

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年8月4日(04.08.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/162486 A1

(51) 国際特許分類:
G09F 9/30 (2006.01) H01L 51/50 (2006.01)
H01L 27/32 (2006.01) H05B 33/14 (2006.01)
H05B 33/12 (2006.01) H05B 33/22 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/IB2022/050284

(22) 国際出願日: 2022年1月14日(14.01.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-011701 2021年1月29日(29.01.2021) JP
特願 2021-015235 2021年2月3日(03.02.2021) JP
特願 2021-040152 2021年3月15日(15.03.2021) JP

(71) 出願人: 株式会社半導体エネルギー研究所
(SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY
CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2430036 神奈川県厚木
市長谷398 Kanagawa (JP).

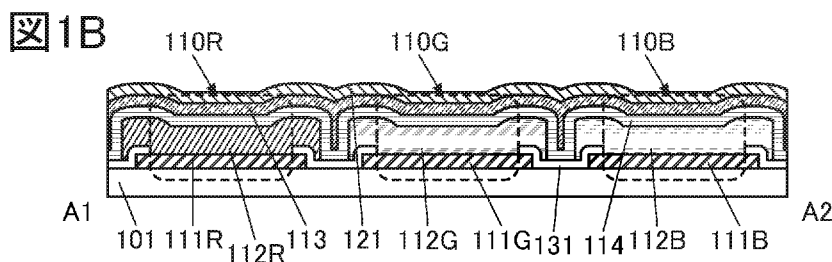
(72) 発明者: 山崎 舜平 (YAMAZAKI, Shunpei);
〒2430036 神奈川県厚木市長谷398株式会社半導
体エネルギー研究所内 Kanagawa (JP). 池田隆

之(IKEDA, Takayuki); 〒2430036 神奈川県厚木
市長谷398株式会社半導体エネルギー研究所内
Kanagawa (JP). 岡崎健一(OKAZAKI, Kenichi);
〒2430036 神奈川県厚木市長谷398株式会
社半導体エネルギー研究所内 Kanagawa (JP).
山根靖正(YAMANE, Yasumasa); 〒2430036 神
奈川県厚木市長谷398株式会社半導体エネ
ルギー研究所内 Kanagawa (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: DISPLAY DEVICE

(54) 発明の名称: 表示装置



(57) Abstract: Provided is a high-definition display device. Provided is the display device having both high display quality and high definition. The display device includes a first light-emission element and a second light-emission element. The first light-emission element includes a first pixel electrode, a first EL layer, and a common electrode. The second light-emission element includes a second pixel electrode, a second EL layer, and the common electrode. An insulation layer including an inorganic insulating material is provided between the first pixel electrode and the second pixel electrode. The insulation layer includes: a first region that overlaps with the first EL layer; a second region that overlaps with the second EL layer; and a third region that is positioned between the first region and the second region. A side surface of the first EL layer and a side surface of the second EL layer face each other and are each positioned on the insulation layer. The common electrode is provided along the side surface of the first EL layer, the side surface of the second EL layer, and the top surface of the insulation layer. The width of the insulation layer is two to four times the distance between the first pixel electrode and the second pixel electrode.

WO 2022/162486 A1

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類 :

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))
- 一 白黒。出願原本にはカラー又はグレースケールの情報が含まれており、PATENTSCOPE からのダウンロードが可能。

(57) 要約 : 高精細な表示装置を提供する。高い表示品位と、高い精細度を兼ね備える表示装置を提供する。表示装置は、第1の発光素子と第2の発光素子とを有する。第1の発光素子は、第1の画素電極、第1のEL層、共通電極を有する。第2の発光素子は、第2の画素電極、第2のEL層、共通電極を有する。第1の画素電極と第2の画素電極との間に無機絶縁材料を有する絶縁層が設けられる。絶縁層は、第1のEL層と重なる第1の領域、第2のEL層と重なる第2の領域、第1の領域と第2の領域の間に位置する第3の領域を有する。第1のEL層の側面と第2のEL層の側面は対向し、それぞれ絶縁層上に位置する。共通電極は、第1のEL層の側面、第2のEL層の側面、及び絶縁層の上面に沿って設けられる。絶縁層の幅は、第1の画素電極と第2の画素電極との間の距離の2倍以上4倍以下である。

明細書

発明の名称

表示装置

技術分野

[0001]

本発明の一態様は、表示装置に関する。本発明の一態様は、表示装置の作製方法に関する。

[0002]

なお、本発明の一態様は、上記の技術分野に限定されない。本明細書等で開示する本発明の一態様の技術分野としては、半導体装置、表示装置、発光装置、蓄電装置、記憶装置、電子機器、照明装置、入力装置、入出力装置、それらの駆動方法、又はそれらの製造方法、を一例として挙げる事ができる。半導体装置は、半導体特性を利用することで機能しうる装置全般を指す。

背景技術

[0003]

近年、ディスプレイパネルの高精細化が求められている。高精細なディスプレイパネルが要求される機器としては、例えばスマートフォン、タブレット端末、ノート型パーソナルコンピュータなどがある。また、テレビジョン装置、モニタ装置などの据え置き型のディスプレイ装置においても、高解像度化に伴い高精細化が求められている。さらに、最も高い精細度が要求される機器としては、例えば、仮想現実（VR：Virtual Reality）、または拡張現実（AR：Augmented Reality）向けの機器がある。

[0004]

また、ディスプレイパネルに適用可能な表示装置としては、代表的には液晶表示装置、有機EL（Electro Luminescence）素子、発光ダイオード（LED：Light Emitting Diode）等の発光素子を備える発光装置、電気泳動方式などにより表示を行う電子ペーパーなどが挙げられる。

[0005]

例えば、有機EL素子の基本的な構成は、一对の電極間に発光性の有機化合物を含む層を、挟持したものである。この素子に電圧を印加することにより、発光性の有機化合物から発光を得ることができる。このような有機EL素子が適用された表示装置は、液晶表示装置等で必要であったバックライトが不要なため、薄型、軽量、高コントラストで且つ低消費電力な表示装置を実現できる。例えば、有機EL素子を用いた表示装置の一例が、特許文献1に記載されている。

[先行技術文献]

[特許文献]

[0006]

[特許文献1] 特開2002-324673号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0007]

本発明の一態様は、高精細化が容易な表示装置、及びその作製方法を提供することを課題の一とする。本発明の一態様は、高い表示品位と、高い精細度を兼ね備える表示装置を提供することを課題の一とする。本発明の一態様は、コントラストの高い表示装置を提供することを課題の一とする。

本発明の一態様は、信頼性の高い表示装置を提供することを課題の一とする。

[0008]

本発明の一態様は、新規な構成を有する表示装置、または表示装置の作製方法を提供することを課題の一とする。本発明の一態様は、上述した表示装置を歩留まりよく製造する方法を提供することを課題の一とする。本発明の一態様は、先行技術の問題点の少なくとも一を少なくとも軽減することを課題の一とする。

[0009]

なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一態様は、これらの課題の全てを解決する必要はないものとする。なお、これら以外の課題は、明細書、図面、請求項などの記載から抽出することが可能である。

課題を解決するための手段

[0010]

本発明の一態様は、第1の発光素子と、第2の発光素子と、を有する表示装置である。第1の発光素子は、第1の画素電極と、第1のEL層と、共通電極と、を有する。第2の発光素子は、第2の画素電極と、第2のEL層と、共通電極と、を有する。第1の画素電極と、第2の画素電極との間に、絶縁層を有する。絶縁層は、第1のEL層と重なる第1の領域と、第2のEL層と重なる第2の領域と、第1の領域と第2の領域の間に位置し、且つ第1のEL層及び第2のEL層のいずれとも重ならない第3の領域と、を有する。第1のEL層の側面と、第2のEL層の側面とは、それぞれ絶縁層上に位置し、且つ、対向して設けられる。共通電極は、第1のEL層の側面、第2のEL層の側面、及び絶縁層の上面に沿って設けられる。絶縁層は、無機絶縁材料を含む。絶縁層の幅は、第1の画素電極と第2の画素電極との間の距離の2倍以上4倍以下である。

[0011]

本発明の他の一態様は、第1の発光素子と、第2の発光素子と、を有する表示装置である。第1の発光素子は、第1の画素電極と、第1のEL層と、共通電極と、を有する。第2の発光素子は、第2の画素電極と、第2のEL層と、共通電極と、を有する。第1の画素電極と、第2の画素電極との間に、絶縁層を有する。絶縁層は、第1のEL層と重なる第1の領域と、第2のEL層と重なる第2の領域と、第1の領域と第2の領域の間に位置し、且つ第1のEL層及び第2のEL層のいずれとも重ならない第3の領域と、を有する。第1のEL層の側面と、第2のEL層の側面とは、それぞれ絶縁層上に位置し、且つ、対向して設けられる。共通電極は、第1のEL層の側面、第2のEL層の側面、及び絶縁層の上面に沿って設けられる。絶縁層は、無機絶縁材料を含む。絶縁層の幅は、第1のEL層の側面と、第2のEL層の側面との距離の2倍以上4倍以下である。

[0012]

また、上記いずれかにおいて、第1の領域の幅が、第3の領域の幅よりも大きく、且つ、300nm以下であり、第2の領域の幅が、第3の領域の幅よりも大きく、且つ、300nm以下であることが好ましい。

[0013]

また、上記いずれかにおいて、第1の領域の幅と第2の領域の幅の和が、第3の領域の幅の2倍よりも大きいことが好ましい。さらに、第1の領域の幅、第2の領域の幅、及び第3の領域の幅の和が、1000nm以下であることが好ましい。

[0014]

また、上記いずれかにおいて、第3の領域の幅が、50nm以上250nm以下であることが好ましい。

[0015]

また、上記いずれかにおいて、表示装置は、有効発光面積比が70%以上100%未満であることが好ましい。

発明の効果

[0016]

本発明の一態様によれば、高精細化が容易な表示装置、及びその作製方法を提供できる。または、高い表示品位と、高い精細度を兼ね備える表示装置を提供できる。または、コントラストの高い表示装置を提供できる。または、信頼性の高い表示装置を提供できる。

[0017]

また、本発明の一態様によれば、新規な構成を有する表示装置、または表示装置の作製方法を提供できる。または、上述した表示装置を歩留まりよく製造する方法を提供できる。本発明の一態様によれば、先行技術の問題点の少なくとも一を少なくとも軽減することができる。

[0018]

なお、これらの効果の記載は、他の効果の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一態様は、必ずしも、これらの効果の全てを有する必要はない。なお、これら以外の効果は、明細書、図面、請求項などの記載から抽出することが可能である。

図面の簡単な説明

[0019]

- 図1A乃至図1Dは、表示装置の構成例を示す図である。
- 図2A及び図2Bは、表示装置の構成例を示す図である。
- 図3A乃至図3Fは、表示装置の作製方法例を示す図である。
- 図4A乃至図4Fは、表示装置の作製方法例を示す図である。
- 図5A乃至図5Cは、表示装置の作製方法例を示す図である。
- 図6A乃至図6Dは、表示装置の構成例を示す図である。
- 図7A乃至図7Dは、表示装置の構成例を示す図である。
- 図8A乃至図8Eは、表示装置の作製方法例を示す図である。
- 図9A乃至図9Cは、表示装置の構成例を示す図である。
- 図10A乃至図10Cは、表示装置の構成例を示す図である。
- 図11A乃至図11Cは、表示装置の構成例を示す図である。
- 図12A及び図12Bは、表示モジュールの一例を示す斜視図である。
- 図13は、表示装置の一例を示す断面図である。
- 図14は、表示装置の一例を示す断面図である。
- 図15は、表示装置の一例を示す断面図である。
- 図16A乃至図16Dは、発光素子の構成例を示す図である。
- 図17A及び図17Bは、表示装置の構成例を示す図である。
- 図18A及び図18Bは、表示装置の構成例を示す図である。
- 図19A及び図19Bは、電子機器の一例を示す図である。
- 図20A乃至図20Dは、電子機器の一例を示す図である。

図 2 1 A 乃至図 2 1 F は、電子機器の一例を示す図である。

図 2 2 A 乃至図 2 2 F は、電子機器の一例を示す図である。

図 2 3 A は、実施例 1 にかかる、画素の光学顕微鏡写真である。図 2 3 B は、実施例 1 にかかる、画素の断面観察写真である。

図 2 4 は、実施例 2 にかかる、画素の断面観察写真である。

図 2 5 A 及び図 2 5 B は、実施例 2 にかかる、表示パネルの表示写真である。

発明を実施するための形態

[0020]

以下、実施の形態について図面を参照しながら説明する。ただし、実施の形態は多くの異なる態様で実施することが可能であり、趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は、以下の実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。

[0021]

なお、以下に説明する発明の構成において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。また、同様の機能を指す場合には、ハッチパターンを同じくし、特に符号を付さない場合がある。

[0022]

なお、本明細書で説明する各図において、各構成要素の大きさ、層の厚さ、または領域は、明瞭化のために誇張されている場合がある。よって、必ずしもそのスケールに限定されない。

[0023]

なお、本明細書等における「第 1」、「第 2」等の序数詞は、構成要素の混同を避けるために付すものであり、数的に限定するものではない。

[0024]

また、本明細書等において、「膜」という用語と、「層」という用語とは、互いに入れ替えることが可能である。例えば、「導電層」または「絶縁層」という用語は、「導電膜」または「絶縁膜」という用語に相互に交換することが可能な場合がある。

[0025]

なお、本明細書において、E L 層とは発光素子の一对の電極間に設けられ、少なくとも発光性の物質を含む層（発光層とも呼ぶ）、または発光層を含む積層体を示すものとする。

[0026]

本明細書等において、表示装置の一態様である表示パネルは表示面に画像等を表示（出力）する機能を有するものである。したがって表示パネルは出力装置の一態様である。

[0027]

また、本明細書等では、表示パネルの基板に、例えば F P C (F l e x i b l e P r i n t e d C i r c u i t) もしくは T C P (T a p e C a r r i e r P a c k a g e) などのコネクタを取り付けられたもの、または基板に C O G (C h i p O n G l a s s) 方式等により I C が実装されたものを、表示パネルモジュール、表示モジュール、または単に表示パネルなどと呼ぶ場合がある。

[0028]

(実施の形態 1)

本実施の形態では、本発明の一態様の表示装置の構成例、及び表示装置の作製方法例について説明する。

[0029]

本発明の一態様は、発光素子（発光デバイスともいう）を有する表示装置である。表示装置は、少なくとも発光色の異なる2つの発光素子を有する。発光素子は、それぞれ一对の電極と、その間にEL層を有する。発光素子は、有機EL素子（有機電界発光素子）であることが好ましい。発光色の異なる2つ以上の発光素子は、それぞれ異なる材料を含むEL層を有する。例えば、それぞれ赤色（R）、緑色（G）、または青色（B）の光を発する3種類の発光素子を有することで、フルカラーの表示装置を実現できる。

[0030]

ここで、発光色の異なる発光素子間で、EL層の一部または全部を作り分ける場合、メタルマスクなどのシャドーマスクを用いた蒸着法により形成することが知られている。しかしながらこの方法では、メタルマスクの精度、メタルマスクと基板との位置ずれ、メタルマスクのたわみ、及び蒸気の散乱などによる成膜される膜の輪郭の広がりなどの様々な影響により、島状の有機膜の形状及び位置に設計からのずれが生じるため、表示装置の高精細化、及び高開口率化が困難である。そのため、ペンタイル配列などの特殊な画素配列方式を適用することなどにより、疑似的に精細度（画素密度ともいう）を高める対策が取られていた。

[0031]

本発明の一態様は、EL層をメタルマスクなどのシャドーマスクを用いることなく、微細なパターンに加工する。これにより、これまで実現が困難であった高い精細度と、大きな開口率を有する表示装置を実現できる。さらに、EL層を作り分けることができるため、極めて鮮やかで、コントラストが高く、表示品位の高い表示装置を実現できる。

[0032]

ここでは簡単のために、2色の発光素子のEL層を作り分ける場合について説明する。まず、2つの画素電極を覆って、第1のEL膜と、第1の犠牲膜とを積層して形成する。続いて、第1の犠牲膜上であって、一方の画素電極（第1の画素電極）と重なる位置にレジストマスクを形成する。続いて、レジストマスクと重ならない第1の犠牲膜の一部、及び第1のEL膜の一部をエッチングする。このとき、他方の画素電極（第2の画素電極）を露出させた時点で、エッチングを終了する。これにより、第1の画素電極上には、帯状または島状に加工された第1のEL膜の一部（第1のEL層ともいう）と、その上に犠牲膜の一部（第1の犠牲層ともいう）を形成することができる。

[0033]

続いて、第2のEL膜と、第2の犠牲膜とを積層して形成する。そして、第2の画素電極と重なる位置にレジストマスクを形成する。続いて、上記と同様にレジストマスクと重ならない第2の犠牲膜の一部、及び第2のEL膜の一部をエッチングする。これにより、第1の画素電極上には第1のEL層及び第1の犠牲層が、第2の画素電極上には第2のEL層及び第2の犠牲層が、それぞれ設けられた状態となる。このようにして、第1のEL層と第2のEL層を作り分けることができる。最後に、第1の犠牲層及び第2の犠牲層を除去し、第1のEL層と第2のEL層を露出させたのち、共通電極を形成することで、二色の発光素子を作り分けることができる。

[0034]

さらに、上記工程を繰り返すことで、三色以上の発光素子のEL層を作り分けることができ、三

色、または四色以上の発光素子を有する表示装置を実現できる。

[0035]

ここで、共通電極に電位を供給するために、画素電極と同一面上に電極（第1の電極、接続電極などともいう）を設け、当該接続電極と共通電極とを電氣的に接続する構成とすることができる。当該接続電極は、画素が設けられる表示部の外側に配置される。ここで、上記第1のEL膜のエッチング時に、接続電極の上面がエッチングに曝されることを防ぐため、接続電極上にも、第1の犠牲層を設けることが好ましい。また、第2のEL膜のエッチング時にも同様に、接続電極上に第2の犠牲層を設けることが好ましい。接続電極上に設けられた第1の犠牲層及び第2の犠牲層は、第1のEL層上の第1の犠牲層、及び第2のEL層上の第2の犠牲層と同時にエッチングにより除去することができる。

[0036]

発光色の異なるEL層の間隔について、例えばメタルマスクを用いた形成方法では10 μ m未満にすることは困難であるが、上記方法によれば、3 μ m以下、2 μ m以下、または、1 μ m以下にまで狭めることができる。例えばLSI向けの露光装置を用いることで、500nm以下、200nm以下、100nm以下、さらには50nm以下にまで間隔を狭めることもできる。これにより、メタルマスクを用いた場合と比較して、2つの発光素子間に存在する非発光領域の面積を大幅に縮小することができ、開口率を100%に近づけることが可能となる。例えば、開口率は、50%以上、60%以上、70%以上、80%以上、さらには90%以上であって、100%未満を実現することもできる。

[0037]

さらに、EL層自体のパターンについても、メタルマスクを用いた場合に比べて極めて小さくすることができる。また、例えばEL層の作り分けにメタルマスクを用いた場合では、パターンの中央と端で厚さのばらつきが生じるため、パターン全体の面積に対して、発光領域として使用できる有効な面積は小さくなる。一方、上記作製方法では、均一な厚さに成膜した膜を加工することでパターンを形成するため、パターン内で厚さを均一にでき、微細なパターンであっても、そのほぼ全域を発光領域として用いることができる。そのため、上記作製方法によれば、高い精細度と高い開口率を兼ね備えることができる。

[0038]

さらに隣接する2つの画素電極の間に、絶縁層を設けることが好ましい。当該絶縁層は、画素電極の端部を覆って設けられる。画素電極上の、当該絶縁層に覆われる領域は、発光素子の発光領域として機能しないため、絶縁層と画素電極とが重なる領域の幅が小さいほど、表示装置の有効発光面積比、すなわち開口率を高めることができる。

[0039]

また、EL層の端部は、上記絶縁層上に位置する。このとき、絶縁層上には、2つのEL層の端部（側面）が対向して配置されることとなる。2つのEL層の距離が狭いほど、絶縁層の幅も小さくできるため、表示装置の開口率を高めることができる。

[0040]

2つの発光素子間に設けられる絶縁層の幅は、2つの画素電極の間の距離よりも大きく、4倍以下、好ましくは3.5倍以下、より好ましくは3倍以下であることが好ましい、特に、絶縁層の幅は、2つの画素電極の間の距離の1.5倍以上、好ましくは2倍以上であることが好ましい。絶縁

層の幅をこのような値とすることで、工程ばらつきが生じたとしても、高い開口率を維持しつつ、確実に絶縁層で画素電極の端部を覆うことができる。

[0041]

また、2つの発光素子間に設けられる絶縁層の幅は、2つのEL層の対向する2つの側面間の距離よりも大きく、4倍以下、好ましくは3.5倍以下、より好ましくは3倍以下であることが好ましい。特に、絶縁層の幅は、2つのEL層の対向する2つの側面間の距離の1.5倍以上、好ましくは2倍以上であることが好ましい。絶縁層の幅をこのような値とすることで、工程ばらつきが生じたとしても、高い開口率を維持しつつ、EL層の端部が確実に絶縁層上に位置するように加工することができる。

[0042]

このように、上記作製方法によれば、微細な発光素子を集積した表示装置を実現することができるため、例えばペンタイル方式などの特殊な画素配列方式を適用し、疑似的に精細度を高める必要が無い場合、R、G、Bをそれぞれ一方向に配列させた、いわゆるストライプ配置で、且つ、500ppi以上、1000ppi以上、または2000ppi以上、さらには3000ppi以上、さらには5000ppi以上の精細度の表示装置を実現することができる。さらに、50%以上、さらには60%以上、さらには70%以上であって、100%未満の有効発光面積比（開口率）の表示装置を実現することができる。

[0043]

なお、本明細書等において、有効発光面積比は、表示装置の画素の繰り返しピッチから算出される1画素の面積に対する、1画素内の発光領域とみなせる領域の面積の割合を指すこととする。

[0044]

以下では、本発明の一態様の表示装置の、より具体的な構成例及び作製方法例について、図面を参照して説明する。

[0045]

[構成例1]

図1Aに、本発明の一態様の表示装置100の上面概略図を示す。表示装置100は、赤色を呈する発光素子110R、緑色を呈する発光素子110G、及び青色を呈する発光素子110Bをそれぞれ複数有する。図1Aでは、各発光素子の区別を簡単にするため、各発光素子の発光領域内にR、G、Bの符号を付している。

[0046]

発光素子110R、発光素子110G、及び発光素子110Bは、それぞれマトリクス状に配列している。図1Aは、一方向に同一の色の発光素子が配列する、いわゆるストライプ配列を示している。なお、発光素子の配列方法はこれに限られず、デルタ配列、ジグザグ配列などの配列方法を適用してもよいし、ペンタイル配列を用いることもできる。

[0047]

発光素子110R、発光素子110G、及び発光素子110Bは、X方向に配列している。また、X方向と交差するY方向には、同じ色の発光素子が配列している。

[0048]

発光素子110R、発光素子110G、及び発光素子110Bとしては、OLED (Organic Light Emitting Diode)、またはQLED (Quantum-dot

Light Emitting Diode) などのEL素子を用いることが好ましい。EL素子が有する発光物質としては、蛍光を発する物質（蛍光材料）、燐光を発する物質（燐光材料）、熱活性化遅延蛍光を示す物質（熱活性化遅延蛍光（Thermally activated delayed fluorescence: TADF）材料）などが挙げられる。EL素子が有する発光物質としては、有機化合物だけでなく、無機化合物（量子ドット材料など）を用いることができる。

[0049]

図1Bは、図1A中の一点鎖線A1-A2に対応する断面概略図であり、図1Cは、一点鎖線B1-B2に対応する断面概略図である。

[0050]

図1Bには、発光素子110R、発光素子110G、及び発光素子110Bの断面を示している。発光素子110Rは、画素電極111R、EL層112R、EL層114、及び共通電極113を有する。発光素子110Gは、画素電極111G、EL層112G、EL層114、及び共通電極113を有する。発光素子110Bは、画素電極111B、EL層112B、EL層114、及び共通電極113を有する。EL層114と共通電極113は、発光素子110R、発光素子110G、及び発光素子110Bに共通に設けられる。EL層114は、共通層ともいうことができる。

[0051]

発光素子110Rが有するEL層112Rは、少なくとも赤色の波長域に強度を有する光を発する発光性の有機化合物を有する。発光素子110Gが有するEL層112Gは、少なくとも緑色の波長域に強度を有する光を発する発光性の有機化合物を有する。発光素子110Bが有するEL層112Bは、少なくとも青色の波長域に強度を有する光を発する発光性の有機化合物を有する。

[0052]

EL層112R、EL層112G、及びEL層112Bは、それぞれ発光性の有機化合物を含む層（発光層）のほかに、電子注入層、電子輸送層、正孔注入層、及び正孔輸送層のうち、一以上を有していてもよい。EL層114は、発光層を有さない構成とすることができる。例えば、EL層114は、電子注入層、電子輸送層、正孔注入層、及び正孔輸送層のうち、一以上を有する。

[0053]

画素電極111R、画素電極111G、及び画素電極111Bは、それぞれ発光素子毎に設けられている。また、共通電極113及びEL層114は、各発光素子に共通な一続きの層として設けられている。各画素電極と共通電極113のいずれか一方に可視光に対して透光性を有する導電膜を用い、他方に反射性を有する導電膜を用いる。各画素電極を透光性、共通電極113を反射性とすることで、下面射出型（ボトムエミッション型）の表示装置とすることができ、反対に各画素電極を反射性、共通電極113を透光性とすることで、上面射出型（トップエミッション型）の表示装置とすることができる。なお、各画素電極と共通電極113の双方を透光性とすることで、両面射出型（デュアルエミッション型）の表示装置とすることもできる。

[0054]

画素電極111R、画素電極111G、及び画素電極111Bの端部を覆って、絶縁層131が設けられている。絶縁層131の端部は、テーパ形状であることが好ましい。なお、絶縁層131は不要であれば設けなくてもよい。なお、本明細書等において、対象物の端部がテーパ形状であるとは、その端部の領域において表面と被形成面との成す角度が0度より大きく90度未満、好

ましくは5度以上70度以下であり、端部から連続的に厚さが増加するような断面形状を有することをいう。

[0055]

絶縁層131は、無機絶縁材料を用いることが好ましい。絶縁層131として無機絶縁材料を用いることで、フォトリソグラフィ法による精度の高い微細加工が可能となるため、有機絶縁材料を用いた場合と比べて隣接画素間の距離を極めて小さくでき、開口率を極めて高いものとすることができる。

[0056]

絶縁層131は、その端部がテーパー形状であることが好ましい。これにより、絶縁層131の端部を覆って設けられるEL層など、絶縁層131の上に形成される膜の段差被覆性を高めることができる。また、絶縁層131は、その厚さが画素電極111R等よりも薄いことが好ましい。絶縁層131を薄く形成することで、絶縁層131上に形成される膜の段差被覆性を高めることができる。

[0057]

絶縁層131に用いることのできる無機絶縁材料としては、例えば、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、または酸化ハフニウムなどの、酸化物または窒化物膜を用いることができる。また、酸化イットリウム、酸化ジルコニウム、酸化ガリウム、酸化タンタル、酸化マグネシウム、酸化ランタン、酸化セリウム、及び酸化ネオジム等を用いてもよい。

[0058]

また、絶縁層131は、上記無機絶縁材料を含む膜を積層してもよい。

[0059]

EL層112R、EL層112G、及びEL層112Bは、それぞれ画素電極の上面に接する領域と、絶縁層131の表面に接する領域と、を有する。また、EL層112R、EL層112G、及びEL層112Bの端部は、絶縁層131上に位置する。

[0060]

図1Bに示すように、発光色の異なる発光素子間において、2つのEL層の間に隙間が設けられている。このように、EL層112R、EL層112G、及びEL層112Bが、互いに接しないように、隙間をあけて設けられていることが好ましい。これにより、発光色の異なる発光素子間で連続するEL層を介して電流が流れ、意図しない発光が生じることを好適に防ぐことができる。そのため、コントラストを高めることができ、表示品位の高い表示装置を実現できる。

[0061]

図1Cに示すように、Y方向において、EL層112Rが一続きとなるように、EL層112Rが帯状に形成されている。EL層112Rなどを帯状に形成することで、これらを分断するためのスペースが不要となり、発光素子間の非発光領域の面積を縮小できるため、開口率を高めることができる。なお、図1Cでは一例として発光素子110Rの断面を示しているが、発光素子110G及び発光素子110Bについても同様の形状とすることができる。

[0062]

共通電極113上には、発光素子110R、発光素子110G、及び発光素子110Bを覆って、保護層121が設けられている。保護層121は、上方から各発光素子に水などの不純物が拡散す

ることを防ぐ機能を有する。

[0063]

保護層121としては、例えば、少なくとも無機絶縁膜を含む単層構造または積層構造とすることができる。無機絶縁膜としては、例えば、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、酸化アルミニウム膜、酸化窒化アルミニウム膜、酸化ハフニウム膜などの酸化物膜または窒化物膜が挙げられる。または、保護層121としてインジウムガリウム酸化物、インジウムガリウム亜鉛酸化物などの半導体材料を用いてもよい。

[0064]

また、保護層121として、無機絶縁膜と、有機絶縁膜の積層膜を用いることもできる。例えば、一对の無機絶縁膜の間に、有機絶縁膜を挟んだ構成とすることが好ましい。さらに有機絶縁膜が平坦化膜として機能することが好ましい。これにより、有機絶縁膜の上面を平坦なものとすることができるため、その上の無機絶縁膜の被覆性が向上し、バリア性を高めることができる。また、保護層121の上面が平坦となるため、保護層121の上方に構造物（例えばカラーフィルタ、タッチセンサの電極、またはレンズアレイなど）を設ける場合に、下方の構造に起因する凹凸形状の影響を軽減できるため好ましい。

[0065]

また、図1Aには、共通電極113と電氣的に接続する接続電極111Cを示している。接続電極111Cには、共通電極113に供給するための電位（例えばアノード電位、またはカソード電位）が与えられる。接続電極111Cは、発光素子110Rなどが配列する表示領域の外に設けられる。また図1Aには、共通電極113を破線で示している。

[0066]

接続電極111Cは、表示領域の外周に沿って設けることができる。例えば、表示領域の外周の一辺に沿って設けられていてもよいし、表示領域の外周の2辺以上にわたって設けられていてもよい。すなわち、表示領域の上面形状が長方形である場合には、接続電極111Cの上面形状は、帯状、L字状、コの字状（角括弧状）、または四角形などとすることができる。

[0067]

図1Dは、図1A中の一点鎖線C1-C2に対応する断面概略図である。図1Dには、接続電極111Cと共通電極113とが電氣的に接続する接続部130を示している。接続部130では、接続電極111C上に共通電極113が接して設けられ、共通電極113を覆って保護層121が設けられている。また、接続電極111Cの端部を覆って絶縁層131が設けられている。

[0068]

続いて、絶縁層131、及びその近傍の好ましい構成について、詳細に説明する。図2Aには、隣接する2つの発光素子間の絶縁層131及びその近傍の拡大図を示している。

[0069]

なお、ここでは任意の隣接する2つの発光素子として、発光素子110Pと発光素子110Qを示している。発光素子110Pと発光素子110Qは、それぞれ独立に、発光素子110R、発光素子110G、及び発光素子110Bのいずれかである。発光素子110PはEL層112P及び画素電極111Pを有し、発光素子110Qは、EL層112Q及び画素電極111Qを有する。

[0070]

図2Aには、絶縁層131の幅 W_D 、画素電極111Pと画素電極111Qとの間の距離 S_G 、E

L層112Pの側面とEL層112Qの側面との距離 S_E をそれぞれ示している。

[0071]

また、絶縁層131は、EL層112Pと重なる領域と、EL層112Qと重なる領域と、これらのいずれとも重ならない領域と、を有する。絶縁層131の、EL層112Pと重なる領域の幅を幅 W_P とし、EL層112Qと重なる領域の幅を W_Q とする。なお、絶縁層131のいずれのEL層とも重ならない領域の幅は、幅 W_D から幅 W_P と幅 W_Q を差し引いた長さであり、距離 S_E と概略一致する。

[0072]

ここで、絶縁層131の幅 W_D は、一对の画素電極間の距離 S_G よりも大きくする。特に、幅 W_D を、距離 S_G の1.2倍以上、好ましくは1.5倍以上、より好ましくは2倍以上であって、8倍以下、好ましくは6倍以下、より好ましくは4倍以下、さらに好ましくは3倍以下とすることが好ましい。代表的には、幅 W_D は、距離 S_G の2倍以上4倍以下とすることが好ましい。幅 W_D を大きくするほど、一对の画素電極と、絶縁層131との位置ずれを許容できるため、作製歩留まりを向上させることができる。一方、幅 W_D が小さいほど、精細度、開口率等を向上させることができる。幅 W_D を上記範囲とすることで、高い作製歩留まりと、高い精細度または開口率を両立させることができる。

[0073]

また、絶縁層131の幅 W_D は、EL層112Pの側面と、EL層112Qの側面との距離 S_E よりも大きくする。特に、幅 W_D を、距離 S_E の1.2倍以上、好ましくは1.5倍以上、より好ましくは2倍以上であって、8倍以下、好ましくは6倍以下、より好ましくは4倍以下、さらに好ましくは3倍以下とすることが好ましい。代表的には、幅 W_D は、距離 S_E の2倍以上4倍以下とすることが好ましい。幅 W_D を大きくするほど、各EL層の端部と、絶縁層131との位置ずれを許容できるため、作製歩留まりを向上させることができる。一方、幅 W_D が小さいほど、精細度、開口率等を向上させることができる。幅 W_D を上記範囲とすることで、高い作製歩留まりと、高い精細度または開口率を両立させることができる。

[0074]

また、絶縁層131は、EL層112Pと重なる領域の幅 W_P が、EL層112P及びEL層112Qのいずれとも重ならない領域の幅（すなわち距離 S_E ）よりも大きいことが好ましい。さらに、EL層112Qと重なる領域の幅 W_Q が、距離 S_E よりも大きいことが好ましい。さらに、幅 W_P 、幅 W_Q は、それぞれ2000nm以下、好ましくは1000nm以下、より好ましくは500nm以下、さらに好ましくは300nm以下、さらに好ましくは200nm以下、さらに好ましくは150nm以下とすることが好ましい。代表的には、幅 W_P 、幅 W_Q は、それぞれ300nm以下とすることが好ましい。

[0075]

また、絶縁層131は、幅 W_P と幅 W_Q の幅の和が、距離 S_E の2倍よりも大きいことが好ましい。さらに、絶縁層131は、幅 W_P 、幅 W_Q 、及び距離 S_E の和、すなわち幅 W_D が、1500nm以下、好ましくは1200nm以下、より好ましくは1000nm以下、さらに好ましくは900nm以下、さらに好ましくは800nm以下、さらに好ましくは600nm以下であることが好ましい。代表的には、幅 W_D は、距離 S_E の2倍以上であって、1000nm以下であることが好ましい。

[0076]

また、EL層112PとEL層112Qとの間の距離 S_E が小さいほど、開口率を高めること、及び、精細度を高めることができる。一方、距離 S_E が大きいほど、EL層112PとEL層112Qの作製工程ばらつきの影響を許容できるため、製造歩留まりを高めることができる。距離 S_E は、20nm以上350nm以下、好ましくは30nm以上300nm以下、より好ましくは40nm以上300nm以下、さらに好ましくは50nm以上250nm以下、さらに好ましくは50nm以上200nm以下、さらに好ましくは50nm以上150nm以下であることが好ましい。代表的には、距離 S_E は50nm以上250nm以下（例えば90nmまたはその近傍）であることが好ましい。

[0077]

隣接する2つの発光素子間において、絶縁層131、EL層112P、EL層112Q、画素電極111P、及び画素電極111Qの関係を上記のようにすることで、開口率の高い表示装置を実現することができる。例えば、開口率（有効発光面積比）を、40%以上、または50%以上、さらには60%以上、さらには65%以上、さらには70%以上にまで高めることができる。

[0078]

図2Aは、EL層112Pの端部が画素電極111Pと重ならず、EL層112Qの端部が画素電極111Qと重ならない場合の例である。また、平面視において、EL層112Pの端部及びEL層112Qの端部は、一对の画素電極の間に位置している。

[0079]

一方、図2Bは、EL層112Pの端部が画素電極111Pと重なり、EL層112Qの端部が画素電極111Qと重なる場合の例を示している。また、平面視において、画素電極111Pの端部及び画素電極111Qの端部は、隣接する2つのEL層の対向する端部の間に位置している。

[0080]

なお、一对のEL層のうち、一方のEL層の端部が画素電極と重なり、他方の端部が重ならない構成としてもよい。また、一方の画素電極の端部がEL層と重なり、他方の端部がEL層と重ならない構成としてもよい。

[0081]

以上が、絶縁層131及びその近傍の構成例についての説明である。

[0082]

[作製方法例1]

以下では、本発明の一態様の表示装置の作製方法の一例について、図面を参照して説明する。ここでは、上記構成例で示した表示装置100を例に挙げて説明する。図3A乃至図4Fは、以下で例示する表示装置の作製方法の、各工程における断面概略図である。また図3A等では、右側に接続部130及びその近傍における断面概略図を合わせて示している。

[0083]

なお、表示装置を構成する薄膜（絶縁膜、半導体膜、導電膜等）は、スパッタリング法、化学気相堆積（CVD: Chemical Vapor Deposition）法、真空蒸着法、パルスレーザー堆積（PLD: Pulsed Laser Deposition）法、原子層堆積（ALD: Atomic Layer Deposition）法等を用いて形成することができる。CVD法としては、プラズマ化学気相堆積（PECVD: Plasma Enhanced CVD）法、または熱CVD法などがある。また、熱CVD法のひとつに、有機金属化学気相堆積

(MOCVD: Metal Organic CVD) 法がある。

[0084]

また、表示装置を構成する薄膜（絶縁膜、半導体膜、導電膜等）は、スピコート、ディップ、スプレー塗布、インクジェット、ディスペンス、スクリーン印刷、オフセット印刷、ドクターナイフ法、スリットコート、ロールコート、カーテンコート、ナイフコート等の方法により形成することができる。

[0085]

また、表示装置を構成する薄膜を加工するには、フォトリソグラフィ法等を用いることができる。それ以外に、ナノインプリント法、サンドブラスト法、リフトオフ法などにより薄膜を加工してもよい。また、メタルマスクなどの遮蔽マスクを用いた成膜方法により、島状の薄膜を直接形成してもよい。

[0086]

フォトリソグラフィ法としては、代表的には以下の2つの方法がある。一つは、加工したい薄膜上にレジストマスクを形成して、エッチング等により当該薄膜を加工し、レジストマスクを除去する方法である。もう一つは、感光性を有する薄膜を成膜した後に、露光、現像を行って、当該薄膜を所望の形状に加工する方法である。

[0087]

フォトリソグラフィ法において、露光に用いる光は、例えばi線（波長365nm）、g線（波長436nm）、h線（波長405nm）、またはこれらを混合させた光を用いることができる。そのほか、紫外線、KrFレーザ光、またはArFレーザ光等を用いることもできる。また、液浸露光技術により露光を行ってもよい。また、露光に用いる光として、極端紫外（EUV: Extreme Ultraviolet）光、X線などを用いてもよい。また、露光に用いる光に換えて、電子ビームを用いることもできる。極端紫外光、X線または電子ビームを用いると、極めて微細な加工が可能となるため好ましい。なお、電子ビームなどのビームを走査することにより露光を行う場合には、フォトマスクは不要である。

[0088]

薄膜のエッチングには、ドライエッチング法、ウェットエッチング法、サンドブラスト法などを用いることができる。

[0089]

[基板101の準備]

基板101としては、少なくとも後の熱処理に耐える程度の耐熱性を有する基板を用いることができる。基板101として、絶縁性基板を用いる場合には、ガラス基板、石英基板、サファイア基板、セラミック基板、有機樹脂基板などを用いることができる。また、シリコン、炭化シリコンなどを材料とした単結晶半導体基板、多結晶半導体基板、シリコンゲルマニウム等の化合物半導体基板、SOI基板などの半導体基板を用いることができる。

[0090]

特に、基板101として、上記半導体基板または絶縁性基板上に、トランジスタなどの半導体素子を含む半導体回路が形成された基板を用いることが好ましい。当該半導体回路は、例えば画素回路、ゲート線駆動回路（ゲートドライバ）、ソース線駆動回路（ソースドライバ）などを構成していることが好ましい。また、上記に加えて演算回路、記憶回路などが構成されていてもよい。

[0091]

〔画素電極111R、111G、111B、接続電極111Cの形成〕

続いて、基板101上に画素電極111R、画素電極111G、画素電極111B、及び接続電極111Cを形成する。まず画素電極となる導電膜を成膜し、フォトリソグラフィ法によりレジストマスクを形成し、導電膜の不要な部分をエッチングにより除去する。その後、レジストマスクを除去することで、画素電極111R、画素電極111G、及び画素電極111Bを形成することができる。

[0092]

各画素電極として可視光に対して反射性を有する導電膜を用いる場合、可視光の波長域全域での反射率ができるだけ高い材料（例えば銀またはアルミニウムなど）を適用することが好ましい。これにより、発光素子の光取り出し効率を高められるだけでなく、色再現性を高めることができる。

[0093]

〔絶縁層131の形成〕

続いて、画素電極111R、画素電極111G、及び画素電極111Bの端部を覆って、絶縁層131を形成する（図3A）。絶縁層131としては、有機絶縁膜または無機絶縁膜を用いることができる。絶縁層131は、後のEL膜の段差被覆性を向上させるために、端部をテーパ形状とすることが好ましい。特に、有機絶縁膜を用いる場合には、感光性の材料を用いると、露光及び現像の条件により端部の形状を制御しやすいため好ましい。

[0094]

〔EL膜112Rfの形成〕

続いて、画素電極111R、画素電極111G、画素電極111B、及び絶縁層131上に、後にEL層112RとなるEL膜112Rfを成膜する。

[0095]

EL膜112Rfは、少なくとも発光性の化合物を含む膜を有する。このほかに、電子注入層、電子輸送層、電荷発生層、正孔輸送層、または正孔注入層として機能する膜のうち、一以上が積層された構成としてもよい。EL膜112Rfは、例えば蒸着法、スパッタリング法、またはインクジェット法等により形成することができる。なおこれに限られず、上述した成膜方法を適宜用いることができる。

[0096]

一例としては、EL膜112Rfとして、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層が、この順で積層された積層膜とすることが好ましい。このとき、後に形成するEL層114としては、電子注入層を有する膜を用いることができる。特に、発光層を覆って電子輸送層を設けることで、後のフォトリソグラフィ工程などにより発光層がダメージを受けることを抑制することができ、信頼性の高い発光素子を作製することができる。さらに、EL膜112Rf等に用いる電子輸送層と、後のEL層114に用いる電子注入層とに、同じ有機化合物を含む層を用いることで、これらの接合を良好なものとし、発光効率が高く、信頼性の高い発光素子を実現できる。例えば、電子輸送層に電子輸送性の有機化合物を用い、電子注入層に、当該有機化合物と金属とを含む材料を用いることができる。

[0097]

EL膜112Rfは、接続電極111C上に設けないように形成することが好ましい。例えば、

EL膜112Rfを蒸着法（またはスパッタリング法）により形成する場合、接続電極111CにEL膜112Rfが成膜されないように、遮蔽マスクを用いて形成することが好ましい。

[0098]

[犠牲膜144aの形成]

続いて、EL膜112Rfを覆って犠牲膜144aを形成する。また、犠牲膜144aは、接続電極111Cの上面に接して設けられる。

[0099]

犠牲膜144aには、EL膜112Rfなどの各EL膜のエッチング処理に対する耐性の高い膜、すなわちエッチングの選択比の大きい膜を用いることができる。また、犠牲膜144aは、後述する保護膜146aなどの保護膜とのエッチングの選択比の大きい膜を用いることができる。さらに、犠牲膜144aは、各EL膜へのダメージの少ないウエットエッチングにより除去可能な膜を用いることができる。

[0100]

犠牲膜144aとしては、例えば、金属膜、合金膜、金属酸化物膜、半導体膜、無機絶縁膜などの無機膜を用いることができる。犠牲膜144aは、スパッタリング法、蒸着法、CVD法、ALD法などの各種成膜方法により形成することができる。特に、ALD法は被形成層に対する成膜ダメージが小さいため、EL膜112Rf上に直接形成する犠牲膜144aは、ALD法を用いて形成することが好ましい。

[0101]

犠牲膜144aとしては、例えば金、銀、白金、マグネシウム、ニッケル、タングステン、クロム、モリブデン、鉄、コバルト、銅、パラジウム、チタン、アルミニウム、イットリウム、ジルコニウム、及びタンタルなどの金属材料、または該金属材料を含む合金材料を用いることができる。特に、アルミニウムまたは銀などの低融点材料を用いることが好ましい。

[0102]

また、犠牲膜144aとしては、インジウムガリウム亜鉛酸化物（In-Ga-Zn酸化物、IGZOとも表記する）などの金属酸化物を用いることができる。さらに、酸化インジウム、インジウム亜鉛酸化物（In-Zn酸化物）、インジウムスズ酸化物（In-Sn酸化物）、インジウムチタン酸化物（In-Ti酸化物）、インジウムスズ亜鉛酸化物（In-Sn-Zn酸化物）、インジウムチタン亜鉛酸化物（In-Ti-Zn酸化物）、インジウムガリウムスズ亜鉛酸化物（In-Ga-Sn-Zn酸化物）などを用いることができる。またはシリコンを含むインジウムスズ酸化物などを用いることもできる。

[0103]

なお、上記ガリウムに代えて元素M（Mは、アルミニウム、シリコン、ホウ素、イットリウム、銅、バナジウム、ベリリウム、チタン、鉄、ニッケル、ゲルマニウム、ジルコニウム、モリブデン、ランタン、セリウム、ネオジム、ハフニウム、タンタル、タングステン、またはマグネシウムから選ばれた一種または複数種）を用いてもよい。特に、Mは、ガリウム、アルミニウム、またはイットリウムから選ばれた一種または複数種とすることが好ましい。

[0104]

また、犠牲膜144aとしては、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化シリコンなどの無機絶縁材料を用いることができる。

[0105]

また、犠牲膜144aとして、少なくともEL膜112Rfの最上部に位置する膜に対して、化学的に安定な溶媒に溶解しうる材料を用いることが好ましい。特に、水またはアルコールに溶解する材料を、犠牲膜144aに好適に用いることができる。犠牲膜144aを成膜する際には、水またはアルコールなどの溶媒に溶解させた状態で、湿式の成膜方法で塗布した後に、溶媒を蒸発させるための加熱処理を行うことが好ましい。このとき、減圧雰囲気下での加熱処理を行うことで、低温且つ短時間で溶媒を除去できるため、EL膜112Rfへの熱的なダメージを低減することができる、好ましい。

[0106]

犠牲膜144aの形成に用いることのできる湿式の成膜方法としては、スピコート、ディップ、スプレー塗布、インクジェット、ディスペンス、スクリーン印刷、オフセット印刷、ドクターナイフ法、スリットコート、ロールコート、カーテンコート、ナイフコート等がある。

[0107]

犠牲膜144aとしては、ポリビニルアルコール（PVA）、ポリビニルブチラール、ポリビニルピロリドン、ポリエチレングリコール、ポリグリセリン、プルラン、水溶性のセルロース、またはアルコール可溶性のポリアミド樹脂などの有機材料を用いることができる。

[0108]

[保護膜146aの形成]

続いて、犠牲膜144a上に、保護膜146aを形成する（図3B）。

[0109]

保護膜146aは、後に犠牲膜144aをエッチングする際のハードマスクとして用いる膜である。また、後の保護膜146aの加工時には、犠牲膜144aが露出する。したがって、犠牲膜144aと保護膜146aとは、互いにエッチングの選択比の大きい膜の組み合わせを選択する。そのため、犠牲膜144aのエッチング条件、及び保護膜146aのエッチング条件に応じて、保護膜146aに用いることのできる膜を選択することができる。

[0110]

例えば、保護膜146aのエッチングに、フッ素を含むガス（フッ素系ガスともいう）を用いたドライエッチングを用いる場合には、シリコン、窒化シリコン、酸化シリコン、タングステン、チタン、モリブデン、タンタル、窒化タンタル、モリブデンとニオブを含む合金、またはモリブデンとタングステンを含む合金などを、保護膜146aに用いることができる。ここで、上記フッ素系ガスを用いたドライエッチングに対して、エッチングの選択比を大きくとれる（すなわち、エッチング速度を遅くできる）膜としては、IGZO、ITOなどの金属酸化物膜などがあり、これを犠牲膜144aに用いることができる。

[0111]

なお、これに限られず、保護膜146aは、様々な材料の中から、犠牲膜144aのエッチング条件、及び保護膜146aのエッチング条件に応じて、選択することができる。例えば、上記犠牲膜144aに用いることのできる膜の中から選択することもできる。

[0112]

また、保護膜146aとしては、例えば窒化物膜を用いることができる。具体的には、窒化シリコン、窒化アルミニウム、窒化ハフニウム、窒化チタン、窒化タンタル、窒化タングステン、窒化

ガリウム、窒化ゲルマニウムなどの窒化物を用いることもできる。

[0113]

または、保護膜146aとして、酸化物膜を用いることができる。代表的には、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化窒化ハフニウムなどの酸化物膜または酸窒化物膜を用いることもできる。

[0114]

例えば、犠牲膜144aとして、ALD法により形成した酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化シリコンなどの無機絶縁材料を用い、保護膜146aとして、スパッタリング法により形成した、インジウムガリウム亜鉛酸化物（In-Ga-Zn酸化物、IGZOとも表記する）などの、インジウムを含む金属酸化物を用いることが好ましい。

[0115]

また、保護膜146aとして、EL膜112Rfなどに用いることのできる有機膜を用いてもよい。例えば、EL膜112Rf、EL膜112Gf、またはEL膜112Bfに用いる有機膜と同じ膜を、保護膜146aに用いることができる。このような有機膜を用いることで、EL膜112Rfなどと成膜装置を共通に用いることができるため、好ましい。

[0116]

[レジストマスク143aの形成]

続いて、保護膜146a上であって、画素電極111Rと重なる位置、及び接続電極111Cと重なる位置に、それぞれレジストマスク143aを形成する（図3C）。

[0117]

レジストマスク143aは、ポジ型のレジスト材料、またはネガ型のレジスト材料など、感光性の樹脂を含むレジスト材料を用いることができる。

[0118]

ここで、保護膜146aを有さずに、犠牲膜144a上にレジストマスク143aを形成する場合、犠牲膜144aにピンホールなどの欠陥が存在すると、レジスト材料の溶媒によって、EL膜112Rfが溶解してしまう恐れがある。保護膜146aを用いることで、このような不具合が生じることを防ぐことができる。

[0119]

なお、犠牲膜144aにピンホールなどの欠陥が生じにくい膜を用いる場合には、保護膜146aを用いずに、犠牲膜144a上に直接、レジストマスク143aを形成してもよい。

[0120]

[保護膜146aのエッチング]

続いて、保護膜146aの、レジストマスク143aに覆われない一部をエッチングにより除去し、帯状の保護層147aを形成する。このとき同時に、接続電極111C上にも保護層147aが形成される。

[0121]

保護膜146aのエッチングの際、犠牲膜144aが当該エッチングにより除去されないように、選択比の高いエッチング条件を用いることが好ましい。保護膜146aのエッチングは、ウェットエッチングまたはドライエッチングにより行うことができるが、ドライエッチングを用いることで、保護膜146aのパターンが縮小することを抑制できる。

[0122]

[レジストマスク143aの除去]

続いて、レジストマスク143aを除去する(図3D)。

[0123]

レジストマスク143aの除去は、ウェットエッチングまたはドライエッチングにより行うことができる。特に、酸素ガスをエッチングガスに用いたドライエッチング(プラズマアッシングともいう)により、レジストマスク143aを除去することが好ましい。

[0124]

このとき、レジストマスク143aの除去は、EL膜112Rfが犠牲膜144aに覆われた状態で行われるため、EL膜112Rfへの影響が抑制されている。特に、EL膜112Rfが酸素に触れると、電気特性に悪影響を及ぼす場合があるため、プラズマアッシングなどの、酸素ガスを用いたエッチングを行う場合には好適である。

[0125]

[犠牲膜144aのエッチング]

続いて、保護層147aをマスクとして用いて、犠牲膜144aの保護層147aに覆われない一部をエッチングにより除去し、帯状の犠牲層145aを形成する(図3E)。このとき同時に、接続電極111C上にも犠牲層145aが形成される。

[0126]

犠牲膜144aのエッチングは、ウェットエッチングまたはドライエッチングにより行うことができるが、ドライエッチングを用いると、パターンの縮小を抑制できるため好ましい。

[0127]

[EL膜112Rf、保護層147aのエッチング]

続いて、保護層147aをエッチングすると同時に、犠牲層145aに覆われないEL膜112Rfの一部をエッチングにより除去し、帯状のEL層112Rを形成する(図3F)。このとき同時に、接続電極111C上の保護層147aも除去される。

[0128]

EL膜112Rfと、保護層147aとを同一処理によりエッチングすることで、工程を簡略化することができ、表示装置の作製コストを削減することができるため好ましい。

[0129]

特にEL膜112Rfのエッチングには、酸素を主成分に含まないエッチングガスを用いたドライエッチングを用いることが好ましい。これにより、EL膜112Rfの変質を抑制し、信頼性の高い表示装置を実現できる。酸素を主成分に含まないエッチングガスとしては、例えばCF₄、C₄F₈、SF₆、CHF₃、Cl₂、H₂O、BCl₃、H₂またはHeなどの貴ガスが挙げられる。また、上記ガスと、酸素を含まない希釈ガスとの混合ガスをエッチングガスに用いることができる。

[0130]

なお、EL膜112Rfのエッチングと、保護層147aのエッチングを、別々に行ってもよい。このとき、EL膜112Rfを先にエッチングしてもよいし、保護層147aを先にエッチングしてもよい。

[0131]

この時点において、EL層112Rと、接続電極111Cが、犠牲層145aに覆われた状態と

なる。

[0132]

[EL膜112Gfの形成]

続いて、犠牲層145a、絶縁層131、画素電極111G、画素電極111B上に、後にEL層112GとなるEL膜112Gfを成膜する。このとき、上記EL膜112Rfと同様に、接続電極111C上にはEL膜112Gfを設けないことが好ましい。

[0133]

EL膜112Gfの形成方法については、上記EL膜112Rfの記載を援用できる。

[0134]

[犠牲膜144bの形成]

続いて、EL膜112Gf上に、犠牲膜144bを形成する。犠牲膜144bは、上記犠牲膜144aと同様の方法で形成することができる。特に、犠牲膜144bは、犠牲膜144aと同一材料を用いることが好ましい。

[0135]

このとき同時に、接続電極111C上において、犠牲層145aを覆って犠牲膜144bが形成される。

[0136]

[保護膜146bの形成]

続いて、犠牲膜144b上に、保護膜146bを形成する。保護膜146bは、上記保護膜146aと同様の方法で形成することができる。特に、保護膜146bは、上記保護膜146aと同一材料を用いることが好ましい。

[0137]

[レジストマスク143bの形成]

続いて、保護膜146b上であって、画素電極111Gと重なる領域、及び接続電極111Cと重なる領域に、レジストマスク143bを形成する（図4A）。

[0138]

レジストマスク143bは、上記レジストマスク143aと同様の方法で形成することができる。

[0139]

[保護膜146bのエッチング]

続いて、保護膜146bの、レジストマスク143bに覆われない一部をエッチングにより除去し、帯状の保護層147bを形成する（図4B）。このとき同時に、接続電極111C上にも保護層147bが形成される。

[0140]

保護膜146bのエッチングについては、上記保護膜146aの記載を援用することができる。

[0141]

[レジストマスク143bの除去]

続いて、レジストマスク143bを除去する。レジストマスク143bの除去は、上記レジストマスク143aの記載を援用することができる。

[0142]

[犠牲膜144bのエッチング]

続いて、保護層147bをマスクとして用いて、犠牲膜144bの保護層147bに覆われない一部をエッチングにより除去し、帯状の犠牲層145bを形成する。このとき同時に、接続電極111C上にも犠牲層145bが形成される。接続電極111C上には、犠牲層145aと犠牲層145bとが積層される。

[0143]

犠牲膜144bのエッチングは、上記犠牲膜144aの記載を援用することができる。

[0144]

[EL膜112Gf、保護層147bのエッチング]

続いて、保護層147bをエッチングすると同時に、犠牲層145bに覆われないEL膜112Gfの一部をエッチングにより除去し、帯状のEL層112Gを形成する(図4C)。このとき同時に、接続電極111C上の保護層147bも除去される。

[0145]

EL膜112Gf及び保護層147bのエッチングは、上記EL膜112Rf及び保護層147aの記載を援用することができる。

[0146]

このとき、EL層112Rは、犠牲層145aに保護されているため、EL膜112Gfのエッチング工程によるダメージを受けることを防ぐことができる。

[0147]

このようにして、帯状のEL層112Rと、帯状のEL層112Gとを、高い位置精度で作分けすることができる。

[0148]

[EL層112Bの形成]

以上の工程を、EL膜112Bf(図示しない)に対して行うことで、島状のEL層112Bと、島状の犠牲層145cとを形成することができる(図4D)。

[0149]

すなわち、EL層112Gの形成後、EL膜112Bf、犠牲膜144c、保護膜146c、及びレジストマスク143c(いずれも図示しない)を順に形成する。続いて、保護膜146cをエッチングして保護層147c(図示しない)を形成した後に、レジストマスク143cを除去する。続いて、犠牲膜144cをエッチングして犠牲層145cを形成する。その後、保護層147cと、EL膜112Bfをエッチングして、帯状のEL層112Bを形成する。

[0150]

また、EL層112Bの形成後、同時に接続電極111C上にも、犠牲層145cが形成される。接続電極111C上には、犠牲層145a、犠牲層145b、及び犠牲層145cが積層される。

[0151]

[犠牲層の除去]

続いて、犠牲層145a、犠牲層145b、及び犠牲層145cを除去し、EL層112R、EL層112G、及びEL層112Bの上面を露出させる(図4E)。このとき同時に、接続電極111Cの上面も露出される。

[0152]

犠牲層145a、犠牲層145b、及び犠牲層145cは、ウェットエッチングまたはドライエ

ッチングにより除去することができる。このとき、EL層112R、EL層112G、及びEL層112Bにできるだけダメージを与えない方法を用いることが好ましい。特に、ウェットエッチングを用いることが好ましい。例えば、水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液（TMAH）、希フッ酸、シュウ酸、リン酸、酢酸、硝酸、またはこれらの混合液体を用いたウェットエッチングを用いることが好ましい。

[0153]

または、犠牲層145a、犠牲層145b、及び犠牲層145cを、水またはアルコールなどの溶媒に溶解させることで除去することが好ましい。ここで、犠牲層145a、犠牲層145b、及び犠牲層145cを溶解しうるアルコールとしては、エチルアルコール、メチルアルコール、イソプロピルアルコール（IPA）、またはグリセリンなど、様々なアルコールを用いることができる。

[0154]

犠牲層145a、犠牲層145b、及び犠牲層145cを除去した後に、EL層112R、EL層112G、及びEL層112Bの内部に含まれる水、及び表面に吸着する水を除去するため、乾燥処理を行うことが好ましい。例えば、不活性ガス雰囲気または減圧雰囲気下における加熱処理を行うことが好ましい。加熱処理は、基板温度として50℃以上200℃以下、好ましくは60℃以上150℃以下、より好ましくは70℃以上120℃以下の温度で行うことができる。減圧雰囲気とすることで、より低温で乾燥が可能であるため好ましい。

[0155]

このようにして、EL層112R、EL層112G、及びEL層112Bを作り分けることができる。

[0156]

[EL層114の形成]

続いて、EL層112R、EL層112G、及びEL層112Bを覆ってEL層114を成膜する。

[0157]

EL層114は、EL膜112Rfなどと同様の方法で成膜することができる。蒸着法によりEL層114を成膜する場合には、EL層114が接続電極111C上に成膜されないように、遮蔽マスクを用いて成膜することが好ましい。

[0158]

[共通電極113の形成]

続いて、EL層114及び接続電極111Cを覆って共通電極113を形成する（図4F）。

[0159]

共通電極113は、蒸着法またはスパッタリング法などの成膜方法により形成することができる。または、蒸着法で形成した膜と、スパッタリング法で形成した膜を積層させてもよい。このとき、EL層114が成膜される領域を包含するように、共通電極113を形成することが好ましい。すなわち、EL層114の端部が、共通電極113と重畳する構成とすることができる。共通電極113は、遮蔽マスクを用いて形成することが好ましい。

[0160]

共通電極113は、表示領域外において、接続電極111Cと電氣的に接続される。

[0161]

〔保護層の形成〕

続いて、共通電極 1 1 3 上に、保護層 1 2 1 を形成する。保護層 1 2 1 に用いる無機絶縁膜の成膜には、スパッタリング法、PECVD法、またはALD法を用いることが好ましい。特にALD法は、段差被覆性に優れ、ピンホールなどの欠陥が生じにくいいため、好ましい。また、有機絶縁膜の成膜には、インクジェット法を用いると、所望のエリアに均一な膜を形成できるため好ましい。

〔0 1 6 2〕

以上により、図 1 B 及び図 1 C に示す表示装置 1 0 0 を作製することができる。

〔0 1 6 3〕

なお、上記では、共通電極 1 1 3 と EL 層 1 1 4 とを、異なる上面形状となるように形成した場合について示したが、これらを同じ領域に、すなわち同じ上面形状となるように形成してもよい。

〔0 1 6 4〕

図 5 A には、上記において、犠牲層を除去した後の断面概略図を示している。例えば、図 5 B に示すように、EL 層 1 1 4 と、共通電極 1 1 3 とを、同一の遮蔽マスクを用いて、または遮蔽マスクを用いることなく形成することもできる。これにより、異なる遮蔽マスクを用いる場合に比べて、製造コストを低減できる。

〔0 1 6 5〕

このとき、図 5 B に示すように、接続部 1 3 0 では、接続電極 1 1 1 C と共通電極 1 1 3 との間に、EL 層 1 1 4 が挟持された構成となる。このとき、EL 層 1 1 4 としては、できるだけ電気抵抗の低い材料を用いることが好ましい。または、できるだけ薄く形成することで、EL 層 1 1 4 の厚さ方向の電気抵抗を低減することが好ましい。例えば、EL 層 1 1 4 として、厚さ 1 nm 以上 5 nm 以下、好ましくは 1 nm 以上 3 nm 以下の電子注入性または正孔注入性の材料を用いることで、接続電極 1 1 1 C と共通電極 1 1 3 との間の電気抵抗を無視できる程度に小さくできる場合がある。

〔0 1 6 6〕

続いて、図 5 C に示すように、保護層 1 2 1 を形成する。このとき、図 5 C に示すように、保護層 1 2 1 を、共通電極 1 1 3 の端部、及び EL 層 1 1 4 の端部を覆って設けることが好ましい。これにより、EL 層 1 1 4、及び EL 層 1 1 4 と共通電極 1 1 3 の界面に、外部から水または酸素などの不純物が拡散することを効果的に防ぐことができる。

〔0 1 6 7〕

ここで、EL 層に用いる有機膜と、無機絶縁膜とは密着性が低い場合があるため、被形成面が無機絶縁膜である箇所では、作製工程中に応力による膜剥がれ（ピーリング）が発生する場合がある。そのため、特に表示部よりも外側の領域などでは、EL 層、及び EL 層上に形成する犠牲層などの応力を緩和しやすい構成とすることが好ましい。

〔0 1 6 8〕

図 6 A には、表示部よりも外側の領域の上面概略図を示し、図 6 B には、図 6 A 中の一点鎖線 P 1-Q 2 における断面概略図を示している。図 6 B では、ダミー層 1 5 1 及び配線 1 5 2 が絶縁層に覆われ、当該絶縁層上に、絶縁層 1 3 1、EL 膜 1 1 2 R f、及び犠牲層 1 4 5 a が積層されている時点の断面を示している。

〔0 1 6 9〕

図 6 A には、ダミー層 1 5 1 と、配線 1 5 2 が設けられている。ダミー層は、平坦化工程などの加工ばらつきを抑制するために設けられる。また、配線 1 5 2 は、電源線（例えばアノード線、ま

たはカソード線など)として機能する配線である。

[0170]

ダミー層151は、島状の上面形状を有している。ダミー層151は、周期的に複数配列されている。これにより、ダミー層151と重なる部分では応力が緩和されるため、当該領域ではピーリングの発生を抑制できる。一方、配線152は、広範囲にわたって面積の大きな領域を有しており、その上部に設けられる膜の応力が緩和されにくいいため、ダミー層151が設けられる領域と比較して、ピーリングが発生しやすい傾向がある。

[0171]

図6Cに、上記とは配線152の形状が異なる上面概略図を示す。また、図6Dは、図6C中の一点鎖線P2-Q2における断面概略図である。

[0172]

図6A、及び図6Bに示すように、配線152に複数のスリット153を設けることで、上部に設けられる膜の応力を緩和しやすい構造とすることができ、ピーリングの発生を抑制することができる。

[0173]

以上が、表示装置の作製方法例についての説明である。

[0174]

[構成例2]

以下では、上記構成例1とは一部の構成が異なる表示装置の構成例について説明する。以下では上記と重複する部分については説明を省略する場合がある。

[0175]

図7A乃至図7Dに示す表示装置100Aは、EL層114及び共通電極113の形状が異なる点で、上記表示装置100と主に相違している。

[0176]

図7Cに示すように、Y方向の断面において、2つの発光素子110Rの間で、EL層112R、EL層114、及び共通電極113が分離されている。言い換えると、EL層112R、EL層114、及び共通電極113は、絶縁層131と重なる部分に端部を有する。

[0177]

また、保護層121は、絶縁層131と重なる領域において、EL層112R、EL層114、及び共通電極113のそれぞれの側面を覆って設けられている。

[0178]

また、図7Cに示すように、絶縁層131の上面の一部には、凹部が形成されていてもよい。このとき、絶縁層131の凹部の表面に沿って、保護層121が接して設けられていることが好ましい。これにより、絶縁層131と保護層121との接触面積が増大し、これらの密着性が向上するため好ましい。

[0179]

図7Aには、共通電極113とEL層114の輪郭を破線で示している。図7Aに示すように、共通電極113とEL層114は、それぞれ長手方向がX方向と平行な帯状の上面形状を有する。一方、図7B及び図7Cに示すように、EL層112Rは島状の形状を有する。

[0180]

なお、ここでは示さないが、発光素子110G及び発光素子110Bに関しても同様の構成とすることができる。

[0181]

[作製方法例2]

以下では、上記表示装置100Aの作製方法例について説明する。なお、以下では上記作製方法例1と重複する部分についてはこれを援用し、説明を省略する。ここで例示する作製方法例は、上記作製方法例1の、共通電極113の形成工程以降の工程が異なる。

[0182]

図8A乃至図8Dには、以下で例示する各工程における断面概略図を示している。ここでは、図7Aにおける一点鎖線B3-B4に対応する断面と、一点鎖線C3-C4に対応する断面とを、並べて示している。

[0183]

上記作製方法例1と同様に、共通電極113の形成まで順に行う(図8A)。

[0184]

続いて、共通電極113上に複数のレジストマスク143dを形成する(図8B)。レジストマスク143dは、X方向に延在する帯状の上面形状を有するように形成する。レジストマスク143dは、画素電極111Rと重畳する。また、レジストマスク143dは、絶縁層131上に端部が設けられている。

[0185]

続いて、共通電極113、EL層114、EL層112R、EL層112G(図示しない)、及びEL層112B(図示しない)の、レジストマスク143dに覆われていない部分をエッチングにより除去する(図8C)。これにより、それまで全ての画素電極を覆って一続きに設けられていた共通電極113とEL層114は、上記エッチングによりスリットが形成されることによって分断され、複数の帯状の共通電極113と、EL層114が形成される。

[0186]

エッチングはドライエッチングにより行うことが好ましい。例えば、エッチングガスを切り替えることによって、大気に曝すことなく連続して、共通電極113、EL層114、及びEL層112Rなどを順にエッチングすることが好ましい。さらに、酸素を主成分として含有しないガスを、エッチングガスに用いることが好ましい。

[0187]

共通電極113、EL層114、及びEL層112Rなどのエッチングの際に、絶縁層131の一部がエッチングされ、図8Cに示すように、絶縁層131の上部に凹部が形成されてもよい。または、絶縁層131のレジストマスク143dに覆われない部分がエッチングされ、2つに分断される場合もある。

[0188]

続いて、レジストマスク143dを除去する。レジストマスク143dの除去は、ウェットエッチングまたはドライエッチングにより行うことができる。

[0189]

続いて、保護層121を形成する(図8D)。保護層121は、共通電極113の側面、EL層114の側面、EL層112Rの側面を覆って設けられる。また、保護層121は、絶縁層131

の上面に接して設けられることが好ましい。

[0190]

また、図8Eに示すように、保護層121の形成時に、絶縁層131の上方に、空隙（隙間、空間などともいう）122が形成される場合がある。空隙122は、減圧状態であってもよいし、大気圧であってもよい。また、空気、窒素、貴ガスなどのガス、または、保護層121の成膜に用いる成膜ガスなどを含んでいてもよい。

[0191]

以上が、表示装置100Aの作製方法例についての説明である。

[0192]

なお、ここでは共通電極113上に、レジストマスク143dを直接形成したが、共通電極113上に、ハードマスクとして機能する膜を設けてもよい。このとき、レジストマスク143dをマスクとして、ハードマスクを形成し、レジストマスクを除去した後に、ハードマスクをマスクとして、共通電極113、EL層114、及びEL層112Rなどをエッチングすることができる。なお、このときハードマスクは除去してもよいし、残存させてもよい。

[0193]

[変形例]

以下では、上記とは一部の構成が異なる例について説明する。なお以下では、上記と重複する部分についてはこれを援用し、説明を省略する。

[0194]

[変形例1]

図9A及び図9Bに、表示装置100Bの断面概略図を示す。表示装置100Bの上面図は、図1Aと同様である。図9Aは、X方向の断面に相当し、図9Bは、Y方向の断面に相当する。

[0195]

表示装置100Bは、共通層であるEL層114を有していない点で、上記表示装置100と主に相違している。

[0196]

共通電極113は、EL層112R、EL層112G、及びEL層112Bの上面に接して設けられている。EL層114を設けないことにより、発光素子110R、発光素子110G、及び発光素子110Bを、それぞれ全く異なる積層構造とすることが可能となり、材料の選択肢が増えるため、設計の自由度を高めることができる。

[0197]

図9Cに示す表示装置100Cは、上記表示装置100Aと同様に、共通電極113の、絶縁層131と重なる領域に、X方向に延在するスリットを形成した場合の例である。表示装置100Cにおいて、保護層121は、共通電極113の側面、EL層112Rの側面、及び絶縁層131の上面に接して設けられている。

[0198]

[変形例2]

図10A、図10Bに示す表示装置100Dは、発光素子の構成が異なる点で、上記表示装置100と主に相違している。

[0199]

発光素子110Rは、画素電極111RとEL層112Rとの間に、光学調整層115Rを有する。発光素子110Gは、画素電極111GとEL層112Gとの間に、光学調整層115Gを有する。発光素子110Bは、画素電極111BとEL層112Bとの間に、光学調整層115Bを有する。

[0200]

さらに、光学調整層115R、光学調整層115G、及び光学調整層115Bは、それぞれ可視光に対して透光性を有する。光学調整層115R、光学調整層115G、及び光学調整層115Bは、それぞれ厚さが異なる。これにより、発光素子毎に光路長を異ならせることができる。

[0201]

ここで、画素電極111R、画素電極111G、及び画素電極111Bに、可視光に対して反射性を有する導電膜を用い、共通電極113に、可視光に対して反射性及び透光性を有する導電膜を用いる。これにより、各発光素子は、いわゆるマイクロキャビティ構造（微小共振器構造）が実現され、特定の波長の光が強められる。これにより、色純度が高められた表示装置を実現することができる。

[0202]

各光学調整層としては、可視光に対して透光性を有する、導電性材料を用いることができる。例えば、酸化インジウム、インジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化亜鉛、ガリウムを含む酸化亜鉛、シリコンを含むインジウム錫酸化物、シリコンを含むインジウム亜鉛酸化物などの導電性酸化物を用いることができる。

[0203]

各光学調整層は、画素電極111R、画素電極111G、及び画素電極111Bを形成した後であって、EL膜112Rf等を形成する前に、形成することができる。各光学調整層は、それぞれ厚さの異なる導電膜を用いてもよいし、薄いものから順に、単層構造、2層構造、3層構造などとしてもよい。

[0204]

また、図10Cに示す表示装置100Eは、上記表示装置100Aに、光学調整層を適用した場合の例である。図10Cでは、Y方向に並べて配置された2つの発光素子110Gの断面を示している。

[0205]

[変形例3]

図11A及び図11Bに示す表示装置100Fは、光学調整層を有さない点で、上記表示装置100Dと主に相違している。

[0206]

表示装置100Fは、EL層112R、EL層112G、及びEL層112Bの厚さにより、マイクロキャビティ構造を実現した例である。このような構成とすることで、光学調整層を別途設ける必要が無いため、工程を簡略化できる。

[0207]

例えば表示装置100Cでは、最も波長の長い光を発する発光素子110RのEL層112Rが最も厚く、最も波長の短い光を発する発光素子110BのEL層112Bが最も薄い。なお、これに限られず、各発光素子が発する光の波長、発光素子を構成する層の光学特性、及び発光素子の電

気特性などを考慮して、各EL層の厚さを調整することができる。

[0208]

また、図11Cに示す表示装置100Gは、上記表示装置100AのEL層の厚さを異ならせて、マイクロキャビティ構造を実現した例である。図11Cでは、Y方向に並べて配置された2つの発光素子110Gの断面を示している。

[0209]

以上が変形例についての説明である。

[0210]

なお、上記変形例2及び変形例3では、EL層114を用いる例を示したが、EL層114を設けない構成としてもよい。

[0211]

本実施の形態で例示した構成例、及びそれらに対応する図面等は、少なくともその一部を他の構成例、または図面等と適宜組み合わせることができる。

[0212]

本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することができる。

[0213]

(実施の形態2)

本実施の形態では、上記とは異なる表示装置の構成例について説明する。

[0214]

本実施の形態の表示装置は、高精細な表示装置とすることができる。したがって、本実施の形態の表示装置は、例えば、腕時計型、ブレスレット型などの情報端末機（ウェアラブル機器）、並びに、ヘッドマウントディスプレイなどのVR向け機器、メガネ型のAR向け機器など、頭部に装着可能なウェアラブル機器の表示部に用いることができる。

[0215]

[表示モジュール]

図12Aに、表示モジュール280の斜視図を示す。表示モジュール280は、表示装置400Cと、FPC290と、を有する。なお、表示モジュール280が有する表示装置は表示装置400Cに限られず、後述する表示装置400Dまたは表示装置400Eであってもよい。

[0216]

表示モジュール280は、基板291及び基板292を有する。表示モジュール280は、表示部281を有する。表示部281は、表示モジュール280における画像を表示する領域であり、後述する画素部284に設けられる各画素からの光を視認できる領域である。

[0217]

図12Bに、基板291側の構成を模式的に示した斜視図を示している。基板291上には、回路部282と、回路部282上の画素回路部283と、画素回路部283上の画素部284と、が積層されている。また、基板291上の画素部284と重ならない部分に、FPC290と接続するための端子部285が設けられている。端子部285と回路部282とは、複数の配線により構成される配線部286により電氣的に接続されている。

[0218]

画素部284は、周期的に配列した複数の画素284aを有する。図12Bの右側に、1つの画素284aの拡大図を示している。画素284aは、発光色が互いに異なる発光素子430a、430b、430cを有する。複数の発光素子は、図12Bに示すようにストライプ配列で配置してもよい。ストライプ配列は、高密度に画素回路を配列することが出来るため、高精細な表示装置を提供できる。また、デルタ配列、ペントイル配列など様々な配列方法を適用することができる。

[0219]

画素回路部283は、周期的に配列した複数の画素回路283aを有する。

[0220]

1つの画素回路283aは、1つの画素284aが有する3つの発光素子の発光を制御する回路である。1つの画素回路283aは、1つの発光素子の発光を制御する回路が3つ設けられる構成としてもよい。例えば、画素回路283aは、1つの発光素子につき、1つの選択トランジスタと、1つの電流制御用トランジスタ（駆動トランジスタ）と、容量素子と、を少なくとも有する構成とすることができる。このとき、選択トランジスタのゲートにはゲート信号が、ソースまたはドレインの一方にはソース信号が、それぞれ入力される。これにより、アクティブマトリクス型の表示装置が実現されている。

[0221]

回路部282は、画素回路部283の各画素回路283aを駆動する回路を有する。例えば、ゲート線駆動回路、及び、ソース線駆動回路の一方または双方を有することが好ましい。このほか、演算回路、メモリ回路、及び電源回路等の少なくとも一つを有していてもよい。

[0222]

FPC290は、外部から回路部282にビデオ信号または電源電位等を供給するための配線として機能する。また、FPC290上にICが実装されていてもよい。

[0223]

表示モジュール280は、画素部284の下側に画素回路部283及び回路部282の一方または双方が積層された構成とすることができるため、表示部281の開口率（有効表示面積比）を極めて高くすることができる。例えば表示部281の開口率は、40%以上100%未満、好ましくは50%以上95%以下、より好ましくは60%以上95%以下とすることができる。また、画素284aを極めて高密度に配置することが可能で、表示部281の精細度を極めて高くすることができる。例えば、表示部281には、2000ppi以上、好ましくは3000ppi以上、より好ましくは5000ppi以上、さらに好ましくは6000ppi以上であって、2000ppi以下、または3000ppi以下の精細度で、画素284aが配置されることが好ましい。

[0224]

このような表示モジュール280は、極めて高精細であることから、ヘッドマウントディスプレイなどのVR向け機器、またはメガネ型のAR向け機器に好適に用いることができる。例えば、レンズを通して表示モジュール280の表示部を視認する構成の場合であっても、表示モジュール280は極めて高精細な表示部281を有するためにレンズで表示部を拡大しても画素が視認されず、没入感の高い表示を行うことができる。また、表示モジュール280はこれに限られず、比較的小型の表示部を有する電子機器に好適に用いることができる。例えば腕時計などの装着型の電子機器の表示部に好適に用いることができる。

[0225]

[表示装置400C]

図13に示す表示装置400Cは、基板301、発光素子430a、430b、430c、容量240、及び、トランジスタ310を有する。

[0226]

基板301は、図12A及び図12Bにおける基板291に相当する。基板301から絶縁層255までの積層構造401が、実施の形態1における基板101に相当する。

[0227]

トランジスタ310は、基板301にチャンネル形成領域を有するトランジスタである。基板301としては、例えば単結晶シリコン基板などの半導体基板を用いることができる。トランジスタ310は、基板301の一部、導電層311、低抵抗領域312、絶縁層313、及び、絶縁層314を有する。導電層311は、ゲート電極として機能する。絶縁層313は、基板301と導電層311の間に位置し、ゲート絶縁層として機能する。低抵抗領域312は、基板301に不純物がドーピングされた領域であり、ソースまたはドレインの一方として機能する。絶縁層314は、導電層311の側面を覆って設けられ、絶縁層として機能する。

[0228]

また、基板301に埋め込まれるように、隣接する2つのトランジスタ310の間に素子分離層315が設けられている。

[0229]

また、トランジスタ310を覆って絶縁層261が設けられ、絶縁層261上に容量240が設けられている。

[0230]

容量240は、導電層241と、導電層245と、これらの間に位置する絶縁層243を有する。導電層241は容量240の一方の電極として機能し、導電層245は容量240の他方の電極として機能し、絶縁層243は容量240の誘電体として機能する。

[0231]

導電層241は絶縁層261上に設けられ、絶縁層254に埋め込まれている。導電層241は、絶縁層261に埋め込まれたプラグ271によってトランジスタ310のソースまたはドレインの一方と電氣的に接続されている。絶縁層243は導電層241を覆って設けられる。導電層245は、絶縁層243を介して導電層241と重なる領域に設けられている。

[0232]

容量240を覆って、絶縁層255が設けられ、絶縁層255上に発光素子430a、430b、430c等が設けられている。発光素子430a、430b、430c上には保護層416が設けられており、保護層416の上面には、樹脂層419によって基板420が貼り合わされている。基板420は、図12Aにおける基板292に相当する。

[0233]

発光素子の画素電極は、絶縁層255に埋め込まれたプラグ256、絶縁層254に埋め込まれた導電層241、及び、絶縁層261に埋め込まれたプラグ271によってトランジスタ310のソースまたはドレインの一方と電氣的に接続されている。

[0234]

[表示装置400D]

図14に示す表示装置400Dは、トランジスタの構成が異なる点で、表示装置400Cと主に相違する。なお、表示装置400Cと同様の部分については説明を省略することがある。

[0235]

トランジスタ320は、チャンネルが形成される半導体層に、金属酸化物（酸化物半導体ともいう）が適用されたトランジスタである。

[0236]

トランジスタ320は、半導体層321、絶縁層323、導電層324、一对の導電層325、絶縁層326、及び、導電層327を有する。

[0237]

基板331は、図12A及び図12Bにおける基板291に相当する。基板331から絶縁層255までの積層構造401が、実施の形態1における基板101に相当する。基板331としては、絶縁性基板または半導体基板を用いることができる。

[0238]

基板331上に、絶縁層332が設けられている。絶縁層332は、基板331から水または水素などの不純物がトランジスタ320に拡散すること、及び半導体層321から絶縁層332側に酸素が脱離することを防ぐバリア層として機能する。絶縁層332としては、例えば酸化アルミニウム膜、酸化ハフニウム膜、窒化シリコン膜などの、酸化シリコン膜よりも水素または酸素が拡散しにくい膜を用いることができる。

[0239]

絶縁層332上に導電層327が設けられ、導電層327を覆って絶縁層326が設けられている。導電層327は、トランジスタ320の第1のゲート電極として機能し、絶縁層326の一部は、第1のゲート絶縁層として機能する。絶縁層326の少なくとも半導体層321と接する部分には、酸化シリコン膜等の酸化物絶縁膜を用いることが好ましい。絶縁層326の上面は、平坦化されていることが好ましい。

[0240]

半導体層321は、絶縁層326上に設けられる。半導体層321は、半導体特性を有する金属酸化物（酸化物半導体ともいう）膜を有することが好ましい。半導体層321に好適に用いることのできる材料の詳細については後述する。

[0241]

一对の導電層325は、半導体層321上に接して設けられ、ソース電極及びドレイン電極として機能する。

[0242]

また、一对の導電層325の上面及び側面、並びに半導体層321の側面等を覆って絶縁層328が設けられ、絶縁層328上に絶縁層264が設けられている。絶縁層328は、半導体層321に絶縁層264等から水または水素などの不純物が拡散すること、及び半導体層321から酸素が脱離することを防ぐバリア層として機能する。絶縁層328としては、上記絶縁層332と同様の絶縁膜を用いることができる。

[0243]

絶縁層328及び絶縁層264に、半導体層321に達する開口が設けられている。当該開口の内部において、絶縁層264、絶縁層328、及び導電層325の側面、並びに半導体層321の

上面に接する絶縁層 3 2 3 と、導電層 3 2 4 とが埋め込まれている。導電層 3 2 4 は、第 2 のゲート電極として機能し、絶縁層 3 2 3 は第 2 のゲート絶縁層として機能する。

[0 2 4 4]

導電層 3 2 4 の上面、絶縁層 3 2 3 の上面、及び絶縁層 2 6 4 の上面は、それぞれ高さが概略一致するように平坦化处理され、これらを覆って絶縁層 3 2 9 及び絶縁層 2 6 5 が設けられている。

[0 2 4 5]

絶縁層 2 6 4 及び絶縁層 2 6 5 は、層間絶縁層として機能する。絶縁層 3 2 9 は、トランジスタ 3 2 0 に絶縁層 2 6 5 等から水または水素などの不純物が拡散することを防ぐバリア層として機能する。絶縁層 3 2 9 としては、上記絶縁層 3 2 8 及び絶縁層 3 3 2 と同様の絶縁膜を用いることができる。

[0 2 4 6]

一对の導電層 3 2 5 の一方と電氣的に接続するプラグ 2 7 4 は、絶縁層 2 6 5、絶縁層 3 2 9、及び絶縁層 2 6 4 に埋め込まれるように設けられている。ここで、プラグ 2 7 4 は、絶縁層 2 6 5、絶縁層 3 2 9、絶縁層 2 6 4、及び絶縁層 3 2 8 のそれぞれの開口の側面、及び導電層 3 2 5 の上面の一部を覆う導電層 2 7 4 a と、導電層 2 7 4 a の上面に接する導電層 2 7 4 b とを有することが好ましい。このとき、導電層 2 7 4 a として、水素及び酸素が拡散しにくい導電材料を用いることが好ましい。

[0 2 4 7]

表示装置 4 0 0 D における、絶縁層 2 5 4 から基板 4 2 0 までの構成は、表示装置 4 0 0 C と同様である。

[0 2 4 8]

[表示装置 4 0 0 E]

図 1 5 に示す表示装置 4 0 0 E は、基板 3 0 1 にチャンネルが形成されるトランジスタ 3 1 0 と、チャンネルが形成される半導体層に金属酸化物を含むトランジスタ 3 2 0 とが積層された構成を有する。なお、表示装置 4 0 0 C、4 0 0 D と同様の部分については説明を省略することがある。

[0 2 4 9]

トランジスタ 3 1 0 を覆って絶縁層 2 6 1 が設けられ、絶縁層 2 6 1 上に導電層 2 5 1 が設けられている。また導電層 2 5 1 を覆って絶縁層 2 6 2 が設けられ、絶縁層 2 6 2 上に導電層 2 5 2 が設けられている。導電層 2 5 1 及び導電層 2 5 2 は、それぞれ配線として機能する。また、導電層 2 5 2 を覆って絶縁層 2 6 3 及び絶縁層 3 3 2 が設けられ、絶縁層 3 3 2 上にトランジスタ 3 2 0 が設けられている。また、トランジスタ 3 2 0 を覆って絶縁層 2 6 5 が設けられ、絶縁層 2 6 5 上に容量 2 4 0 が設けられている。容量 2 4 0 とトランジスタ 3 2 0 とは、プラグ 2 7 4 により電氣的に接続されている。

[0 2 5 0]

トランジスタ 3 2 0 は、画素回路を構成するトランジスタとして用いることができる。また、トランジスタ 3 1 0 は、画素回路を構成するトランジスタ、または当該画素回路を駆動するための駆動回路（ゲート線駆動回路、ソース線駆動回路）を構成するトランジスタとして用いることができる。また、トランジスタ 3 1 0 及びトランジスタ 3 2 0 は、演算回路または記憶回路などの各種回路を構成するトランジスタとして用いることができる。

[0 2 5 1]

このような構成とすることで、発光素子の直下に画素回路だけでなく駆動回路等を形成することができるため、表示領域の周辺に駆動回路を設ける場合に比べて、表示装置を小型化することが可能となる。

[0252]

本実施の形態で例示した構成例、及びそれらに対応する図面等は、少なくともその一部を他の構成例、または図面等と適宜組み合わせることができる。

[0253]

本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせる実施することができる。

[0254]

(実施の形態3)

本実施の形態では、本発明の一態様である表示装置に用いることができる発光素子（発光デバイスともいう）について説明する。

[0255]

本明細書等において、メタルマスク、またはFMM（ファインメタルマスク、高精細なメタルマスク）を用いて作製されるデバイスをMM（メタルマスク）構造のデバイスと呼称する場合がある。また、本明細書等において、メタルマスク、またはFMMを用いることなく作製されるデバイスをMML（メタルマスクレス）構造のデバイスと呼称する場合がある。

[0256]

なお、本明細書等において、各色の発光デバイス（ここでは青（B）、緑（G）、及び赤（R））で、発光層を作り分ける、または発光層を塗り分ける構造をSBS（Side By Side）構造と呼ぶ場合がある。また、本明細書等において、白色光を発することのできる発光デバイスを白色発光デバイスと呼ぶ場合がある。なお、白色発光デバイスは、着色層（たとえば、カラーフィルタ）と組み合わせることで、フルカラー表示の表示装置とすることができる。

[0257]

また、発光デバイスは、シングル構造と、タンデム構造とに大別することができる。シングル構造のデバイスは、一対の電極間に1つの発光ユニットを有し、当該発光ユニットは、1以上の発光層を含む構成とすることが好ましい。白色発光を得るには、2以上の発光層の各々の発光が補色の関係となるような発光層を選択すればよい。例えば、第1の発光層の発光色と第2の発光層の発光色を補色の関係になるようにすることで、発光デバイス全体として白色発光する構成を得ることができる。また、発光層を3つ以上有する発光デバイスの場合も同様である。

[0258]

タンデム構造のデバイスは、一対の電極間に2以上の複数の発光ユニットを有し、各発光ユニットは、1以上の発光層を含む構成とすることが好ましい。白色発光を得るには、複数の発光ユニットの発光層からの光を合わせて白色発光が得られる構成とすればよい。なお、白色発光が得られる構成については、シングル構造の構成と同様である。なお、タンデム構造のデバイスにおいて、複数の発光ユニットの間には、電荷発生層などの中間層を設けると好適である。

[0259]

また、上述の白色発光デバイス（シングル構造またはタンデム構造）と、SBS構造の発光デバイスと、を比較した場合、SBS構造の発光デバイスは、白色発光デバイスよりも消費電力を低く

することができる。消費電力を低く抑えたい場合は、SBS構造の発光デバイスを用いると好適である。一方で、白色発光デバイスは、製造プロセスがSBS構造の発光デバイスよりも簡単であるため、製造コストを低くすることができる、又は製造歩留まりを高くすることができるため、好適である。

[0260]

<発光素子の構成例>

図16Aに示すように、発光素子は、一对の電極（下部電極21、上部電極25）の間に、EL層23を有する。EL層23は、層4420、発光層4411、層4430などの複数の層で構成することができる。層4420は、例えば電子注入性の高い物質を含む層（電子注入層）および電子輸送性の高い物質を含む層（電子輸送層）などを有することができる。発光層4411は、例えば発光性の化合物を有する。層4430は、例えば正孔注入性の高い物質を含む層（正孔注入層）および正孔輸送性の高い物質を含む層（正孔輸送層）を有することができる。

[0261]

一对の電極間に設けられた層4420、発光層4411および層4430を有する構成は単一の発光ユニットとして機能することができ、本明細書では図16Aの構成をシングル構造と呼ぶ。

[0262]

また、図16Bは、図16Aに示す発光素子20が有するEL層23の変形例である。具体的には、図16Bに示す発光素子20は、下部電極21上の層4430-1と、層4430-1上の層4430-2と、層4430-2上の発光層4411と、発光層4411上の層4420-1と、層4420-1上の層4420-2と、層4420-2上の上部電極25と、を有する。例えば、下部電極21を陽極とし、上部電極25を陰極とした場合、層4430-1が正孔注入層として機能し、層4430-2が正孔輸送層として機能し、層4420-1が電子輸送層として機能し、層4420-2が電子注入層として機能する。または、下部電極21を陰極とし、上部電極25を陽極とした場合、層4430-1が電子注入層として機能し、層4430-2が電子輸送層として機能し、層4420-1が正孔輸送層として機能し、層4420-2が正孔注入層として機能する。このような層構造とすることで、発光層4411に効率よくキャリアを注入し、発光層4411内におけるキャリアの再結合の効率を高めることが可能となる。

[0263]

なお、図16Cに示すように層4420と層4430との間に複数の発光層（発光層4411、4412、4413）が設けられる構成もシングル構造のバリエーションである。

[0264]

また、図16Dに示すように、複数の発光ユニット（EL層23a、23b）が中間層（電荷発生層）4440を介して直列に接続された構成を本明細書ではタンデム構造と呼ぶ。なお、本明細書等においては、図16Dに示すような構成をタンデム構造として呼称するが、これに限定されず、例えば、タンデム構造をスタック構造と呼んでもよい。なお、タンデム構造とすることで、高輝度発光が可能な発光素子とすることができる。

[0265]

なお、図16C、及び図16Dにおいても、図16Bに示すように、層4420と、層4430とは、2層以上の層からなる積層構造としてもよい。

[0266]

発光素子の発光色は、EL層23を構成する材料によって、赤、緑、青、シアン、マゼンタ、黄または白などとすることができる。また、発光素子にマイクロキャビティ構造を付与することにより色純度をさらに高めることができる。

[0267]

白色の光を発する発光素子は、発光層に2種類以上の発光物質を含む構成とすることが好ましい。白色発光を得るには、2以上の発光物質の各々の発光が補色の関係となるような発光物質を選択すればよい。例えば、第1の発光層の発光色と第2の発光層の発光色を補色の関係になるようにすることで、発光素子全体として白色発光する発光素子を得ることができる。また、発光層を3つ以上有する発光素子の場合も同様である。

[0268]

発光層には、R（赤）、G（緑）、B（青）、Y（黄）、O（橙）等の発光を示す発光物質を2以上含むことが好ましい。または、発光物質を2以上有し、それぞれの発光物質の発光は、R、G、Bのうち2以上の色のスペクトル成分を含むことが好ましい。

[0269]

ここで、発光素子の具体的な構成例について説明する。

[0270]

発光素子は少なくとも発光層を有する。また、発光素子は、発光層以外の層として、正孔注入性の高い物質、正孔輸送性の高い物質、正孔ブロック材料、電子輸送性の高い物質、電子ブロック材料、電子注入性の高い物質、またはバイポーラ性の物質（電子輸送性及び正孔輸送性が高い物質）等を含む層をさらに有していてもよい。

[0271]

発光デバイスには低分子系化合物及び高分子系化合物のいずれを用いることもでき、無機化合物を含んでいてもよい。発光デバイスを構成する層は、それぞれ、蒸着法（真空蒸着法を含む）、転写法、印刷法、インクジェット法、塗布法等の方法で形成することができる。

[0272]

例えば、発光デバイスは、発光層の他に正孔注入層、正孔輸送層、正孔ブロック層、電子ブロック層、電子輸送層、及び電子注入層のうち1層以上を有する構成とすることができる。

[0273]

正孔注入層は、陽極から正孔輸送層に正孔を注入する層であり、正孔注入性の高い材料を含む層である。正孔注入性の高い材料としては、芳香族アミン化合物、及び、正孔輸送性材料とアクセプター性材料（電子受容性材料）とを含む複合材料などが挙げられる。

[0274]

正孔輸送層は、正孔注入層によって、陽極から注入された正孔を発光層に輸送する層である。正孔輸送層は、正孔輸送性材料を含む層である。正孔輸送性材料としては、 $1 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 以上の正孔移動度を有する物質が好ましい。なお、電子よりも正孔の輸送性の高い物質であれば、これら以外のものも用いることができる。正孔輸送性材料としては、 π 電子過剰型複素芳香族化合物（例えばカルバゾール誘導体、チオフェン誘導体、フラン誘導体など）、芳香族アミン（芳香族アミン骨格を有する化合物）等の正孔輸送性の高い材料が好ましい。

[0275]

電子輸送層は、電子注入層によって、陰極から注入された電子を発光層に輸送する層である。電

子輸送層は、電子輸送性材料を含む層である。電子輸送性材料としては、 $1 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 以上の電子移動度を有する物質が好ましい。なお、正孔よりも電子の輸送性の高い物質であれば、これら以外のものも用いることができる。電子輸送性材料としては、キノリン骨格を有する金属錯体、ベンゾキノリン骨格を有する金属錯体、オキサゾール骨格を有する金属錯体、チアゾール骨格を有する金属錯体等の他、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、オキサゾール誘導体、チアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体、キノリン配位子を有するキノリン誘導体、ベンゾキノリン誘導体、キノキサリン誘導体、ジベンゾキノキサリン誘導体、ピリジン誘導体、ビピリジン誘導体、ピリミジン誘導体、その他含窒素複素芳香族化合物を含む π 電子不足型複素芳香族化合物等の電子輸送性の高い材料を用いることができる。

[0276]

電子注入層は、陰極から電子輸送層に電子を注入する層であり、電子注入性の高い材料を含む層である。電子注入性の高い材料としては、アルカリ金属、アルカリ土類金属、またはそれらの化合物を用いることができる。電子注入性の高い材料としては、電子輸送性材料とドナー性材料（電子供与性材料）とを含む複合材料を用いることもできる。

[0277]

電子注入層としては、例えば、リチウム、セシウム、フッ化リチウム (LiF)、フッ化セシウム (CsF)、フッ化カルシウム (CaF₂)、8-(キノリノラト)リチウム (略称: Liq)、2-(2-ピリジル)フェノラトリチウム (略称: LiPP)、2-(2-ピリジル)-3-ピリジノラトリチウム (略称: LiPPy)、4-フェニル-2-(2-ピリジル)フェノラトリチウム (略称: LiPPP)、リチウム酸化物 (LiO_x)、炭酸セシウム等のようなアルカリ金属、アルカリ土類金属、またはこれらの化合物を用いることができる。

[0278]

または、上述の電子注入層としては、電子輸送性を有する材料を用いてもよい。例えば、非共有電子対を備え、電子不足型複素芳香環を有する化合物を、電子輸送性を有する材料に用いることができる。具体的には、ピリジン環、ジアジン環（ピリミジン環、ピラジン環、ピリダジン環）、トリアジン環の少なくとも一つを有する化合物を用いることができる。

[0279]

なお、非共有電子対を備える有機化合物の最低空軌道 (LUMO: Lowest Unoccupied Molecular Orbital) が、 -3.6 eV 以上 -2.3 eV 以下であると好ましい。また、一般にCV (サイクリックボルタンメトリ)、光電子分光法、光吸収分光法、逆光電子分光法等により、有機化合物の最高被占有軌道 (HOMO: Highest Occupied Molecular Orbital) 準位及びLUMO準位を見積もることができる。

[0280]

例えば、4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン (略称: BPhen)、2,9-ビス(ナフタレン-2-イル)-4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン (略称: NBPhen)、ジキノキサリノ [2,3-a:2',3'-c] フェナジン (略称: HATNA)、2,4,6-トリリス [3'-(ピリジン-3-イル)ビフェニル-3-イル]-1,3,5-トリアジン (略称: TmPPPyTz) 等を、非共有電子対を備える有機化合物に用いることができる。なお、NBPhenはBPhenと比較して、高いガラス転移温度 (T_g) を備え、耐熱性に優れる。

[0281]

発光層は、発光物質を含む層である。発光層は、1種または複数種の発光物質を有することができる。発光物質としては、青色、紫色、青紫色、緑色、黄緑色、黄色、橙色、赤色などの発光色を呈する物質を適宜用いる。また、発光物質として、近赤外光を発する物質を用いることもできる。

[0282]

発光物質としては、蛍光材料、燐光材料、TADF材料、量子ドット材料などが挙げられる。

[0283]

蛍光材料としては、例えば、ピレン誘導体、アントラセン誘導体、トリフェニレン誘導体、フルオレン誘導体、カルバゾール誘導体、ジベンゾチオフェン誘導体、ジベンゾフラン誘導体、ジベンゾキノキサリン誘導体、キノキサリン誘導体、ピリジン誘導体、ピリミジン誘導体、フェナントレン誘導体、ナフタレン誘導体などが挙げられる。

[0284]

燐光材料としては、例えば、4H-トリアゾール骨格、1H-トリアゾール骨格、イミダゾール骨格、ピリミジン骨格、ピラジン骨格、またはピリジン骨格を有する有機金属錯体（特にイリジウム錯体）、電子吸引基を有するフェニルピリジン誘導体を配位子とする有機金属錯体（特にイリジウム錯体）、白金錯体、希土類金属錯体等が挙げられる。

[0285]

発光層は、発光物質（ゲスト材料）に加えて、1種または複数種の有機化合物（ホスト材料、アシスト材料等）を有していてもよい。1種または複数種の有機化合物としては、正孔輸送性材料及び電子輸送性材料の一方または双方を用いることができる。また、1種または複数種の有機化合物として、バイポーラ性材料、またはTADF材料を用いてもよい。

[0286]

発光層は、例えば、燐光材料と、励起錯体を形成しやすい組み合わせである正孔輸送性材料及び電子輸送性材料と、を有することが好ましい。このような構成とすることにより、励起錯体から発光物質（燐光材料）へのエネルギー移動であるExTET（Exciplex-Triplet Energy Transfer）を用いた発光を効率よく得ることができる。発光物質の最も低エネルギー側の吸収帯の波長と重なるような発光を呈する励起錯体を形成するような組み合わせを選択することで、エネルギー移動がスムーズとなり、効率よく発光を得ることができる。この構成により、発光デバイスの高効率、低電圧駆動、長寿命を同時に実現できる。

[0287]

本実施の形態で例示した構成例、及びそれらに対応する図面等は、少なくともその一部を他の構成例、または図面等と適宜組み合わせることができる。

[0288]

本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせで実施することができる。

[0289]

(実施の形態4)

本実施の形態では、高精細な表示装置について説明する。

[0290]

[画素回路の構成例]

以下では、高精細な表示装置に適した画素、及びその配列方法の例について説明する。

[0291]

図17Aに、画素ユニット70の回路図の例を示す。画素ユニット70は、2つの画素（画素70a及び画素70b）で構成される。また画素ユニット70には、配線51a、配線51b、配線52a、配線52b、配線52c、配線52d、配線53a、配線53b、配線53c等が接続されている。

[0292]

画素70aは、副画素71a、副画素72a、及び副画素73aを有する。画素70bは、副画素71b、副画素72b、及び副画素73bを有する。副画素71a、副画素72a、及び副画素73aは、それぞれ画素回路41a、画素回路42a、及び画素回路43aを有する。また副画素71b、副画素72b、及び副画素73bは、それぞれ画素回路41b、画素回路42b、及び画素回路43bを有する。

[0293]

各々の副画素は、画素回路と表示素子60を有する。例えば副画素71aは、画素回路41aと表示素子60を有する。ここでは、表示素子60として、有機EL素子等の発光素子を用いた場合を示す。

[0294]

配線51a及び配線51bは、それぞれゲート線としての機能を有する。配線52a、配線52b、配線52c、及び配線52dは、それぞれ信号線（データ線ともいう）としての機能を有する。また配線53a、配線53b、及び配線53cは、表示素子60に電位を供給する機能を有する。

[0295]

画素回路41aは、配線51a、配線52a、及び配線53aと電氣的に接続されている。画素回路42aは、配線51b、配線52d、及び配線53aと電氣的に接続されている。画素回路43aは、配線51a、配線52b、及び配線53bと電氣的に接続されている。画素回路41bは、配線51b、配線52a、及び配線53bと電氣的に接続されている。画素回路42bは、配線51a、配線52c、及び配線53cと電氣的に接続されている。画素回路43bは、配線51b、配線52b、及び配線53cと電氣的に接続されている。

[0296]

図17Aに示すように、1つの画素に2本のゲート線が接続される構成とすることで、反対にソース線の本数を、ストライプ配置と比べて半分にすることができる。これにより、ソース駆動回路として用いるICの端子数を半分に減らすことが可能となり、部品点数を削減することができる。

[0297]

また、信号線として機能する1本の配線には、同じ色に対応した画素回路を接続する構成とすることが好ましい。例えば、画素間の輝度のばらつきを補正するために電位が調整された信号を当該配線に供給する場合、補正值は色ごとに大きく異なる場合がある。そのため、1本の信号線に接続される画素回路を、全て同じ色に対応した画素回路とすることで、補正を容易にすることができる。

[0298]

また各々の画素回路は、トランジスタ61と、トランジスタ62と、容量素子63と、を有している。例えば画素回路41aにおいて、トランジスタ61は、ゲートが配線51aと電氣的に接続し、ソース又はドレインの一方が配線52aと電氣的に接続し、ソース又はドレインの他方がトランジスタ62のゲート、及び容量素子63の一方の電極と電氣的に接続している。トランジスタ6

2は、ソース又はドレインの一方が表示素子60の一方の電極と電氣的に接続し、ソース又はドレインの他方が容量素子63の他方の電極、及び配線53aと電氣的に接続している。表示素子60の他方の電極は、電位V1が与えられる配線と電氣的に接続している。

[0299]

なお、他の画素回路については、図17Aに示すようにトランジスタ61のゲートが接続する配線、トランジスタ61のソース又はドレインの一方が接続する配線、及び容量素子63の他方の電極が接続する配線の少なくとも一つが異なる以外は、画素回路41aと同様の構成を有する。

[0300]

図17Aにおいて、トランジスタ61は選択トランジスタとしての機能を有する。またトランジスタ62は、表示素子60と直列接続され、表示素子60に流れる電流を制御する機能を有する。容量素子63は、トランジスタ62のゲートが接続されるノードの電位を保持する機能を有する。なお、トランジスタ61のオフ状態におけるリーク電流、またはトランジスタ62のゲートを介したリーク電流等が極めて小さい場合には、容量素子63を意図的に設けなくてもよい。

[0301]

ここで、図17Aに示すように、トランジスタ62はそれぞれ電氣的に接続された第1のゲートと第2のゲートを有する構成とすることが好ましい。このように2つのゲートを有する構成とすることで、トランジスタ62の流すことのできる電流を増大させることができる。特に高精細の表示装置においては、トランジスタ62のサイズ、特にチャンネル幅を大きくすることなく当該電流を増大させることができるため好ましい。

[0302]

なお、トランジスタ62が1つのゲートを有する構成としてもよい。このような構成とすることで、第2のゲートを形成する工程が不要となるため、上記に比べて工程を簡略化できる。また、トランジスタ61が2つのゲートを有する構成としてもよい。このような構成とすることで、いずれのトランジスタもサイズを小さくすることができる。また、各トランジスタの第1のゲートと第2のゲートがそれぞれ電氣的に接続する構成とすることができる。または、一方のゲートが他方のゲートではなく、他の配線と電氣的に接続する構成としてもよい。その場合、2つのゲートに与える電位を異ならせることにより、トランジスタのしきい値電圧を制御することができる。

[0303]

また、表示素子60の一对の電極のうち、トランジスタ62と電氣的に接続する電極が、画素電極に相当する。ここで、図17Aでは、表示素子60のトランジスタ62と電氣的に接続する電極を陰極、反対側の電極を陽極とした構成を示している。このような構成は、トランジスタ62がnチャンネル型のトランジスタの場合に特に有効である。すなわち、トランジスタ62がオン状態のとき、配線53aにより与えられる電位がソース電位となるため、表示素子60の抵抗のばらつき及び変動によらず、トランジスタ62に流れる電流を一定とすることができる。また、画素回路が有するトランジスタとして、pチャンネル型のトランジスタを用いてもよい。また、表示素子60の陰極と陽極を逆にしてもよい。

[0304]

[画素電極の配置方法例]

図17Bは、表示領域における各画素電極と、各配線の配置方法の例を示す上面概略図である。配線51aと配線51bとは交互に配列している。また配線51a及び配線51bと交差する配線

5 2 a、配線 5 2 b、及び配線 5 2 c が、この順で配列している。また、各画素電極は、配線 5 1 a 及び配線 5 1 b の延伸方向に沿ってマトリクス状に配列している。

[0305]

画素ユニット 7 0 は、画素 7 0 a と画素 7 0 b を含んで構成されている。画素 7 0 a は、画素電極 9 1 R 1、画素電極 9 1 G 1、及び画素電極 9 1 B 1 を有する。画素 7 0 b は、画素電極 9 1 R 2、画素電極 9 1 G 2、及び画素電極 9 1 B 2 を有する。また 1 つの副画素の表示領域は、その副画素が有する画素電極の内側に位置する。

[0306]

図 1 7 B に示すように、画素ユニット 7 0 の配線 5 2 a 等の延伸方向（第 1 の方向ともいう）に配列する周期を周期 P としたとき、配線 5 1 a 等の延伸方向（第 2 の方向ともいう）に配列する周期は、その 2 倍（周期 2 P）であることが好ましい。これにより、歪みのない表示を行うことができる。ここで、周期 P は、 $1\ \mu\text{m}$ 以上 $150\ \mu\text{m}$ 以下、好ましくは $2\ \mu\text{m}$ 以上 $120\ \mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $3\ \mu\text{m}$ 以上 $100\ \mu\text{m}$ 以下、さらに好ましくは、 $4\ \mu\text{m}$ 以上 $60\ \mu\text{m}$ 以下とすることができる。これにより、極めて高精細な表示装置を実現できる。

[0307]

例えば画素電極 9 1 R 1 等は信号線として機能する配線 5 2 a 等と重ならないように設けられていることが好ましい。これにより、配線 5 2 a 等と画素電極 9 1 R 1 等との間の容量を介して電気的ノイズが伝わり、画素電極 9 1 R 1 等の電位が変動することで、表示素子の輝度が変化してしまうことを抑制できる。

[0308]

また、画素電極 9 1 R 1 等は走査線として機能する配線 5 1 a 等と重なって設けられていてもよい。これにより、画素電極 9 1 R 1 の面積を大きくすることができるため、開口率を高めることができる。図 1 7 B では、画素電極 9 1 R 1 の一部が配線 5 1 a と重なるように配置されている例を示している。

[0309]

ある副画素の画素電極 9 1 R 1 等と、走査線として機能する配線 5 1 a 等を重ねて配置する場合、その副画素の画素回路と接続する配線であることが好ましい。例えば、配線 5 1 a 等の電位が変化する信号が入力される期間は、当該副画素のデータを書き換える期間に相当するため、配線 5 1 a 等から画素電極に容量を介して電気的ノイズが伝わったとしても、副画素の輝度が変化することがない。

[0310]

[画素レイアウトの例 1]

以下では、画素ユニット 7 0 のレイアウトの一例について説明する。

[0311]

図 1 8 A には、1 つの副画素のレイアウトの例を示している。ここでは見やすくするため、画素電極を形成する前の状態における例を示している。図 1 8 A に示す副画素は、トランジスタ 6 1、トランジスタ 6 2、及び容量素子 6 3 を有する。トランジスタ 6 2 は、半導体層を挟む 2 つのゲートをもつトランジスタである。

[0312]

最も下側に位置する導電膜により、配線 5 1 とトランジスタ 6 2 の一方のゲートなどが形成され

ている。これよりも後に形成される導電膜により、トランジスタ61のゲート及びトランジスタ62のもう一方のゲートなどが形成されている。これよりも後に形成される導電膜により、配線52、各トランジスタのソース電極及びドレイン電極、並びに容量素子63の一方の電極などが形成されている。これよりも後に形成される導電膜により、配線53等が形成されている。配線53の一部は、容量素子63のもう一方の電極として機能する。

[0313]

図18Bには、図18Aで例示した副画素を用いた画素ユニット70のレイアウトの一例を示している。図18Bには、各画素電極（画素電極31a、画素電極31b、画素電極32a、画素電極32b、画素電極33a、画素電極33b）と、表示領域22も明示している。

[0314]

ここでは、配線51aと電氣的に接続する3つの副画素と、配線51bと電氣的に接続する3つの副画素は、それぞれ左右対称となっている例を示している。これにより、配線52a等の延伸方向に向かって同じ色の副画素をジグザグに配列し、且つ、これら副画素が信号線として機能する一つの配線に接続する構成としたとき、副画素内の配線の長さなどを揃えることができるため、副画素間の輝度のばらつきを抑制することができる。

[0315]

このような画素レイアウトを用いることにより、極めて高精細な表示装置を作製することが可能となる。

[0316]

本実施の形態で例示した構成例、及びそれらに対応する図面等は、少なくともその一部を他の構成例、または図面等と適宜組み合わせることができる。

[0317]

本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせる実施することができる。

[0318]

(実施の形態5)

本実施の形態では、上記の実施の形態で説明したOSトランジスタに用いることができる金属酸化物（酸化物半導体ともいう）について説明する。

[0319]

金属酸化物は、少なくともインジウムまたは亜鉛を含むことが好ましい。特にインジウム及び亜鉛を含むことが好ましい。また、それらに加えて、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、スズなどが含まれていることが好ましい。また、ホウ素、シリコン、チタン、鉄、ニッケル、ゲルマニウム、ジルコニウム、モリブデン、ランタン、セリウム、ネオジム、ハフニウム、タンタル、タンダステン、マグネシウム、コバルトなどから選ばれた一種、または複数種が含まれていてもよい。

[0320]

また、金属酸化物は、スパッタリング法、有機金属化学気相成長（MOCVD: Metal Organic Chemical Vapor Deposition）法などの化学気相成長（CVD: Chemical Vapor Deposition）法、または、原子層堆積（ALD: Atomic Layer Deposition）法などにより形成することができる。

[0321]

<結晶構造の分類>

酸化物半導体の結晶構造としては、アモルファス (completely amorphous を含む)、CAAC (c-axis-aligned crystalline)、nc (nanocrystalline)、CAC (cloud-aligned composite)、単結晶 (single crystal)、及び多結晶 (poly crystal) 等が挙げられる。

[0322]

なお、膜または基板の結晶構造は、X線回折 (XRD: X-Ray Diffraction) スペクトルを用いて評価することができる。例えば、GIXD (Grazing-Incidence XRD) 測定で得られるXRDスペクトルを用いて評価することができる。なお、GIXD法は、薄膜法またはSeemann-Bohlin法ともいう。

[0323]

例えば、石英ガラス基板では、XRDスペクトルのピークの形状がほぼ左右対称である。一方で、結晶構造を有するIGZO膜では、XRDスペクトルのピークの形状が左右非対称である。XRDスペクトルのピークの形状が左右非対称であることは、膜中または基板中の結晶の存在を明示している。別言すると、XRDスペクトルのピークの形状で左右対称でないと、膜または基板は非晶質状態であるとは言えない。

[0324]

また、膜または基板の結晶構造は、極微電子線回折法 (NBED: Nano Beam Electron Diffraction) によって観察される回折パターン (極微電子線回折パターンともいう) にて評価することができる。例えば、石英ガラス基板の回折パターンでは、ハローが観察され、石英ガラスは、非晶質状態であることが確認できる。また、室温成膜したIGZO膜の回折パターンでは、ハローではなく、スポット状のパターンが観察される。このため、室温成膜したIGZO膜は、結晶状態でもなく、非晶質状態でもない、中間状態であり、非晶質状態であると結論することはできないと推定される。

[0325]

<<酸化物半導体の構造>>

なお、酸化物半導体は、構造に着目した場合、上記とは異なる分類となる場合がある。例えば、酸化物半導体は、単結晶酸化物半導体と、それ以外の非単結晶酸化物半導体と、に分けられる。非単結晶酸化物半導体としては、例えば、上述のCAAC-OS、及びnc-OSがある。また、非単結晶酸化物半導体には、多結晶酸化物半導体、擬似非晶質酸化物半導体 (a-like OS: amorphous-like oxide semiconductor)、非晶質酸化物半導体、などが含まれる。

[0326]

ここで、上述のCAAC-OS、nc-OS、及びa-like OSの詳細について、説明を行う。

[0327]

[CAAC-OS]

CAAC-OSは、複数の結晶領域を有し、当該複数の結晶領域はc軸が特定の方向に配向している酸化物半導体である。なお、特定の方向とは、CAAC-OS膜の厚さ方向、CAAC-OS

膜の被形成面の法線方向、またはCAAC-OS膜の表面の法線方向である。また、結晶領域とは、原子配列に周期性を有する領域である。なお、原子配列を格子配列とみなすと、結晶領域とは、格子配列の揃った領域でもある。さらに、CAAC-OSは、a-b面方向において複数の結晶領域が連結する領域を有し、当該領域は歪みを有する場合がある。なお、歪みとは、複数の結晶領域が連結する領域において、格子配列の揃った領域と、別の格子配列の揃った領域と、の間で格子配列の向きが変化している箇所を指す。つまり、CAAC-OSは、c軸配向し、a-b面方向には明らかな配向をしていない酸化物半導体である。

[0328]

なお、上記複数の結晶領域のそれぞれは、1つまたは複数の微小な結晶（最大径が10nm未満である結晶）で構成される。結晶領域が1つの微小な結晶で構成されている場合、当該結晶領域の最大径は10nm未満となる。また、結晶領域が多数の微小な結晶で構成されている場合、当該結晶領域の大きさは、数十nm程度となる場合がある。

[0329]

また、In-M-Zn酸化物（元素Mは、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、スズ、チタンなどから選ばれた一種、または複数種）において、CAAC-OSは、インジウム（In）、及び酸素を有する層（以下、In層）と、元素M、亜鉛（Zn）、及び酸素を有する層（以下、（M, Zn）層）とが積層した、層状の結晶構造（層状構造ともいう）を有する傾向がある。なお、インジウムと元素Mは、互いに置換可能である。よって、（M, Zn）層にはインジウムが含まれる場合がある。また、In層には元素Mが含まれる場合がある。なお、In層にはZnが含まれる場合もある。当該層状構造は、例えば、高分解能TEM（Transmission Electron Microscope）像において、格子像として観察される。

[0330]

CAAC-OS膜に対し、例えば、XRD装置を用いて構造解析を行うと、 $\theta/2\theta$ スキャンを用いたOut-of-plane XRD測定では、c軸配向を示すピークが $2\theta = 31^\circ$ またはその近傍に検出される。なお、c軸配向を示すピークの位置（ 2θ の値）は、CAAC-OSを構成する金属元素の種類、組成などにより変動する場合がある。

[0331]

また、例えば、CAAC-OS膜の電子線回折パターンにおいて、複数の輝点（スポット）が観測される。なお、あるスポットと別のスポットとは、試料を透過した入射電子線のスポット（ダイレクトスポットともいう）を対称中心として、点対称の位置に観測される。

[0332]

上記特定の方向から結晶領域を観察した場合、当該結晶領域内の格子配列は、六方格子を基本とするが、単位格子は正六角形とは限らず、非正六角形である場合がある。また、上記歪みにおいて、五角形、七角形などの格子配列を有する場合がある。なお、CAAC-OSにおいて、歪み近傍においても、明確な結晶粒界（グレインバウンダリー）を確認することはできない。即ち、格子配列の歪みによって、結晶粒界の形成が抑制されていることがわかる。これは、CAAC-OSが、a-b面方向において酸素原子の配列が稠密でないこと、金属原子が置換することで原子間の結合距離が変化すること、などによって、歪みを許容することができるためと考えられる。

[0333]

なお、明確な結晶粒界が確認される結晶構造は、いわゆる多結晶（polycrystal）と

呼ばれる。結晶粒界は、再結合中心となり、キャリアが捕獲されトランジスタのオン電流の低下、電界効果移動度の低下などを引き起こす可能性が高い。よって、明確な結晶粒界が確認されないCAAC-OSは、トランジスタの半導体層に好適な結晶構造を有する結晶性の酸化物の一つである。なお、CAAC-OSを構成するには、Znを有する構成が好ましい。例えば、In-Zn酸化物、及びIn-Ga-Zn酸化物は、In酸化物よりも結晶粒界の発生を抑制できるため好適である。

[0334]

CAAC-OSは、結晶性が高く、明確な結晶粒界が確認されない酸化物半導体である。よって、CAAC-OSは、結晶粒界に起因する電子移動度の低下が起こりにくいといえる。また、酸化物半導体の結晶性は不純物の混入、欠陥の生成などによって低下する場合があるため、CAAC-OSは不純物及び欠陥（酸素欠損など）の少ない酸化物半導体ともいえる。従って、CAAC-OSを有する酸化物半導体は、物理的性質が安定する。そのため、CAAC-OSを有する酸化物半導体は熱に強く、信頼性が高い。また、CAAC-OSは、製造工程における高い温度（所謂サーマルバジェット）に対しても安定である。従って、OSトランジスタにCAAC-OSを用いると、製造工程の自由度を広げることが可能となる。

[0335]

[nc-OS]

nc-OSは、微小な領域（例えば、1nm以上10nm以下の領域、特に1nm以上3nm以下の領域）において原子配列に周期性を有する。別言すると、nc-OSは、微小な結晶を有する。なお、当該微小な結晶の大きさは、例えば、1nm以上10nm以下、特に1nm以上3nm以下であることから、当該微小な結晶をナノ結晶ともいう。また、nc-OSは、異なるナノ結晶間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、膜全体で配向性が見られない。従って、nc-OSは、分析方法によっては、a-like OS、または非晶質酸化物半導体と区別が付かない場合がある。例えば、nc-OS膜に対し、XRD装置を用いて構造解析を行うと、 $\theta/2\theta$ スキャンを用いたOut-of-plane XRD測定では、結晶性を示すピークが検出されない。また、nc-OS膜に対し、ナノ結晶よりも大きいプローブ径（例えば50nm以上）の電子線を用いる電子線回折（制限視野電子線回折ともいう。）を行うと、ハローパターンのような回折パターンが観測される。一方、nc-OS膜に対し、ナノ結晶の大きさと近いナノ結晶より小さいプローブ径（例えば1nm以上30nm以下）の電子線を用いる電子線回折（ナノビーム電子線回折ともいう。）を行うと、ダイレクトスポットを中心とするリング状の領域内に複数のスポットが観測される電子線回折パターンが取得される場合がある。

[0336]

[a-like OS]

a-like OSは、nc-OSと非晶質酸化物半導体との間の構造を有する酸化物半導体である。a-like OSは、鬆または低密度領域を有する。即ち、a-like OSは、nc-OS及びCAAC-OSと比べて、結晶性が低い。また、a-like OSは、nc-OS及びCAAC-OSと比べて、膜中の水素濃度が高い。

[0337]

<<酸化物半導体の構成>>

次に、上述のCAC-OSの詳細について、説明を行う。なお、CAC-OSは材料構成に関する。

[0338]

[CAC-OS]

CAC-OSとは、例えば、金属酸化物を構成する元素が、0.5nm以上10nm以下、好ましくは、1nm以上3nm以下、またはその近傍のサイズで偏在した材料の一構成である。なお、以下では、金属酸化物において、一つまたは複数の金属元素が偏在し、該金属元素を有する領域が、0.5nm以上10nm以下、好ましくは、1nm以上3nm以下、またはその近傍のサイズで混合した状態をモザイク状、またはパッチ状ともいう。

[0339]

さらに、CAC-OSとは、第1の領域と、第2の領域と、に材料が分離することでモザイク状となり、当該第1の領域が、膜中に分布した構成（以下、クラウド状ともいう。）である。つまり、CAC-OSは、当該第1の領域と、当該第2の領域とが、混合している構成を有する複合金属酸化物である。

[0340]

ここで、In-Ga-Zn酸化物におけるCAC-OSを構成する金属元素に対するIn、Ga、及びZnの原子数比のそれぞれを、[In]、[Ga]、及び[Zn]と表記する。例えば、In-Ga-Zn酸化物におけるCAC-OSにおいて、第1の領域は、[In]が、CAC-OS膜の組成における[In]よりも大きい領域である。また、第2の領域は、[Ga]が、CAC-OS膜の組成における[Ga]よりも大きい領域である。または、例えば、第1の領域は、[In]が、第2の領域における[In]よりも大きく、且つ、[Ga]が、第2の領域における[Ga]よりも小さい領域である。また、第2の領域は、[Ga]が、第1の領域における[Ga]よりも大きく、且つ、[In]が、第1の領域における[In]よりも小さい領域である。

[0341]

具体的には、上記第1の領域は、インジウム酸化物、インジウム亜鉛酸化物などが主成分である領域である。また、上記第2の領域は、ガリウム酸化物、ガリウム亜鉛酸化物などが主成分である領域である。つまり、上記第1の領域を、Inを主成分とする領域と言い換えることができる。また、上記第2の領域を、Gaを主成分とする領域と言い換えることができる。

[0342]

なお、上記第1の領域と、上記第2の領域とは、明確な境界が観察できない場合がある。

[0343]

また、In-Ga-Zn酸化物におけるCAC-OSとは、In、Ga、Zn、及びOを含む材料構成において、一部にGaを主成分とする領域と、一部にInを主成分とする領域とが、それぞれモザイク状であり、これらの領域がランダムに存在している構成をいう。よって、CAC-OSは、金属元素が不均一に分布した構造を有していると推測される。

[0344]

CAC-OSは、例えば基板を意図的に加熱しない条件で、スパッタリング法により形成することができる。また、CAC-OSをスパッタリング法で形成する場合、成膜ガスとして、不活性ガス（代表的にはアルゴン）、酸素ガス、及び窒素ガスの中から選ばれたいずれか一つまたは複数を用いればよい。また、成膜時の成膜ガスの総流量に対する酸素ガスの流量比は低いほど好ましく、例えば、成膜時の成膜ガスの総流量に対する酸素ガスの流量比を0%以上30%未満、好ましくは0%以上10%以下とすることが好ましい。

[0345]

また、例えば、In-Ga-Zn酸化物におけるCAC-OSでは、エネルギー分散型X線分光法(EDX: Energy Dispersive X-ray spectroscopy)を用いて取得したEDXマッピングにより、Inを主成分とする領域(第1の領域)と、Gaを主成分とする領域(第2の領域)とが、偏在し、混合している構造を有することが確認できる。

[0346]

ここで、第1の領域は、第2の領域と比較して、導電性が高い領域である。つまり、第1の領域を、キャリアが流れることにより、金属酸化物としての導電性が発現する。従って、第1の領域が、金属酸化物中にクラウド状に分布することで、高い電界効果移動度(μ)が実現できる。

[0347]

一方、第2の領域は、第1の領域と比較して、絶縁性が高い領域である。つまり、第2の領域が、金属酸化物中に分布することで、リーク電流を抑制することができる。

[0348]

従って、CAC-OSをトランジスタに用いる場合、第1の領域に起因する導電性と、第2の領域に起因する絶縁性とが、相補的に作用することにより、スイッチングさせる機能(On/Offさせる機能)をCAC-OSに付与することができる。つまり、CAC-OSとは、材料の一部では導電性の機能と、材料の一部では絶縁性の機能とを有し、材料の全体では半導体としての機能を有する。導電性の機能と絶縁性の機能とを分離させることで、双方の機能を最大限に高めることができる。よって、CAC-OSをトランジスタに用いることで、高いオン電流(I_{on})、高い電界効果移動度(μ)、及び良好なスイッチング動作を実現することができる。

[0349]

また、CAC-OSを用いたトランジスタは、信頼性が高い。従って、CAC-OSは、表示装置をはじめとするさまざまな半導体装置に最適である。

[0350]

酸化物半導体は、多様な構造をとり、それぞれが異なる特性を有する。本発明の一態様の酸化物半導体は、非晶質酸化物半導体、多結晶酸化物半導体、a-like OS、CAC-OS、nc-OS、CAAC-OSのうち、二種以上を有していてもよい。

[0351]

<酸化物半導体を有するトランジスタ>

続いて、上記酸化物半導体をトランジスタに用いる場合について説明する。

[0352]

上記酸化物半導体をトランジスタに用いることで、高い電界効果移動度のトランジスタを実現することができる。また、信頼性の高いトランジスタを実現することができる。

[0353]

トランジスタには、キャリア濃度の低い酸化物半導体を用いることが好ましい。例えば、酸化物半導体のキャリア濃度は $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 以下、好ましくは $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 以下、さらに好ましくは $1 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ 以下、より好ましくは $1 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}$ 以下、さらに好ましくは $1 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 未満であり、 $1 \times 10^{-9} \text{ cm}^{-3}$ 以上である。なお、酸化物半導体膜のキャリア濃度を低くする場合においては、酸化物半導体膜中の不純物濃度を低くし、欠陥準位密度を低くすればよい。本明細書等において、不純物濃度が低く、欠陥準位密度の低いことを高純度真性または実質的

に高純度真性と言う。なお、キャリア濃度の低い酸化物半導体を、高純度真性または実質的に高純度真性な酸化物半導体と呼ぶ場合がある。

[0354]

また、高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜は、欠陥準位密度が低いため、トラップ準位密度も低くなる場合がある。

[0355]

また、酸化物半導体のトラップ準位に捕獲された電荷は、消失するまでに要する時間が長く、あたかも固定電荷のように振る舞うことがある。そのため、トラップ準位密度の高い酸化物半導体にチャンネル形成領域が形成されるトランジスタは、電気特性が不安定となる場合がある。

[0356]

従って、トランジスタの電気特性を安定にするためには、酸化物半導体中の不純物濃度を低減することが有効である。また、酸化物半導体中の不純物濃度を低減するためには、近接する膜中の不純物濃度も低減することが好ましい。不純物としては、水素、窒素、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄、ニッケル、シリコン等がある。

[0357]

<不純物>

ここで、酸化物半導体中における各不純物の影響について説明する。

[0358]

酸化物半導体において、第14族元素の一つであるシリコンまたは炭素が含まれると、酸化物半導体において欠陥準位が形成される。このため、酸化物半導体におけるシリコンまたは炭素の濃度と、酸化物半導体との界面近傍のシリコンまたは炭素の濃度（二次イオン質量分析法（SIMS: Secondary Ion Mass Spectrometry）により得られる濃度）を、 $2 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以下、好ましくは $2 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$ 以下とする。

[0359]

また、酸化物半導体にアルカリ金属またはアルカリ土類金属が含まれると、欠陥準位を形成し、キャリアを生成する場合がある。従って、アルカリ金属またはアルカリ土類金属が含まれている酸化物半導体を用いたトランジスタはノーモリーオン特性となりやすい。このため、SIMSにより得られる酸化物半導体中のアルカリ金属またはアルカリ土類金属の濃度を、 $1 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以下、好ましくは $2 \times 10^{16} \text{ atoms/cm}^3$ 以下にする。

[0360]

また、酸化物半導体において、窒素が含まれると、キャリアである電子が生じ、キャリア濃度が増加し、n型化しやすい。この結果、窒素が含まれている酸化物半導体を半導体を用いたトランジスタはノーモリーオン特性となりやすい。または、酸化物半導体において、窒素が含まれると、トラップ準位が形成される場合がある。この結果、トランジスタの電気特性が不安定となる場合がある。このため、SIMSにより得られる酸化物半導体中の窒素濃度を、 $5 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ 未満、好ましくは $5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以下、より好ましくは $1 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以下、さらに好ましくは $5 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$ 以下にする。

[0361]

また、酸化物半導体に含まれる水素は、金属原子と結合する酸素と反応して水になるため、酸素欠損を形成する場合がある。該酸素欠損に水素が入ることで、キャリアである電子が生成される場

合がある。また、水素の一部が金属原子と結合する酸素と結合して、キャリアである電子を生成することがある。従って、水素が含まれている酸化物半導体を用いたトランジスタはノーマリーオン特性となりやすい。このため、酸化物半導体中の水素はできる限り低減されていることが好ましい。具体的には、酸化物半導体において、SIMSにより得られる水素濃度を、 1×10^{20} atoms/cm³未満、好ましくは 1×10^{19} atoms/cm³未満、より好ましくは 5×10^{18} atoms/cm³未満、さらに好ましくは 1×10^{18} atoms/cm³未満にする。

[0362]

不純物が十分に低減された酸化物半導体をトランジスタのチャネル形成領域に用いることで、安定した電気特性を付与することができる。

[0363]

本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせる実施することができる。

[0364]

(実施の形態6)

本実施の形態では、本発明の一態様の電子機器について図19乃至図22を用いて説明する。

[0365]

本実施の形態の電子機器は、本発明の一態様の表示装置を有する。本発明の一態様の表示装置は、高精細化、高解像度化、大型化のそれぞれが容易である。したがって、本発明の一態様の表示装置は、様々な電子機器の表示部に用いることができる。

[0366]

また、本発明の一態様の表示装置は、低いコストで作製できるため、電子機器の製造コストを低減することができる。

[0367]

電子機器としては、例えば、テレビジョン装置、デスクトップ型もしくはノート型のパーソナルコンピュータ、コンピュータ用などのモニタ、デジタルサイネージ、パチンコ機などの大型ゲーム機などの比較的大きな画面を備える電子機器の他、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、デジタルフォトフレーム、携帯電話機、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置、などが挙げられる。

[0368]

特に、本発明の一態様の表示装置は、精細度を高めることが可能なため、比較的小さな表示部を有する電子機器に好適に用いることができる。このような電子機器としては、例えば腕時計型、ブレスレット型などの情報端末機（ウェアラブル機器）、並びに、ヘッドマウントディスプレイなどのVR向け機器、メガネ型のAR向け機器など、頭部に装着可能なウェアラブル機器等が挙げられる。また、ウェアラブル機器としては、SR (Substitutional Reality) 向け機器、及び、MR (Mixed Reality) 向け機器も挙げられる。

[0369]

本発明の一態様の表示装置は、HD (画素数 1280×720)、FHD (画素数 1920×1080)、WQHD (画素数 2560×1440)、WQXGA (画素数 2560×1600)、4K2K (画素数 3840×2160)、8K4K (画素数 7680×4320)といった極めて高い解像度を有していることが好ましい。特に4K2K、8K4K、又はそれ以上の解像度とする

ことが好ましい。また、本発明の一態様の表示装置における画素密度（精細度）は、300 p p i 以上が好ましく、500 p p i 以上がより好ましく、1000 p p i 以上がより好ましく、2000 p p i 以上がより好ましく、3000 p p i 以上がより好ましく、5000 p p i 以上がより好ましく、7000 p p i 以上がさらに好ましい。このように高い解像度または高い精細度を有する表示装置を用いることで、携帯型または家庭用途などのパーソナルユースの電子機器において、臨場感及び奥行き感などをより高めることが可能となる。

[0370]

本実施の形態の電子機器は、家屋もしくはビルの内壁もしくは外壁、または、自動車の内装もしくは外装の曲面に沿って組み込むことができる。

[0371]

本実施の形態の電子機器は、アンテナを有していてもよい。アンテナで信号を受信することで、表示部で映像及び情報等の表示を行うことができる。また、電子機器がアンテナ及び二次電池を有する場合、アンテナを、非接触電力伝送に用いてもよい。

[0372]

本実施の形態の電子機器は、センサ（力、変位、位置、速度、加速度、角速度、回転数、距離、光、液、磁気、温度、化学物質、音声、時間、硬度、電場、電流、電圧、電力、放射線、流量、湿度、傾度、振動、においまたは赤外線を検知、検出、または測定する機能を含むもの）を有していてもよい。

[0373]

本実施の形態の電子機器は、様々な機能を有することができる。例えば、様々な情報（静止画、動画、テキスト画像など）を表示部に表示する機能、タッチパネル機能、カレンダー、日付または時刻などを表示する機能、様々なソフトウェア（プログラム）を実行する機能、無線通信機能、記録媒体に記録されているプログラムまたはデータを読み出す機能等を有することができる。

[0374]

図19Aに示す電子機器6500は、スマートフォンとして用いることのできる携帯情報端末機である。

[0375]

電子機器6500は、筐体6501、表示部6502、電源ボタン6503、ボタン6504、スピーカ6505、マイク6506、カメラ6507、及び光源6508等を有する。表示部6502はタッチパネル機能を備える。

[0376]

表示部6502に、本発明の一態様の表示装置を適用することができる。

[0377]

図19Bは、筐体6501のマイク6506側の端部を含む断面概略図である。

[0378]

筐体6501の表示面側には透光性を有する保護部材6510が設けられ、筐体6501と保護部材6510に囲まれた空間内に、表示パネル6511、光学部材6512、タッチセンサパネル6513、プリント基板6517、バッテリー6518等が配置されている。

[0379]

保護部材6510には、表示パネル6511、光学部材6512、及びタッチセンサパネル65

13が接着層（図示しない）により固定されている。

[0380]

表示部6502よりも外側の領域において、表示パネル6511の一部が折り返されており、当該折り返された部分にFPC6515が接続されている。FPC6515には、IC6516が実装されている。FPC6515は、プリント基板6517に設けられた端子に接続されている。

[0381]

表示パネル6511には本発明の一態様のフレキシブルディスプレイ（可撓性を有する表示装置）を適用することができる。そのため、極めて軽量の電子機器を実現できる。また、表示パネル6511が極めて薄いため、電子機器の厚さを抑えつつ、大容量のバッテリー6518を搭載することもできる。また、表示パネル6511の一部を折り返して、画素部の裏側にFPC6515との接続部を配置することにより、狭額縁の電子機器を実現できる。

[0382]

図20Aにテレビジョン装置の一例を示す。テレビジョン装置7100は、筐体7101に表示部7000が組み込まれている。ここでは、スタンド7103により筐体7101を支持した構成を示している。

[0383]

表示部7000に、本発明の一態様の表示装置を適用することができる。

[0384]

図20Aに示すテレビジョン装置7100の操作は、筐体7101が備える操作スイッチ、及び、別体のリモコン操作機7111により行うことができる。または、表示部7000にタッチセンサを備えていてもよく、指等で表示部7000に触れることでテレビジョン装置7100を操作してもよい。リモコン操作機7111は、当該リモコン操作機7111から出力する情報を表示する表示部を有していてもよい。リモコン操作機7111が備える操作キーまたはタッチパネルにより、チャンネル及び音量の操作を行うことができ、表示部7000に表示される映像を操作することができる。

[0385]

なお、テレビジョン装置7100は、受信機及びモデムなどを備えた構成とする。受信機により一般のテレビ放送の受信を行うことができる。また、モデムを介して有線または無線による通信ネットワークに接続することにより、一方向（送信者から受信者）または双方向（送信者と受信者間、あるいは受信者間同士など）の情報通信を行うことも可能である。

[0386]

図20Bに、ノート型パーソナルコンピュータの一例を示す。ノート型パーソナルコンピュータ7200は、筐体7211、キーボード7212、ポインティングデバイス7213、外部接続ポート7214等を有する。筐体7211に、表示部7000が組み込まれている。

[0387]

表示部7000に、本発明の一態様の表示装置を適用することができる。

[0388]

図20C及び図20Dに、デジタルサイネージの一例を示す。

[0389]

図20Cに示すデジタルサイネージ7300は、筐体7301、表示部7000、及びスピーカ

7303等を有する。さらに、LEDランプ、操作キー（電源スイッチ、または操作スイッチを含む）、接続端子、各種センサ、マイクロフォン等を有することができる。

[0390]

図20Dは円柱状の柱7401に取り付けられたデジタルサイネージ7400である。デジタルサイネージ7400は、柱7401の曲面に沿って設けられた表示部7000を有する。

[0391]

図20C及び図20Dにおいて、表示部7000に、本発明の一態様の表示装置を適用することができる。

[0392]

表示部7000が広いほど、一度に提供できる情報量を増やすことができる。また、表示部7000が広いほど、人の目につきやすく、例えば、広告の宣伝効果を高めることができる。

[0393]

表示部7000にタッチパネルを適用することで、表示部7000に画像または動画を表示するだけでなく、使用者が直感的に操作することができ、好ましい。また、路線情報もしくは交通情報などの情報を提供するための用途に用いる場合には、直感的な操作によりユーザビリティを高めることができる。

[0394]

また、図20C及び図20Dに示すように、デジタルサイネージ7300またはデジタルサイネージ7400は、ユーザが所持するスマートフォン等の情報端末機7311または情報端末機7411と無線通信により連携可能であることが好ましい。例えば、表示部7000に表示される広告の情報を、情報端末機7311または情報端末機7411の画面に表示させることができる。また、情報端末機7311または情報端末機7411を操作することで、表示部7000の表示を切り替えることができる。

[0395]

また、デジタルサイネージ7300またはデジタルサイネージ7400に、情報端末機7311または情報端末機7411の画面を操作手段（コントローラ）としたゲームを実行させることもできる。これにより、不特定多数のユーザが同時にゲームに参加し、楽しむことができる。

[0396]

図21Aは、ファインダー8100を取り付けた状態のカメラ8000の外観を示す図である。

[0397]

カメラ8000は、筐体8001、表示部8002、操作ボタン8003、シャッターボタン8004等を有する。またカメラ8000には、着脱可能なレンズ8006が取り付けられている。なお、カメラ8000は、レンズ8006と筐体8001とが一体となってもよい。

[0398]

カメラ8000は、シャッターボタン8004を押す、またはタッチパネルとして機能する表示部8002をタッチすることにより撮像することができる。

[0399]

筐体8001は、電極を有するマウントを有し、ファインダー8100のほか、ストロボ装置等を接続することができる。

[0400]

ファインダー8100は、筐体8101、表示部8102、ボタン8103等を有する。

[0401]

筐体8101は、カメラ8000のマウントと係合するマウントにより、カメラ8000に取り付けられている。ファインダー8100はカメラ8000から受信した映像等を表示部8102に表示させることができる。

[0402]

ボタン8103は、電源ボタン等としての機能を有する。

[0403]

カメラ8000の表示部8002、及びファインダー8100の表示部8102に、本発明の一態様の表示装置を適用することができる。なお、ファインダーが内蔵されたカメラ8000であってもよい。

[0404]

図21Bは、ヘッドマウントディスプレイ8200の外観を示す図である。

[0405]

ヘッドマウントディスプレイ8200は、装着部8201、レンズ8202、本体8203、表示部8204、ケーブル8205等を有している。また装着部8201には、バッテリー8206が内蔵されている。

[0406]

ケーブル8205は、バッテリー8206から本体8203に電力を供給する。本体8203は無線受信機等を備え、受信した映像情報を表示部8204に表示させることができる。また、本体8203はカメラを備え、使用者の眼球またはまぶたの動きの情報を入力手段として用いることができる。

[0407]

また、装着部8201には、使用者に触れる位置に、使用者の眼球の動きに伴って流れる電流を検知可能な複数の電極が設けられ、視線を認識する機能を有していてもよい。また、当該電極に流れる電流により、使用者の脈拍をモニタする機能を有していてもよい。また、装着部8201には、温度センサ、圧力センサ、加速度センサ等の各種センサを有していてもよく、使用者の生体情報を表示部8204に表示する機能、使用者の頭部の動きに合わせて表示部8204に表示する映像を変化させる機能などを有していてもよい。

[0408]

表示部8204に、本発明の一態様の表示装置を適用することができる。

[0409]

図21C乃至図21Eは、ヘッドマウントディスプレイ8300の外観を示す図である。ヘッドマウントディスプレイ8300は、筐体8301と、表示部8302と、バンド状の固定具8304と、一対のレンズ8305と、を有する。

[0410]

使用者は、レンズ8305を通して、表示部8302の表示を視認することができる。なお、表示部8302を湾曲して配置させると、使用者が高い臨場感を感じることができるため好ましい。また、表示部8302の異なる領域に表示された別の画像を、レンズ8305を通して視認することで、視差を用いた3次元表示等を行うこともできる。なお、表示部8302を1つ設ける構成に

限られず、表示部 8302 を 2 つ設け、使用者の片方の目につき 1 つの表示部を配置してもよい。

[0411]

表示部 8302 に、本発明の一態様の表示装置を適用することができる。本発明の一態様の表示装置は、極めて高い精細度を実現することも可能である。例えば、図 21E のようにレンズ 8305 を用いて表示を拡大して視認される場合でも、使用者に画素が視認されにくい。つまり、表示部 8302 を用いて、使用者に現実感の高い映像を視認させることができる。

[0412]

図 21F は、ゴーグル型のヘッドマウントディスプレイ 8400 の外観を示す図である。ヘッドマウントディスプレイ 8400 は、一对の筐体 8401 と、装着部 8402 と、緩衝部材 8403 と、を有する。一对の筐体 8401 内には、それぞれ、表示部 8404 及びレンズ 8405 が設けられる。一对の表示部 8404 に互いに異なる画像を表示させることで、視差を用いた 3 次元表示を行うことができる。

[0413]

使用者は、レンズ 8405 を通して表示部 8404 を視認することができる。レンズ 8405 はピント調整機構を有し、ピント調整機構は使用者の視力に応じてレンズ 8405 位置を調整することができる。表示部 8404 は、正方形または横長の長方形であることが好ましい。これにより、臨場感を高めることができる。

[0414]

装着部 8402 は、使用者の顔のサイズに応じて調整でき、かつ、ずれ落ちることのないよう、可塑性及び弾性を有することが好ましい。また、装着部 8402 の一部は、骨伝導イヤフォンとして機能する振動機構を有していることが好ましい。これにより、別途イヤフォン、スピーカなどの音響機器を必要とせず、装着しただけで映像と音声を楽しむことができる。なお、筐体 8401 内に、無線通信により音声データを出力する機能を有していてもよい。

[0415]

装着部 8402 と緩衝部材 8403 は、使用者の顔（額、頬など）に接触する部分である。緩衝部材 8403 が使用者の顔と密着することにより、光漏れを防ぐことができ、より没入感を高めることができる。緩衝部材 8403 は、使用者がヘッドマウントディスプレイ 8400 を装着した際に使用者の顔に密着するよう、柔らかな素材を用いることが好ましい。例えばゴム、シリコーンゴム、ウレタン、スポンジなどの素材を用いることができる。また、スポンジ等の表面を布、革（天然皮革または合成皮革）、などで覆ったものを用いると、使用者の顔と緩衝部材 8403 との間に隙間が生じにくく光漏れを好適に防ぐことができる。また、このような素材を用いると、肌触りが良いことに加え、寒い季節などに装着した際に、使用者に冷たさを感じさせないため好ましい。緩衝部材 8403 または装着部 8402 などの、使用者の肌に触れる部材は、取り外し可能な構成とすると、クリーニングまたは交換が容易となるため好ましい。

[0416]

図 22A 乃至図 22F に示す電子機器は、筐体 9000、表示部 9001、スピーカ 9003、操作キー 9005（電源スイッチ、または操作スイッチを含む）、接続端子 9006、センサ 9007（力、変位、位置、速度、加速度、角速度、回転数、距離、光、液、磁気、温度、化学物質、音声、時間、硬度、電場、電流、電圧、電力、放射線、流量、湿度、傾度、振動、にのみまたは赤外線を検知、検出、または測定する機能を含むもの）、マイクロフォン 9008、等を有する。

[0417]

図22A乃至図22Fに示す電子機器は、様々な機能を有する。例えば、様々な情報（静止画、動画、テキスト画像など）を表示部に表示する機能、タッチパネル機能、カレンダー、日付または時刻などを表示する機能、様々なソフトウェア（プログラム）によって処理を制御する機能、無線通信機能、記録媒体に記録されているプログラムまたはデータを読み出して処理する機能、等を有することができる。なお、電子機器の機能はこれらに限られず、様々な機能を有することができる。電子機器は、複数の表示部を有していてもよい。また、電子機器にカメラ等を設け、静止画または動画を撮影し、記録媒体（外部またはカメラに内蔵）に保存する機能、撮影した画像を表示部に表示する機能、等を有していてもよい。

[0418]

表示部9001に、本発明の一態様の表示装置を適用することができる。

[0419]

図22A乃至図22Fに示す電子機器の詳細について、以下説明を行う。

[0420]

図22Aは、携帯情報端末9101を示す斜視図である。携帯情報端末9101は、例えばスマートフォンとして用いることができる。なお、携帯情報端末9101は、スピーカ9003、接続端子9006、センサ9007等を設けてもよい。また、携帯情報端末9101は、文字及び画像情報をその複数の面に表示することができる。図22Aでは3つのアイコン9050を表示した例を示している。また、破線の矩形で示す情報9051を表示部9001の他の面に表示することもできる。情報9051の一例としては、電子メール、SNS、電話などの着信の通知、電子メール、SNSなどの題名、送信者名、日時、時刻、バッテリーの残量、アンテナ受信の強度などがある。または、情報9051が表示されている位置にはアイコン9050などを表示してもよい。

[0421]

図22Bは、携帯情報端末9102を示す斜視図である。携帯情報端末9102は、表示部9001の3面以上に情報を表示する機能を有する。ここでは、情報9052、情報9053、情報9054がそれぞれ異なる面に表示されている例を示す。例えば使用者は、洋服の胸ポケットに携帯情報端末9102を収納した状態で、携帯情報端末9102の上方から観察できる位置に表示された情報9053を確認することもできる。使用者は、携帯情報端末9102をポケットから取り出すことなく表示を確認し、例えば電話を受けるか否かを判断できる。

[0422]

図22Cは、腕時計型の携帯情報端末9200を示す斜視図である。携帯情報端末9200は、例えばスマートウォッチ（登録商標）として用いることができる。また、表示部9001はその表示面が湾曲して設けられ、湾曲した表示面に沿って表示を行うことができる。また、携帯情報端末9200を、例えば無線通信可能なヘッドセットと相互通信させることによって、ハンズフリーで通話することもできる。また、携帯情報端末9200は、接続端子9006により、他の情報端末と相互にデータ伝送を行うこと、及び、充電を行うこともできる。なお、充電動作は無線給電により行ってもよい。

[0423]

図22D乃至図22Fは、折り畳み可能な携帯情報端末9201を示す斜視図である。また、図22Dは携帯情報端末9201を展開した状態、図22Fは折り畳んだ状態、図22Eは図22D

と図 2 2 F の一方から他方に変化する途中の状態の斜視図である。携帯情報端末 9 2 0 1 は、折り畳んだ状態では可搬性に優れ、展開した状態では継ぎ目のない広い表示領域により表示の一覧性に優れる。携帯情報端末 9 2 0 1 が有する表示部 9 0 0 1 は、ヒンジ 9 0 5 5 によって連結された 3 つの筐体 9 0 0 0 に支持されている。例えば、表示部 9 0 0 1 は、曲率半径 0. 1 mm 以上 1 5 0 mm 以下で曲げることができる。

[0 4 2 4]

本実施の形態で例示した構成例、及びそれらに対応する図面等は、少なくともその一部を他の構成例、または図面等と適宜組み合わせることができる。

[0 4 2 5]

本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせる実施することができる。

[実施例 1]

[0 4 2 6]

本実施例では、本発明の一態様の表示パネルを作製した。本実施例では、精細度が 3 0 7 8 p p i の表示パネルを作製した。

[0 4 2 7]

[表示パネルの作製]

表示パネルの作製は、実施の形態 1、作製方法例 1 で例示した方法に基づいて行った。具体的には、まず、単結晶シリコン基板上にトランジスタ及び配線等を備える画素回路と、画素電極が形成された基板を準備した。続いて、赤色の E L 層、緑色の E L 層、青色の E L 層を順に形成した後に、各 E L 層上の犠牲層及び保護層を除去した。続いて、E L 層上に電子注入層、共通電極、及び保護層を順に形成した。

[0 4 2 8]

E L 層としては、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、及び、電子輸送層の積層構造を形成した。犠牲層には、基板温度 8 0 °C で、A L D 法により形成した酸化アルミニウム膜を用い、保護層には、スパッタリング法により形成した I n - G a - Z n 酸化物膜を用いた。電子注入層には、L i F を用い、共通電極には銀とマグネシウムとの混合膜を用い、共通電極上の保護層にはスパッタリング法により形成した I T O 膜を用いた。

[0 4 2 9]

[結果]

図 2 3 A に、作製した表示パネルの画素の光学顕微鏡写真を示す。表示パネルにおける、画素のピッチは約 8. 2 5 μ m であり、副画素のピッチは約 2. 7 5 μ m であり、画素の開口率（設計値）は約 3 3. 7 %（副画素の開口率約 1 1. 2 % \times 3 に相当）である。

[0 4 3 0]

続いて、図 2 3 A における太線の箇所の断面を矢印の向きから観察した結果を示す。図 2 3 B に、作製した表示パネルの画素の断面 S T E M 観察写真を示す。図 2 3 B に示す画素は、緑（G）の副画素である。画素電極 1 1 1 G の端部を絶縁層 1 3 1 が覆っている。画素電極 1 1 1 G 及び絶縁層 1 3 1 上に E L 層 1 1 2 G が設けられている。E L 層 1 1 2 G を覆うように電子注入層、共通電極 1 1 3、及び保護層 1 2 1 が設けられている。なお、保護層 1 2 1 上には分析用保護膜 1 2 9 が設けられている。

[0431]

図23Bの拡大写真に示すように、EL層112Gのテーパ角は約 83° となっており、垂直に近い形状になっていることが確認できた。

[実施例2]

[0432]

本実施例では、本発明の一態様の表示パネルを作製した。

[0433]

本実施例で作製した表示パネルは、表示部のサイズが対角 0.99 inch の正方形であり、有効画素数が 1920×1920 、精細度が 2731 ppi 、画素ピッチが $9.3\mu\text{m} \times 9.3\mu\text{m}$ 、画素配列がR、G、Bストライプ配列、開口率が 43% （設計値）、フレーム周波数が 90 Hz である。

[0434]

表示パネルは、基板に単結晶シリコン基板を用い、単結晶シリコントランジスタ、配線層、酸化物半導体トランジスタ（OSトランジスタ）、発光素子を順に積層して作製した。発光素子は、犠牲層の2層目（保護層）としてスパッタリング法で形成したタングステン膜を用いたほかは、実施例1と同様の方法で作製した。

[0435]

図24に、作製した表示装置の断面観察像を示す。右側には配線層から発光素子までの断面を示し、左側に、OSトランジスタ及びその近傍の拡大図を示している。ここでは明示していないが、配線層の下側には単結晶シリコン基板と、当該基板に形成された単結晶シリコントランジスタが設けられている。

[0436]

OSトランジスタ（OS（IGZO）FET）は、半導体層にIn-Ga-Zn酸化物膜（IGZO）を用いた。図24には、OSトランジスタのトップゲート（Top gate）、バックゲート（Back gate）、ソース（Source）、ドレイン（Drain）と、容量（Capacitor）を示している。

[0437]

図25A、図25Bに、作製した表示パネルの表示写真を示す。メタルマスクを用いない塗分け方式によって、精細度が 2731 ppi もの極めて高い精細度で、且つ、カラーの画像を実現することができた。

[符号の説明]

[0438]

100：表示装置、100A-G：表示装置、101：基板、110R、G、B、P、Q：発光素子、111R、G、B、P、Q：画素電極、111C：接続電極、112R、G、B、P、Q：EL層、112Rf、Gf、Bf：EL膜、113：共通電極、114：EL層、115R、G、B：光学調整層、121：保護層、122：空隙、129：分析用保護膜、130：接続部、131：絶縁層、143a-d：レジストマスク、144a-c：犠牲膜、145a-c：犠牲層、146a-c：保護膜、147a-c：保護層、151：ダミー層、152：配線、153：スリット

請求の範囲

[請求項 1]

第 1 の発光素子と、第 2 の発光素子と、を有する表示装置であって、
前記第 1 の発光素子は、第 1 の画素電極と、第 1 の E L 層と、共通電極と、を有し、
前記第 2 の発光素子は、第 2 の画素電極と、第 2 の E L 層と、前記共通電極と、を有し、
前記第 1 の画素電極と、前記第 2 の画素電極との間に、絶縁層を有し、
前記絶縁層は、前記第 1 の E L 層と重なる第 1 の領域と、前記第 2 の E L 層と重なる第 2 の領域と、前記第 1 の領域と前記第 2 の領域の間に位置し、且つ前記第 1 の E L 層及び前記第 2 の E L 層のいずれとも重ならない第 3 の領域と、を有し、
前記第 1 の E L 層の側面と、前記第 2 の E L 層の側面とは、それぞれ前記絶縁層上に位置し、且つ、対向して設けられ、
前記共通電極は、前記第 1 の E L 層の前記側面、前記第 2 の E L 層の前記側面、及び前記絶縁層の上面に沿って設けられ、
前記絶縁層は、無機絶縁材料を含み、
前記絶縁層の幅は、前記第 1 の画素電極と前記第 2 の画素電極との間の距離の 2 倍以上 4 倍以下である、
表示装置。

[請求項 2]

第 1 の発光素子と、第 2 の発光素子と、を有する表示装置であって、
前記第 1 の発光素子は、第 1 の画素電極と、第 1 の E L 層と、共通電極と、を有し、
前記第 2 の発光素子は、第 2 の画素電極と、第 2 の E L 層と、前記共通電極と、を有し、
前記第 1 の画素電極と、前記第 2 の画素電極との間に、絶縁層を有し、
前記絶縁層は、前記第 1 の E L 層と重なる第 1 の領域と、前記第 2 の E L 層と重なる第 2 の領域と、前記第 1 の領域と前記第 2 の領域の間に位置し、且つ前記第 1 の E L 層及び前記第 2 の E L 層のいずれとも重ならない第 3 の領域と、を有し、
前記第 1 の E L 層の側面と、前記第 2 の E L 層の側面とは、それぞれ前記絶縁層上に位置し、且つ、対向して設けられ、
前記共通電極は、前記第 1 の E L 層の前記側面、前記第 2 の E L 層の前記側面、及び前記絶縁層の上面に沿って設けられ、
前記絶縁層は、無機絶縁材料を含み、
前記絶縁層の幅は、前記第 1 の E L 層の前記側面と、前記第 2 の E L 層の前記側面との距離の 2 倍以上 4 倍以下である、
表示装置。

[請求項 3]

請求項 1 または請求項 2 において、
前記第 1 の領域の幅が、前記第 3 の領域の幅よりも大きく、且つ、300 nm 以下であり、
前記第 2 の領域の幅が、前記第 3 の領域の幅よりも大きく、且つ、300 nm 以下である、
表示装置。

[請求項 4]

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一において、

前記第1の領域の幅と前記第2の領域の幅の和が、前記第3の領域の幅の2倍よりも大きく、
前記第1の領域の幅、前記第2の領域の幅、及び前記第3の領域の幅の和が、1000nm以下
である、

表示装置。

[請求項5]

請求項1乃至請求項4のいずれか一において、
前記第3の領域の幅が、50nm以上250nm以下である、
表示装置。

[請求項6]

請求項1乃至請求項5のいずれか一において、
有効発光面積比が、70%以上100%未満である、
表示装置。

図1A

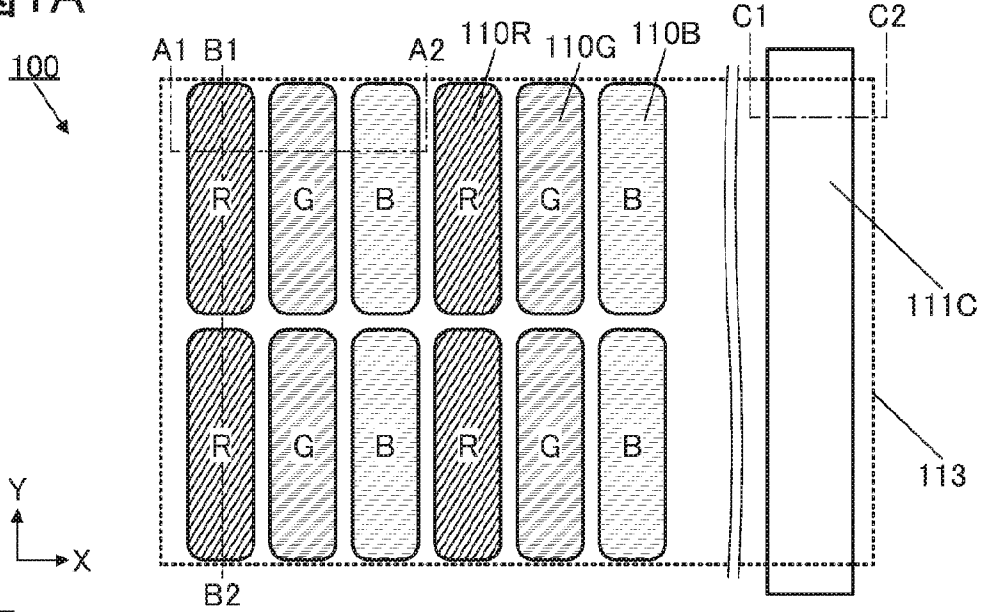


図1B

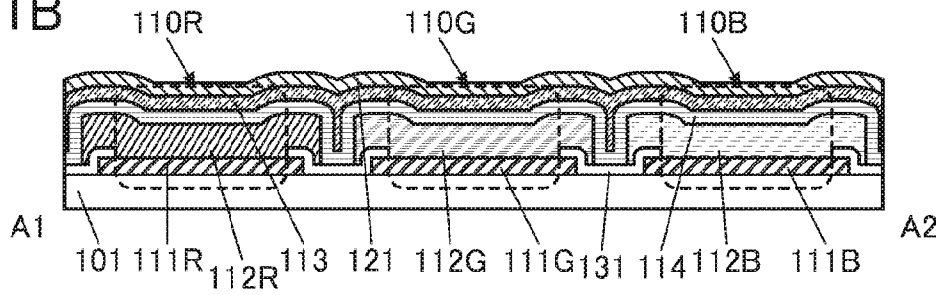


図1C

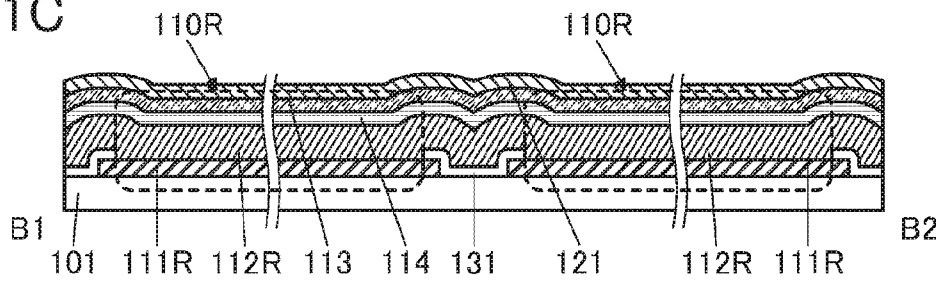
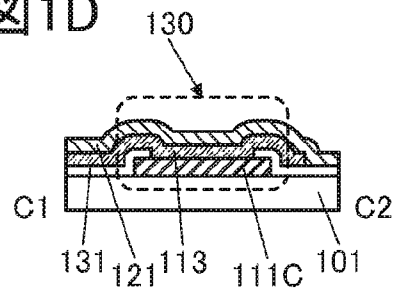
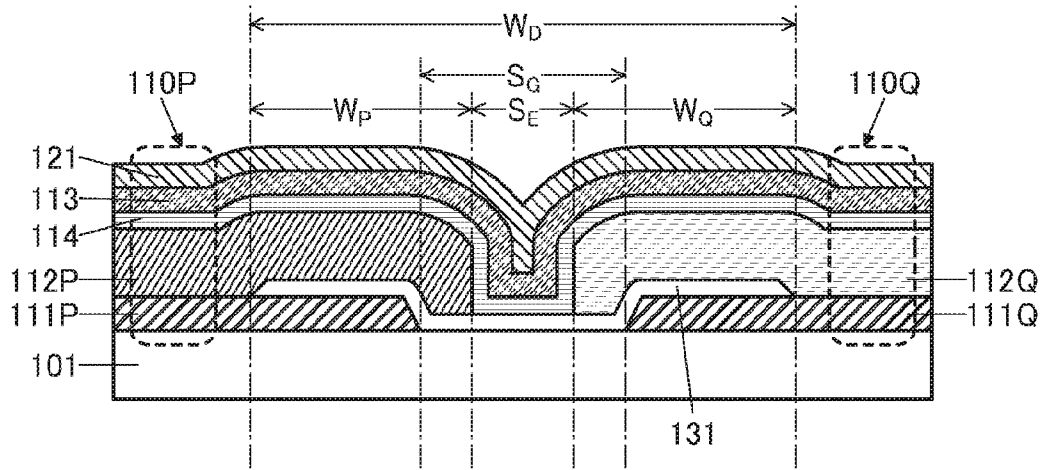


図1D



2A



2B

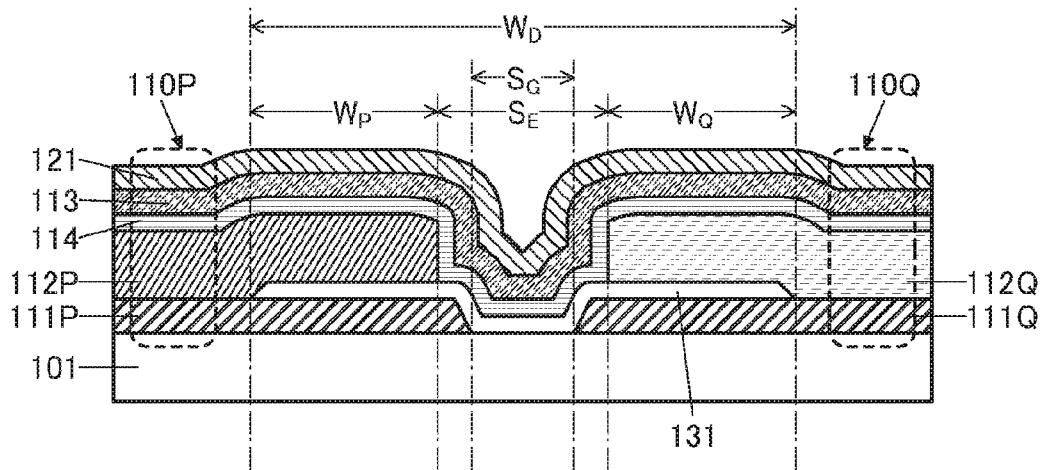


図3A

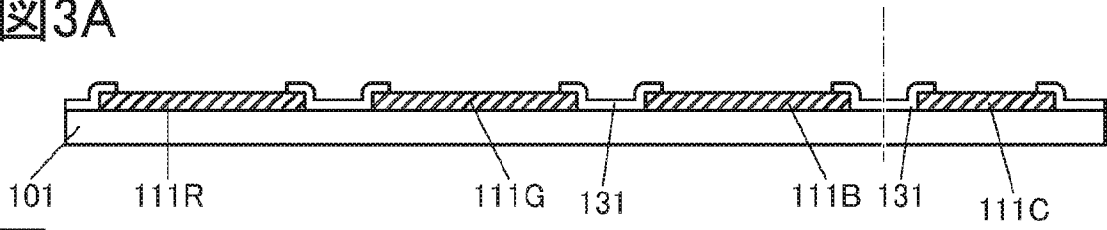


図3B

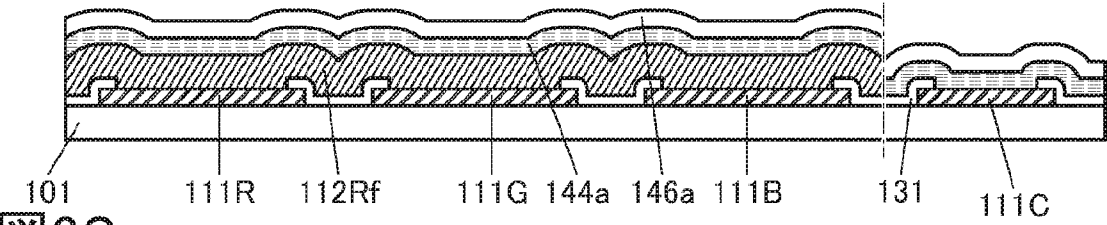


図3C

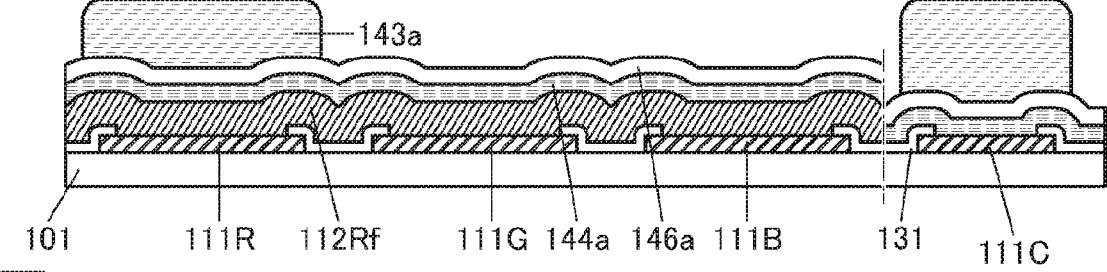


図3D

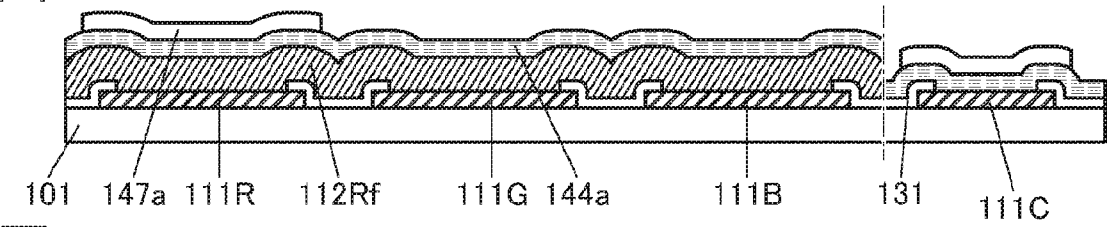


図3E

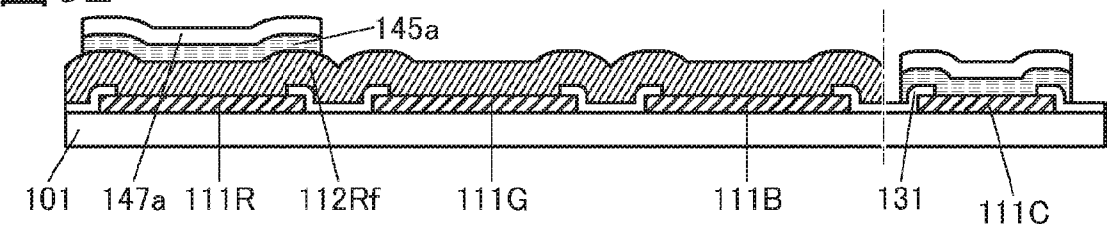


図3F

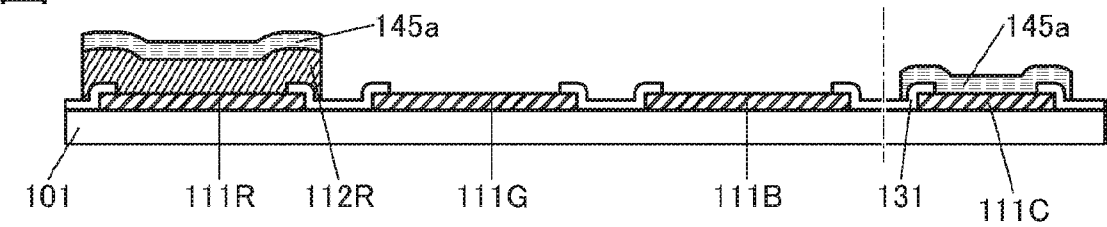


図4A

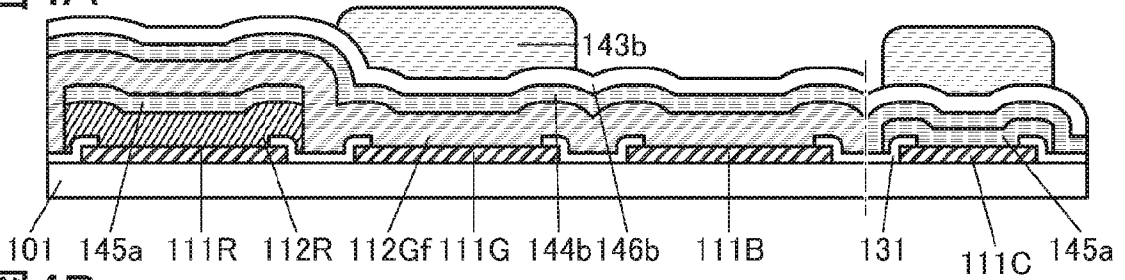


図4B

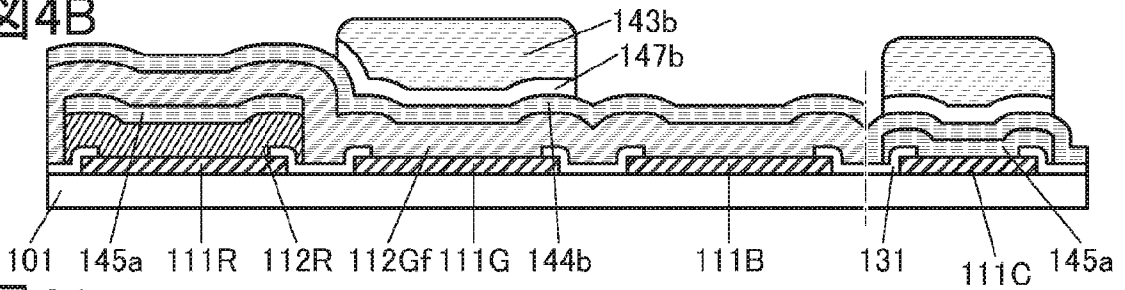


図4C

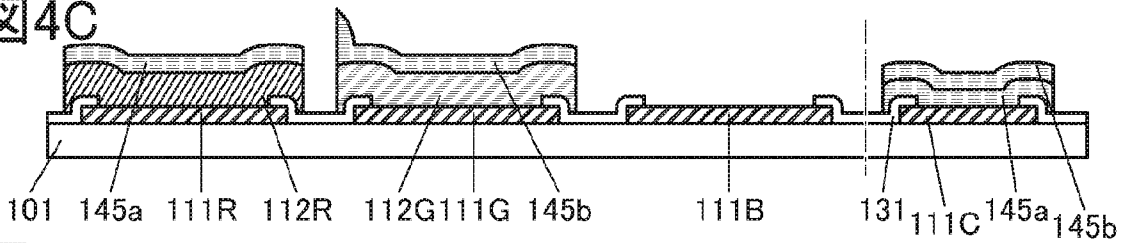


図4D

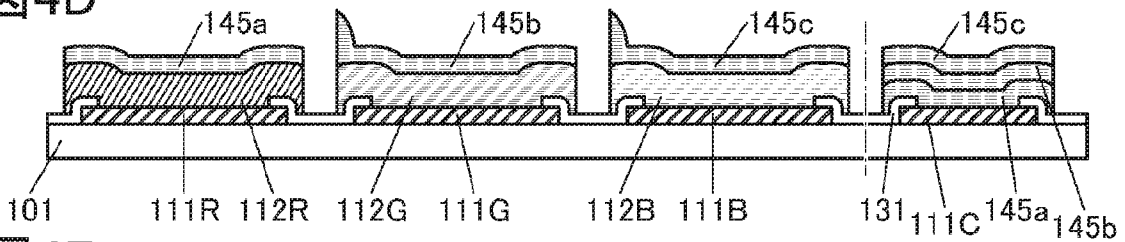


図4E

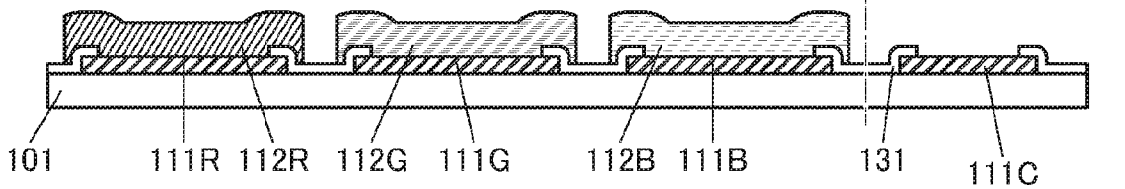


図4F

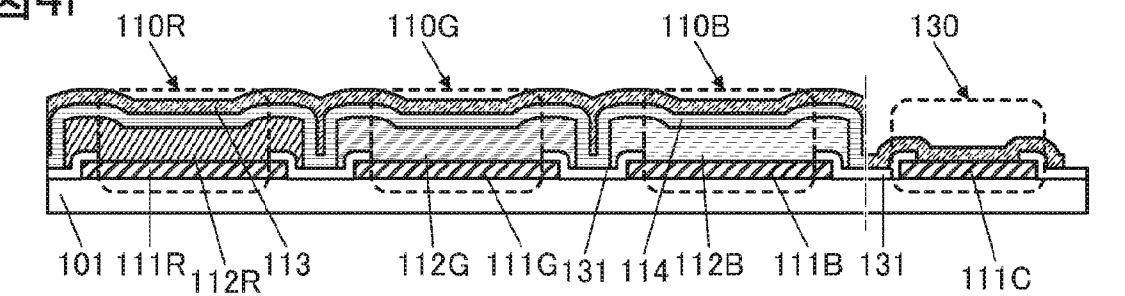


図5A

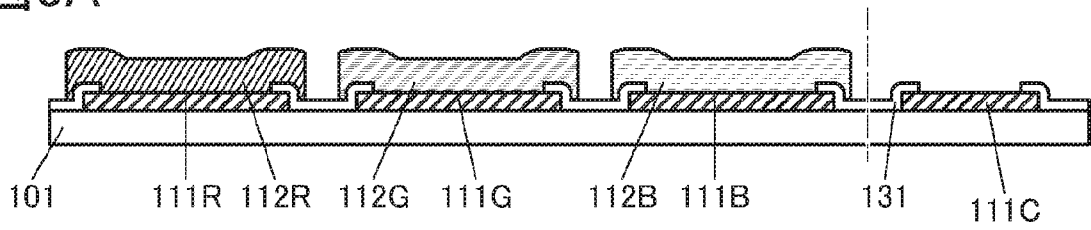


図5B

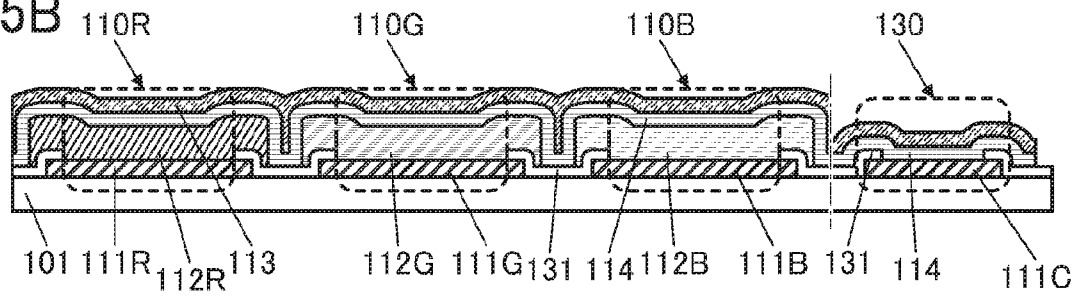


図5C

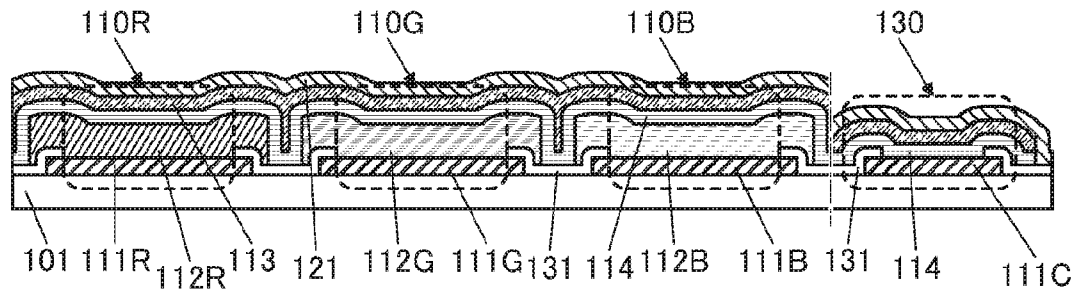


図6A

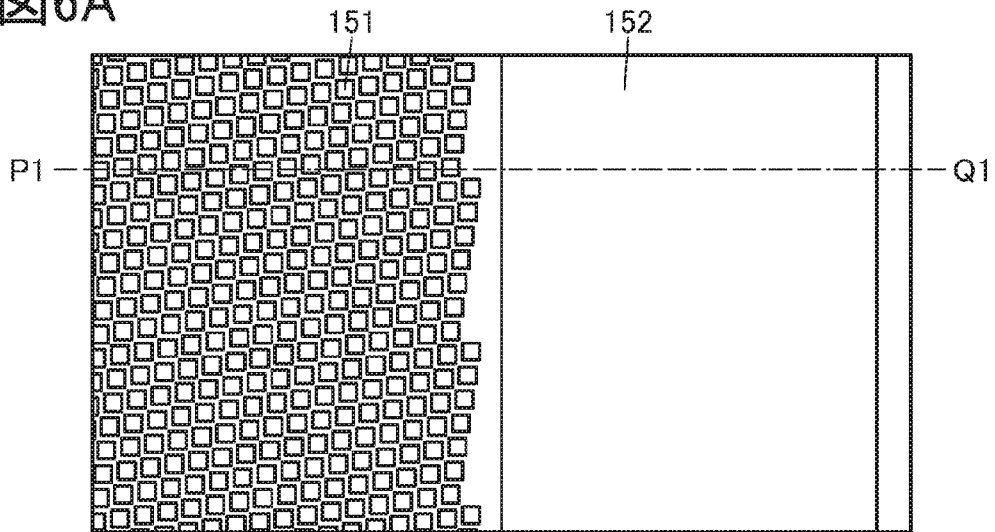


図6B

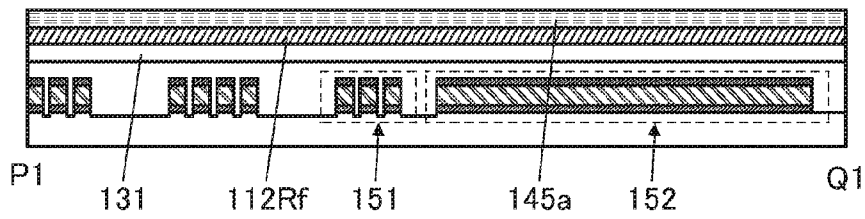


図6C

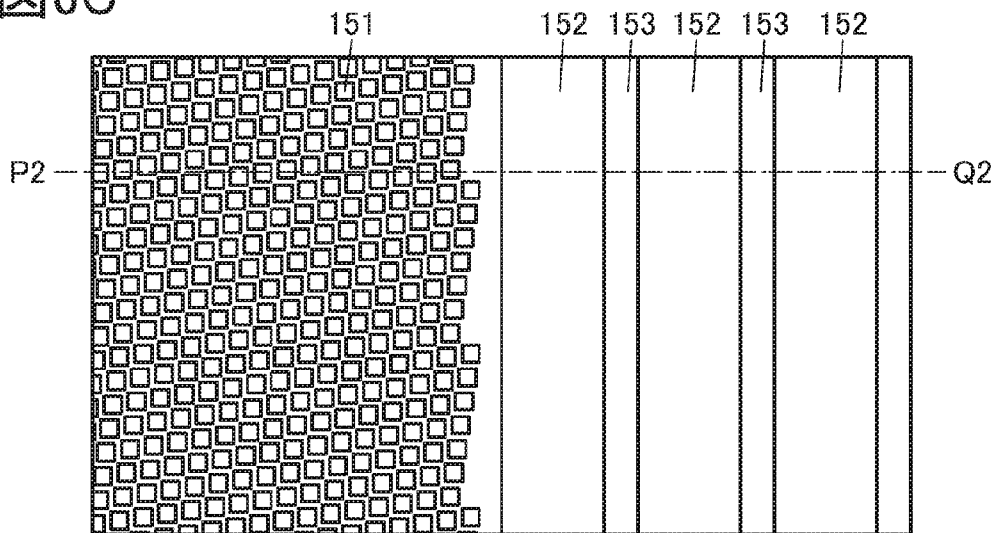


図6D

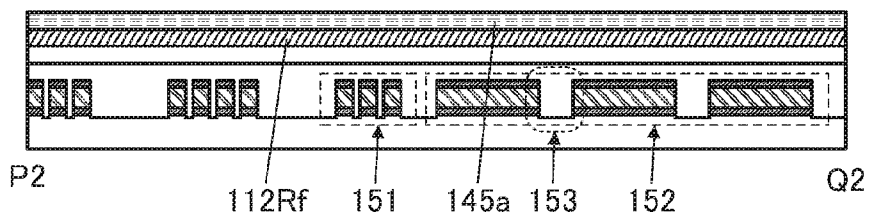


図7A

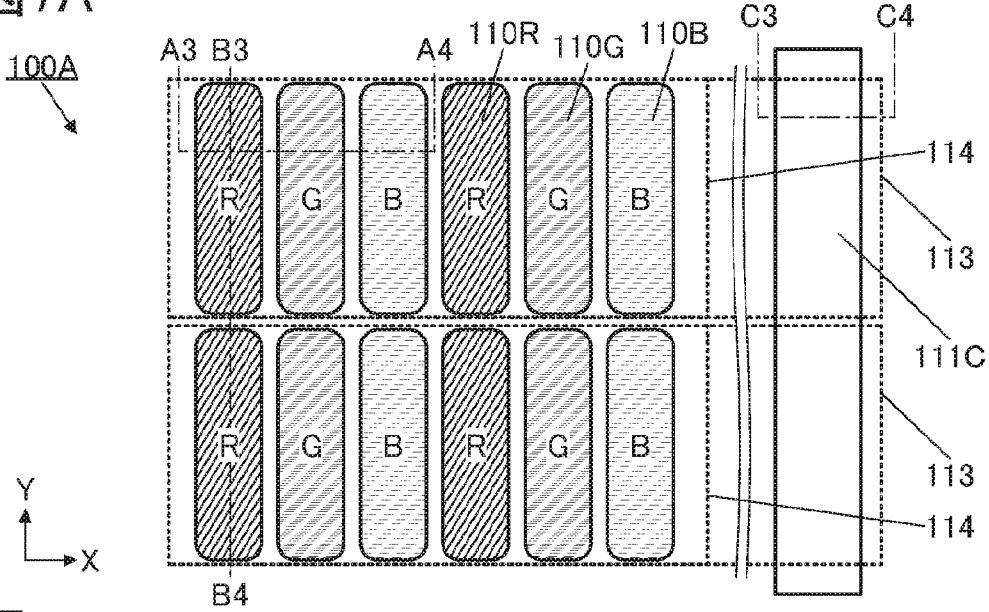


図7B

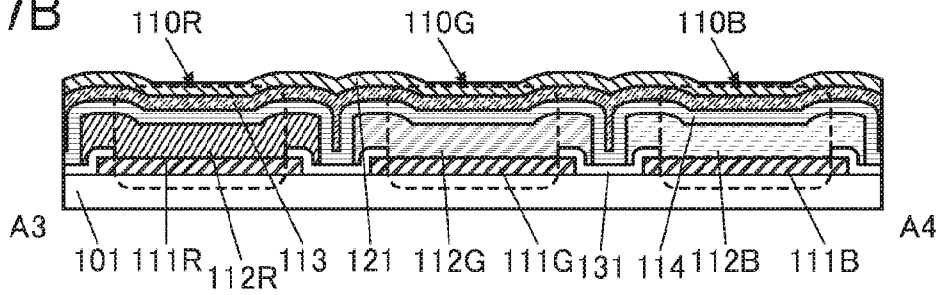


図7C

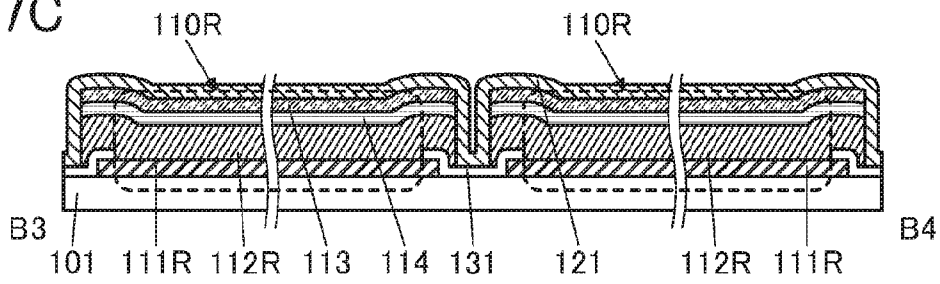
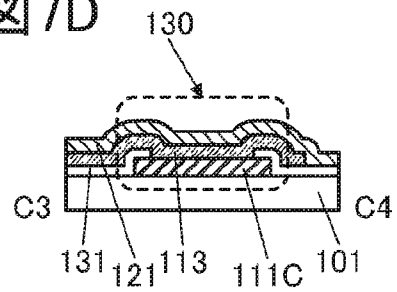
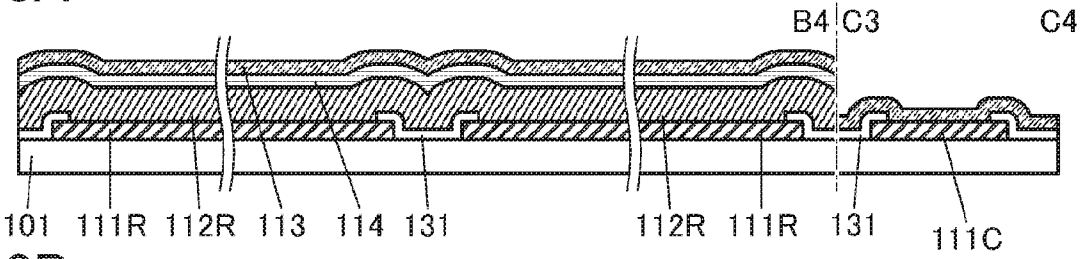


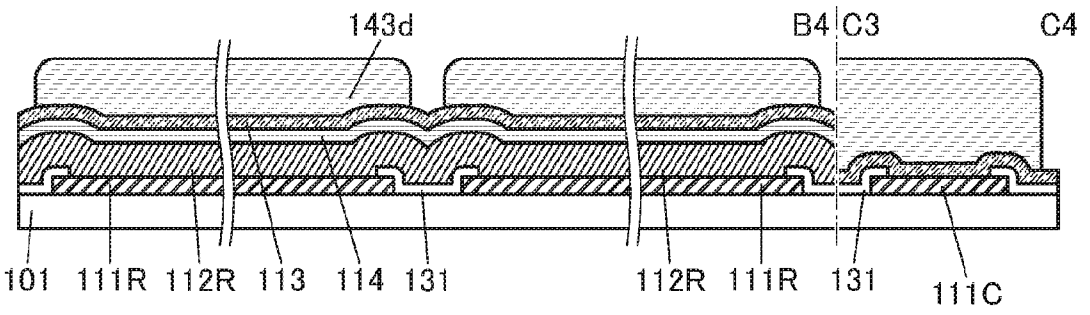
図7D



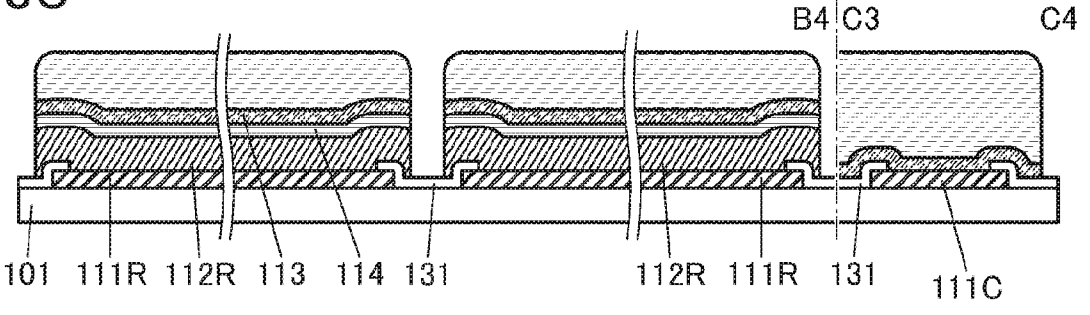
8A



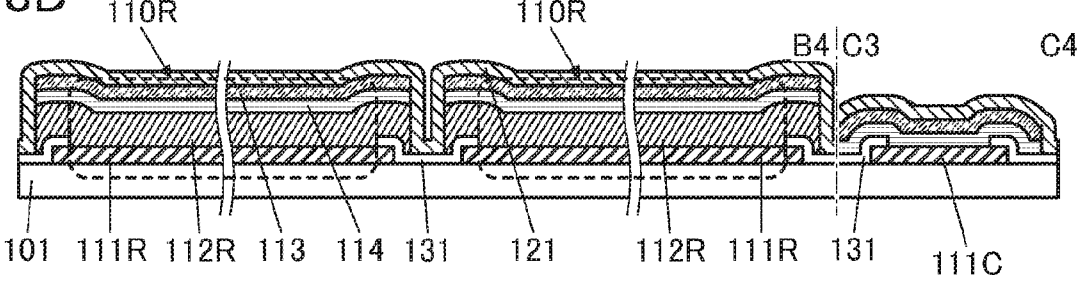
8B



8C



8D



8E

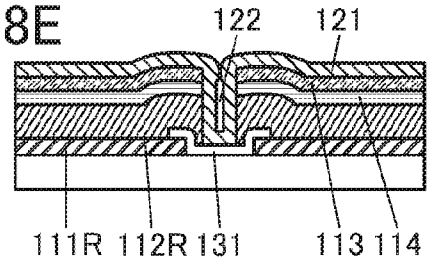


図10A

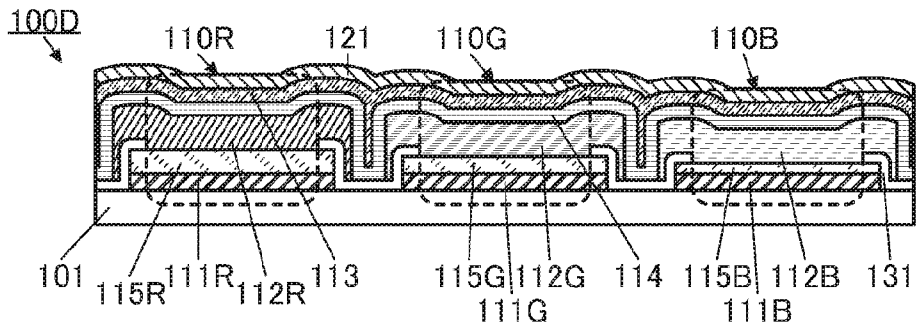


図10B

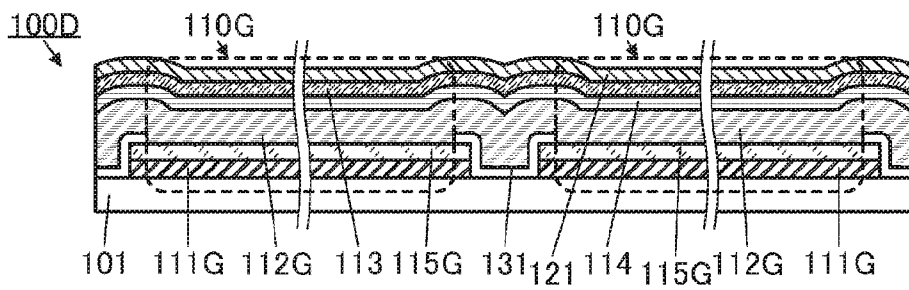


図10C

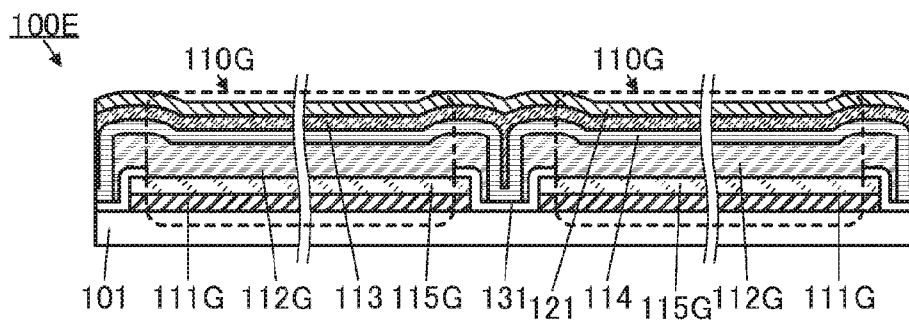


図11A

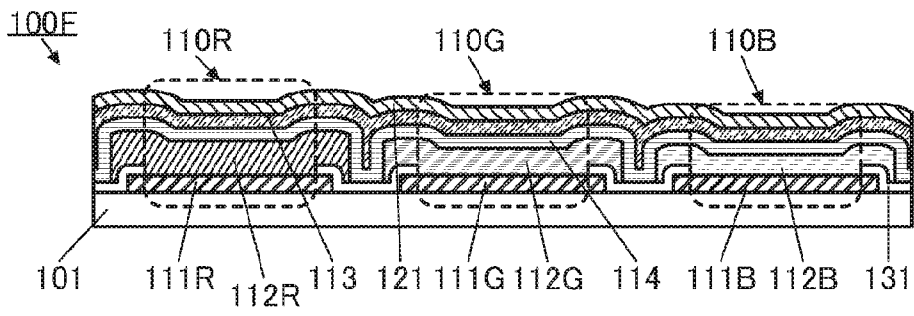


図11B

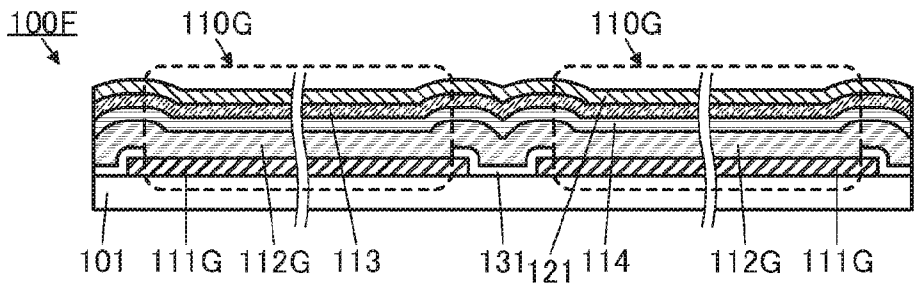


図11C

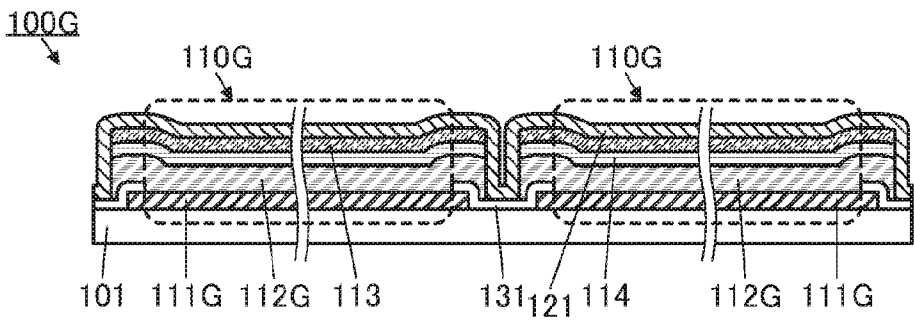


図 12A

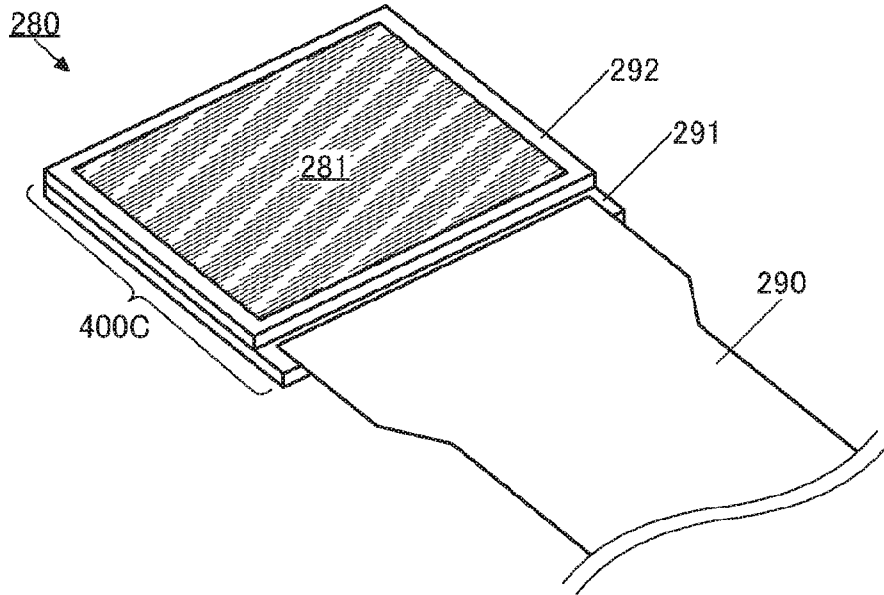


図 12B

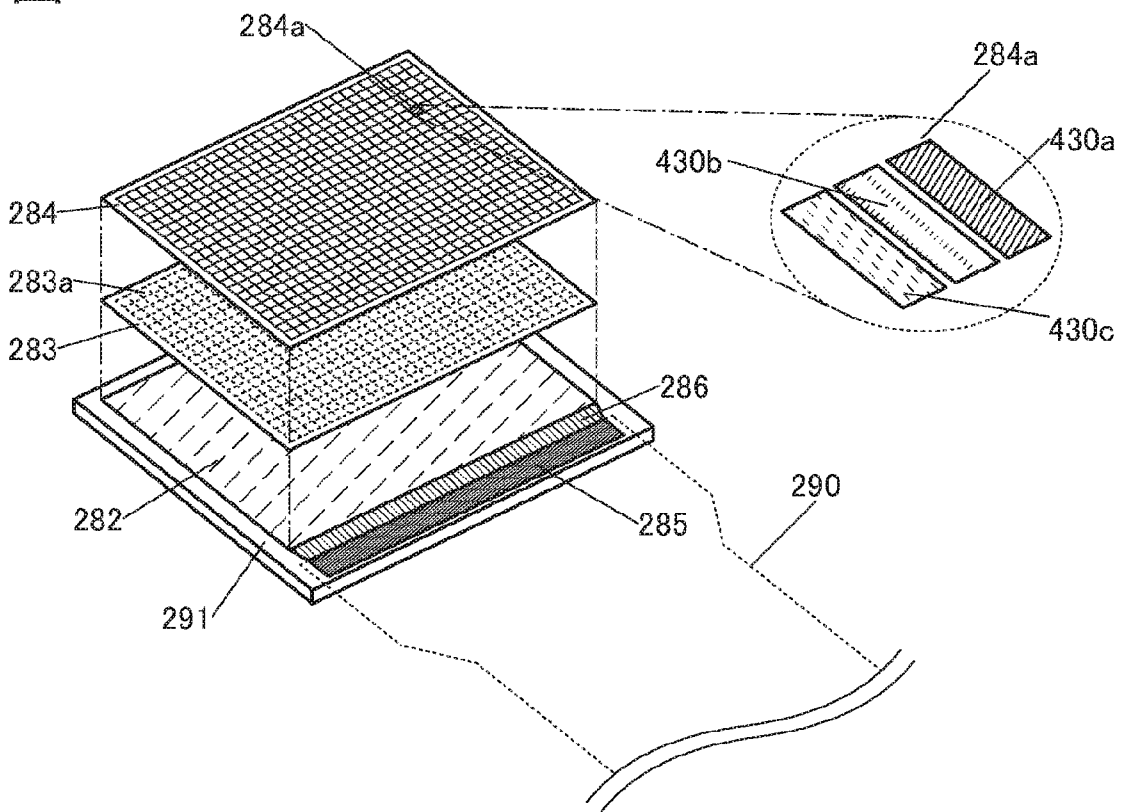


図 13

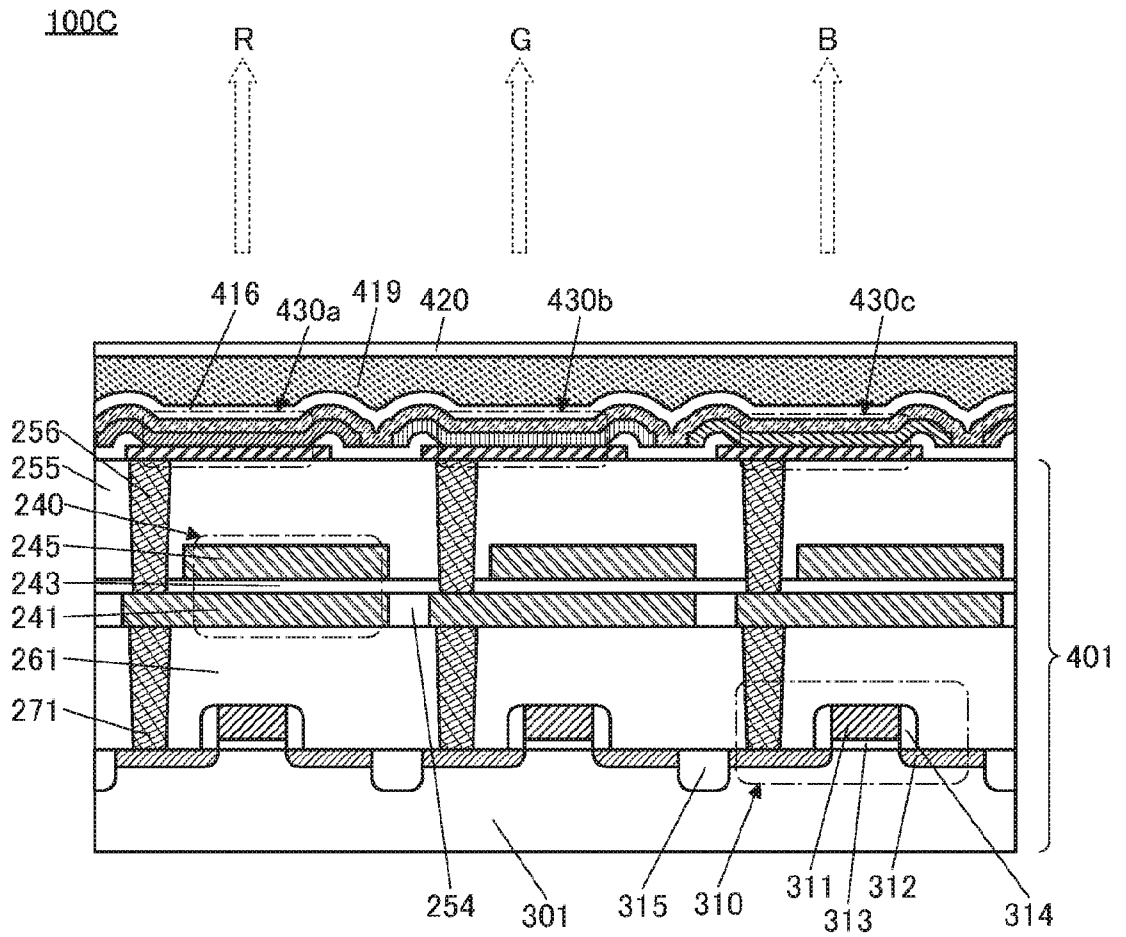


図 14

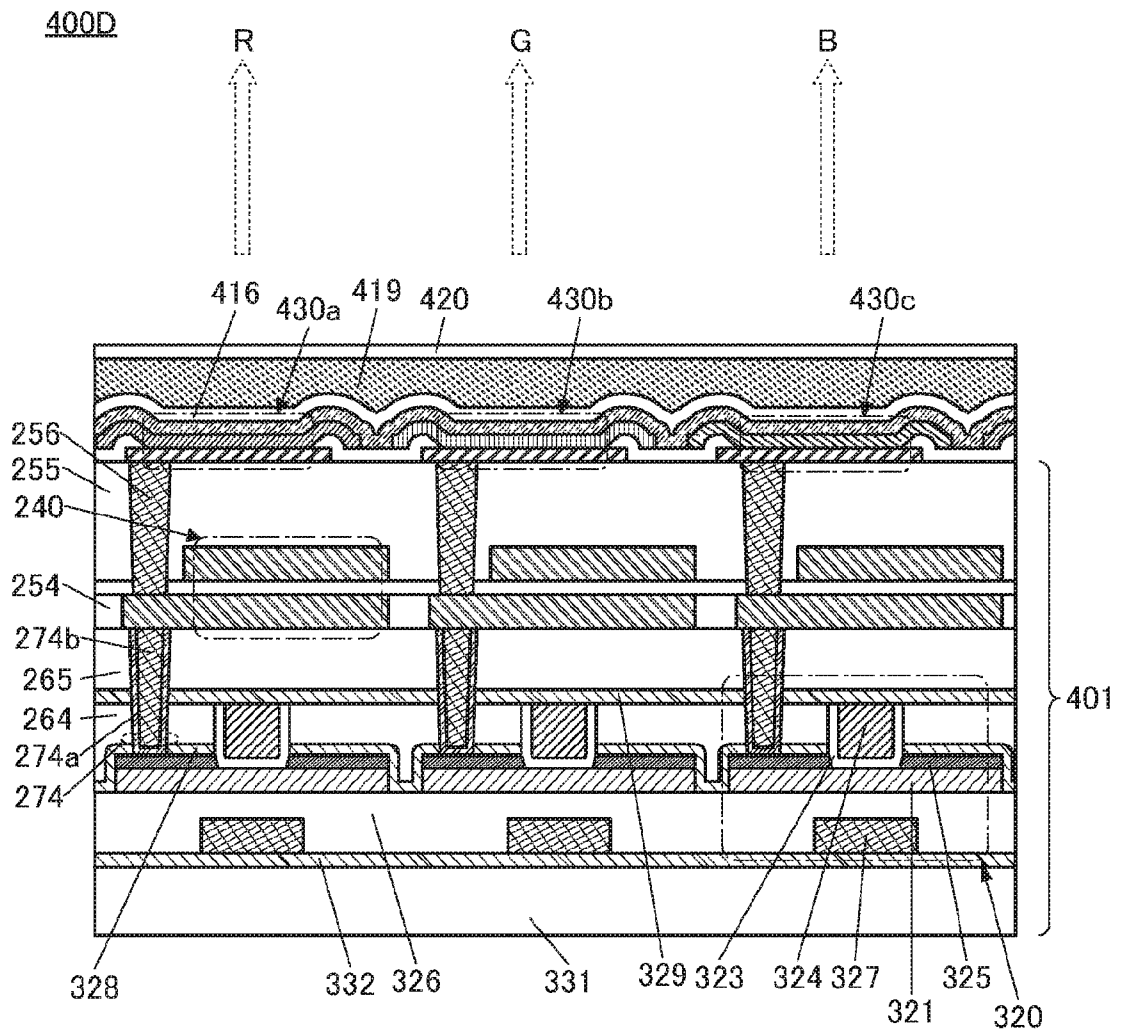
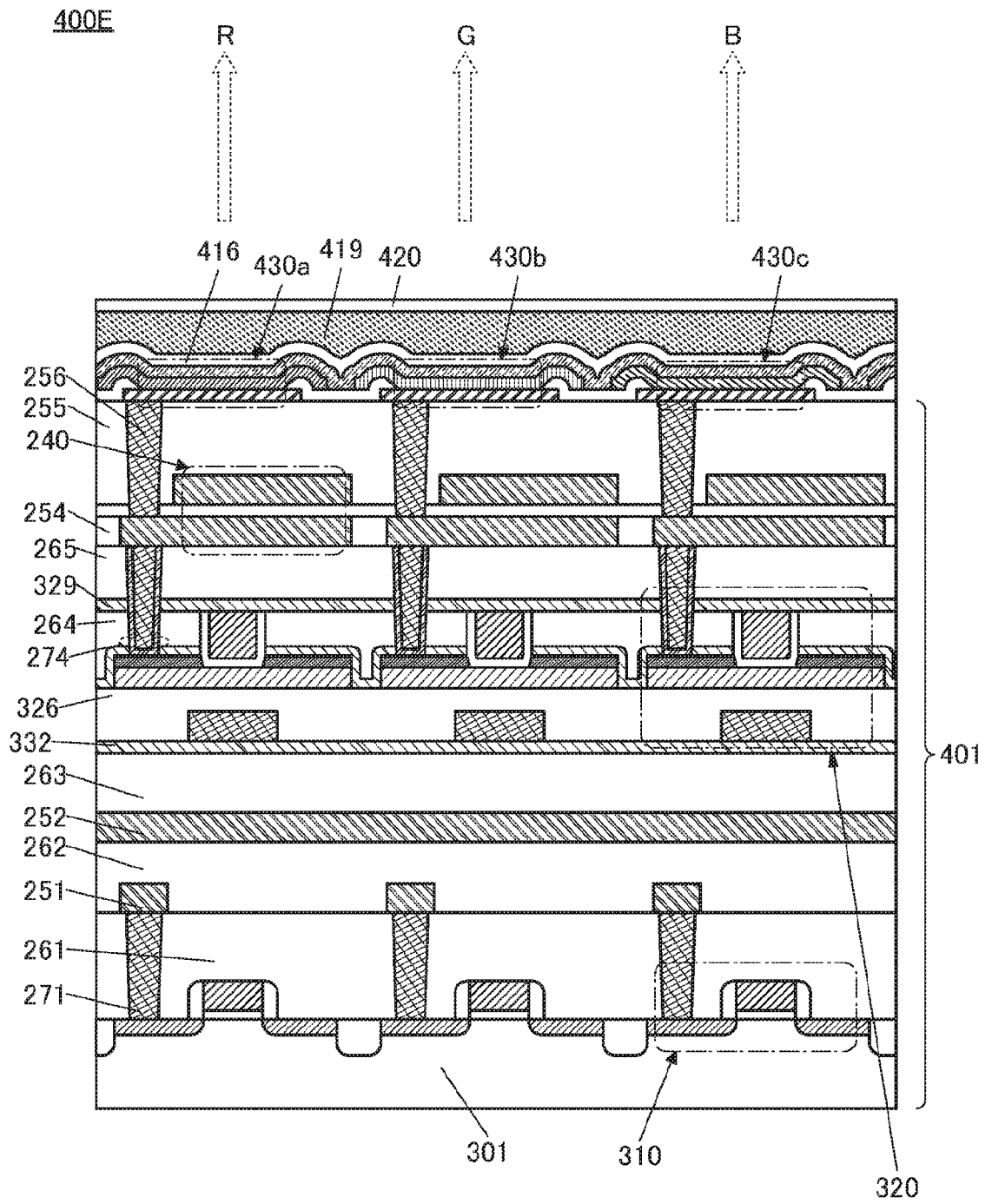
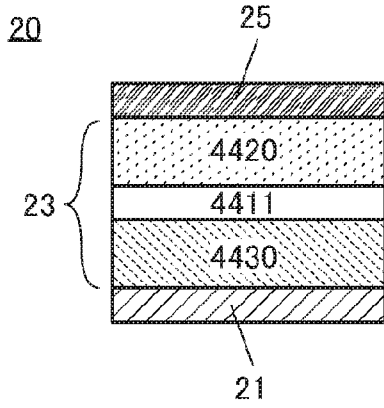


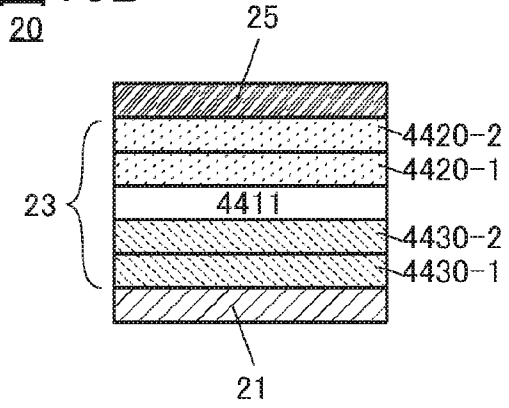
図 15



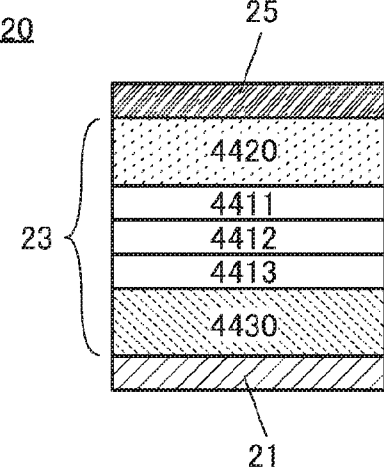
16A



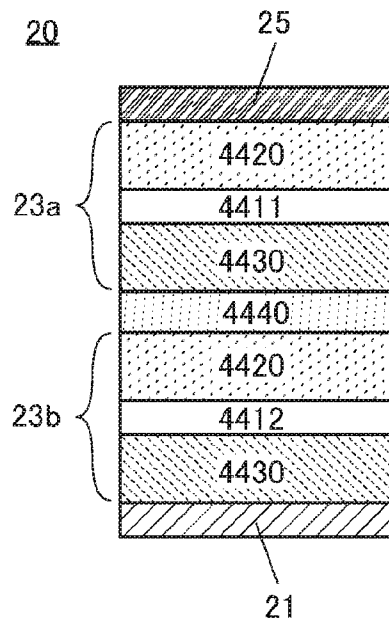
16B



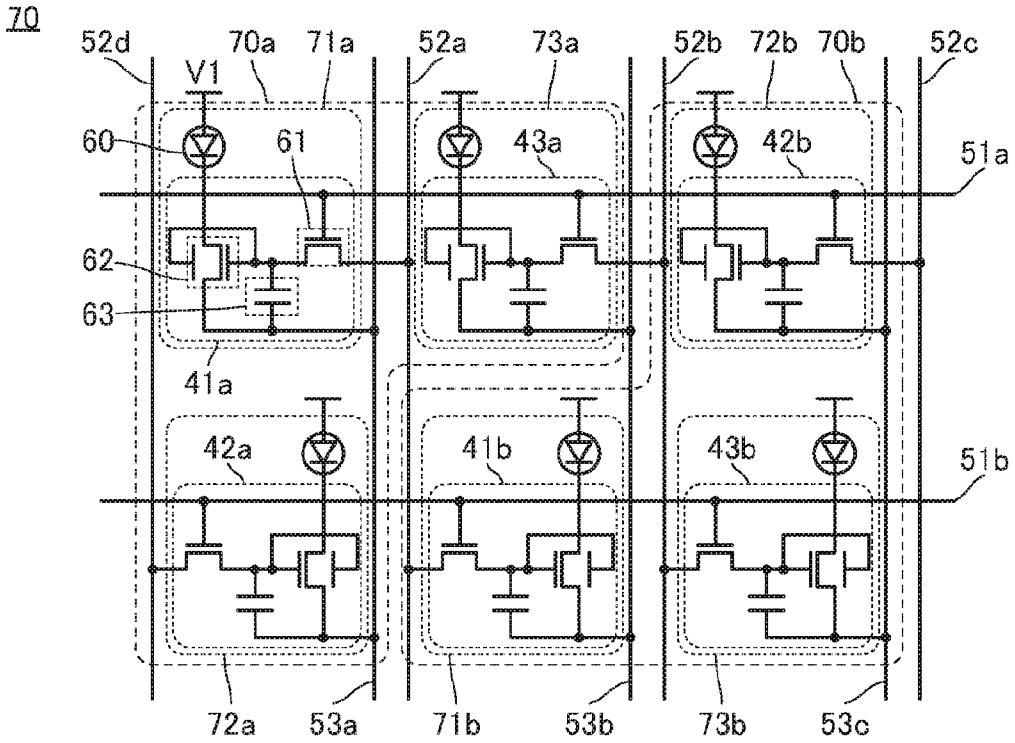
16C



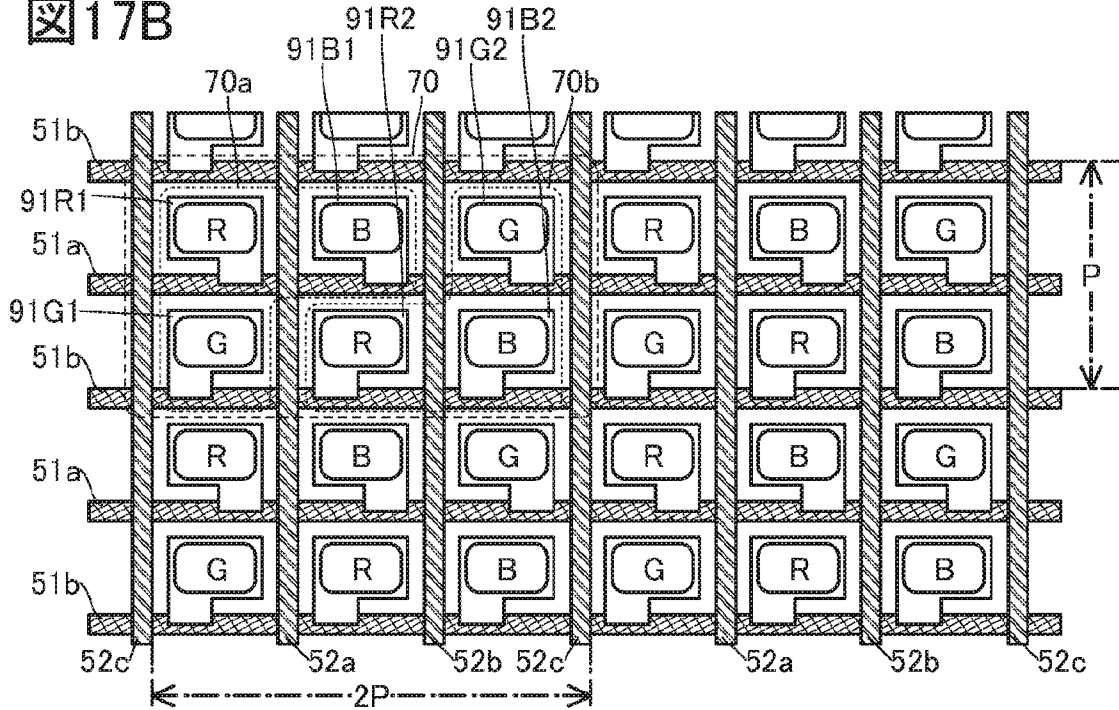
16D



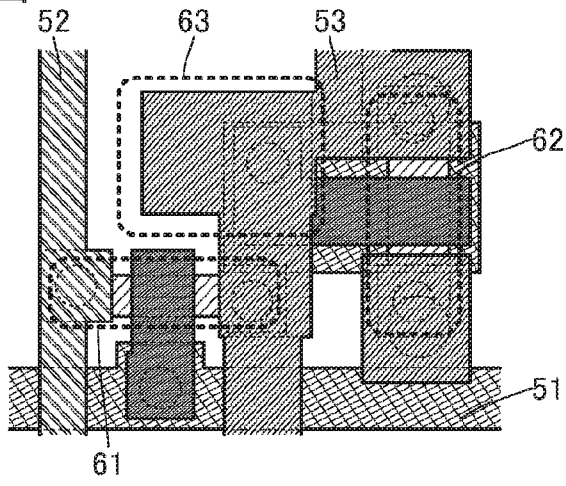
17A



17B



18A



18B

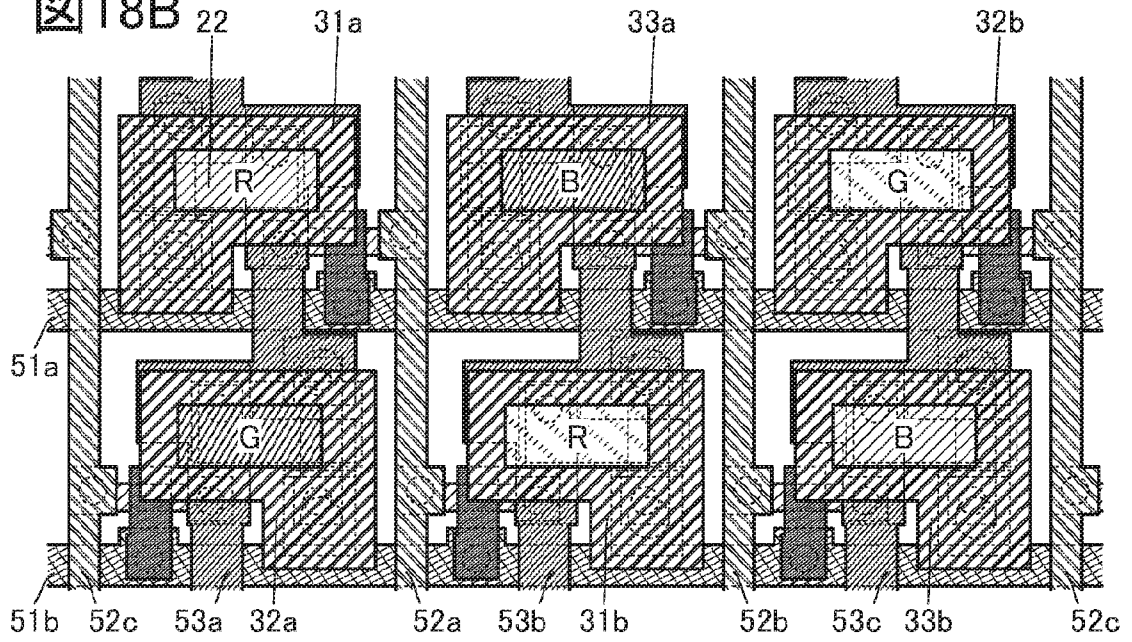


図19A

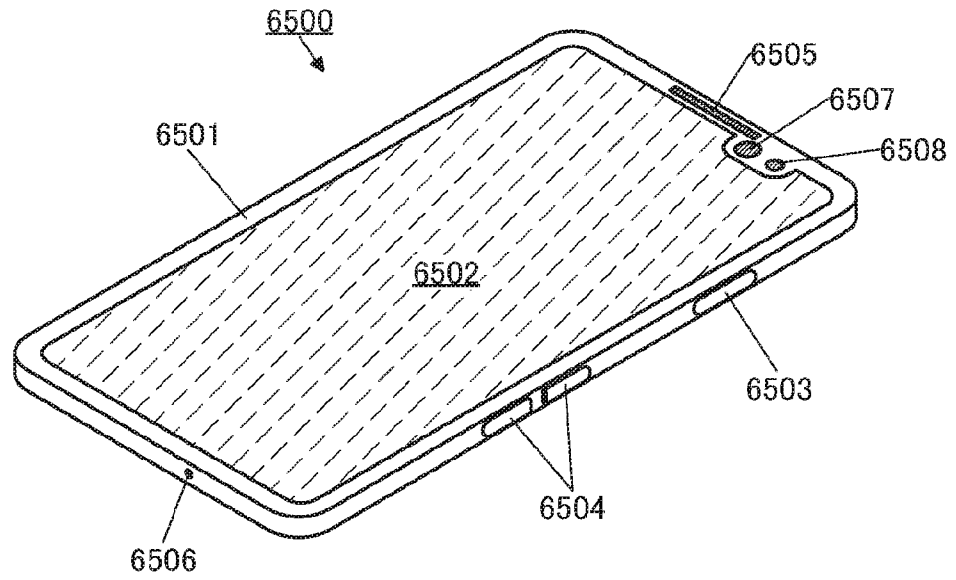
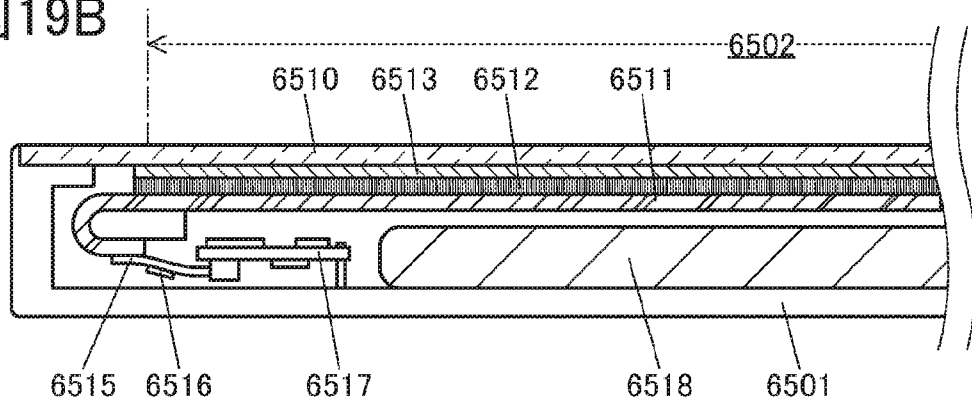
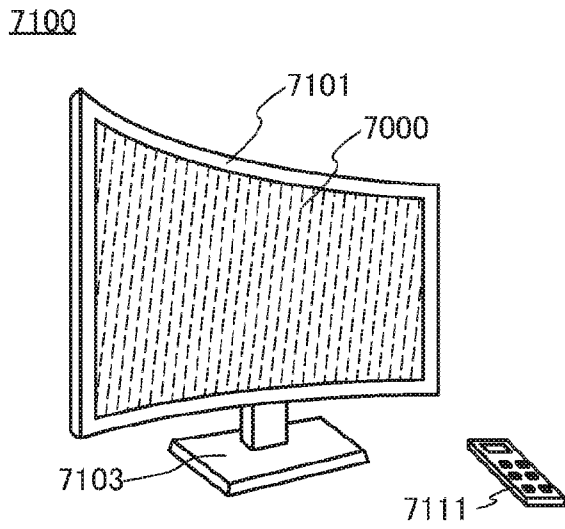


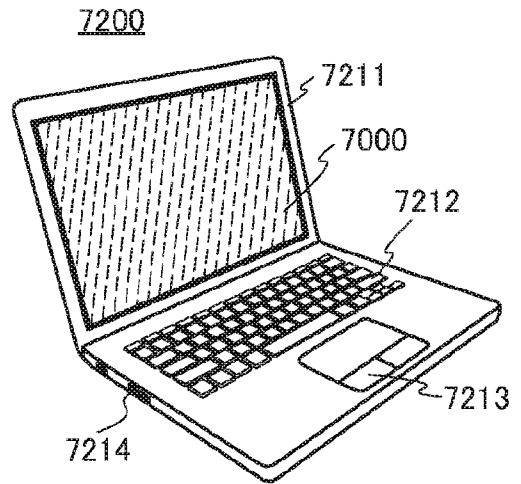
図19B



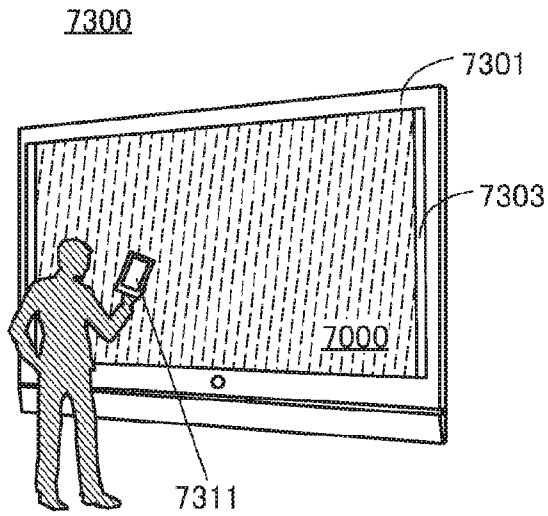
20A



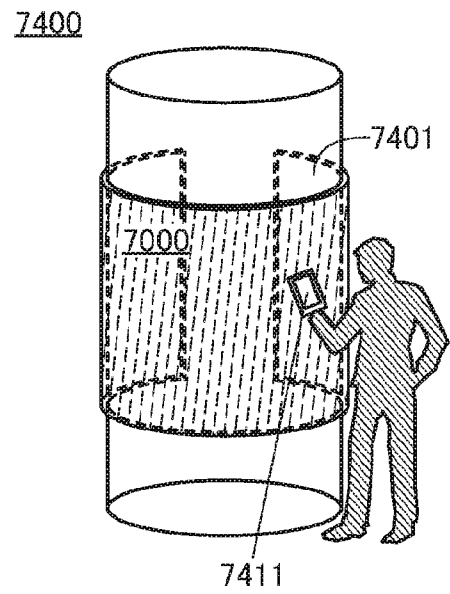
20B



20C



20D



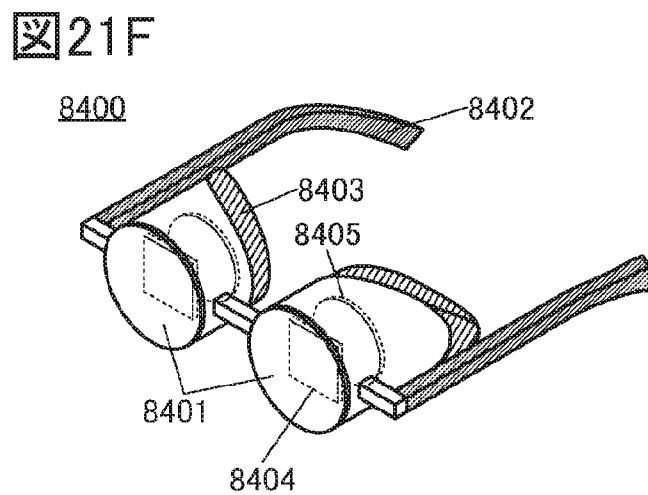
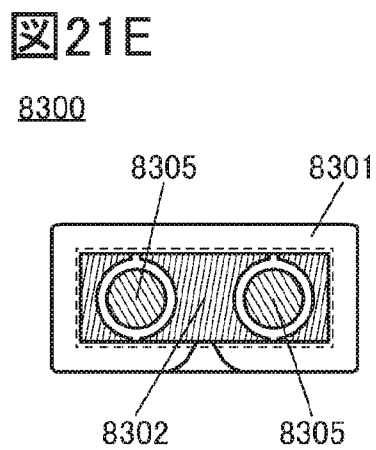
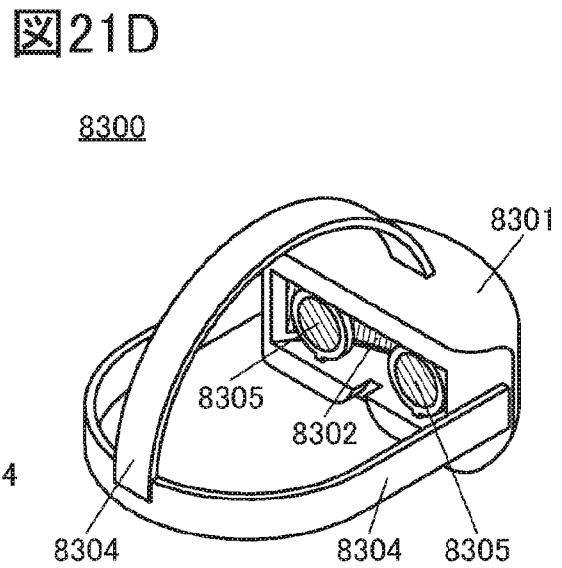
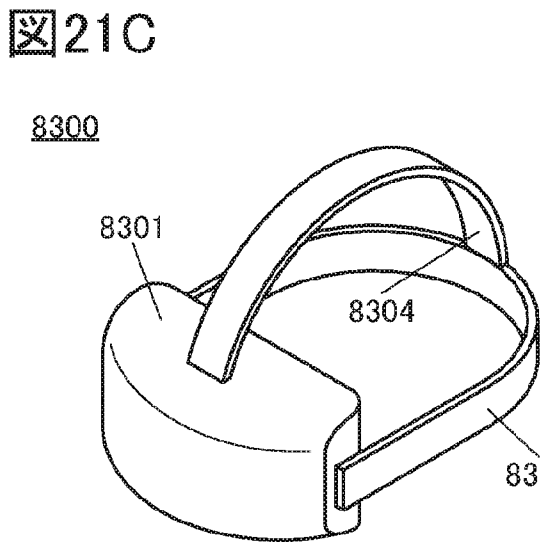
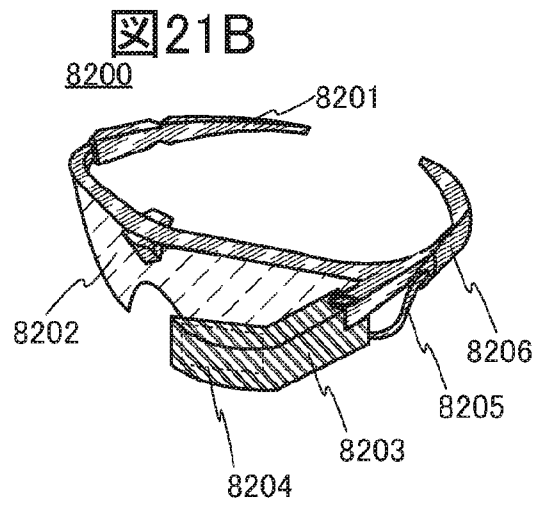
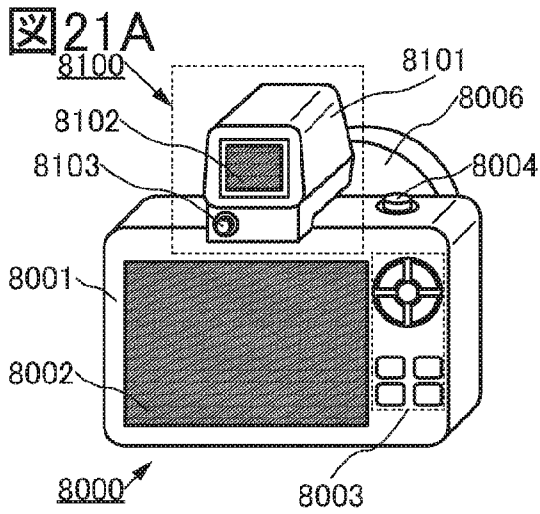


图22A

9101

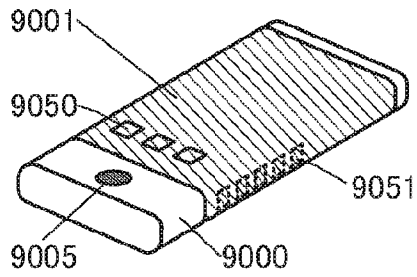


图22B

9102

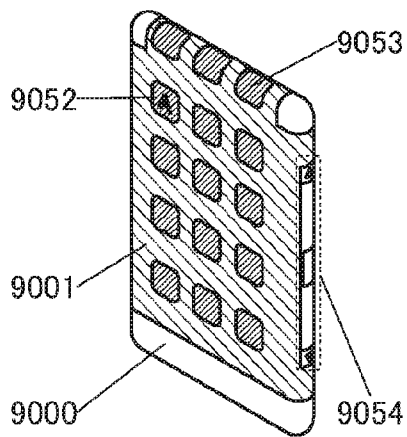


图22C

9200

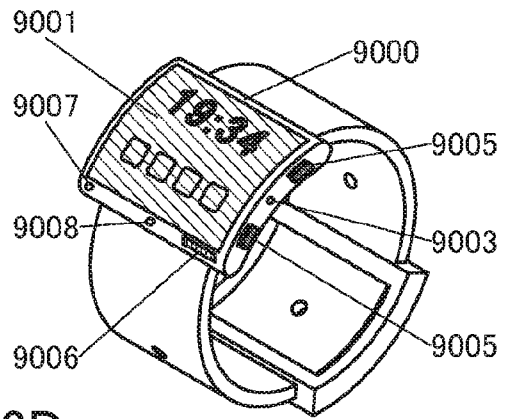


图22D

9201

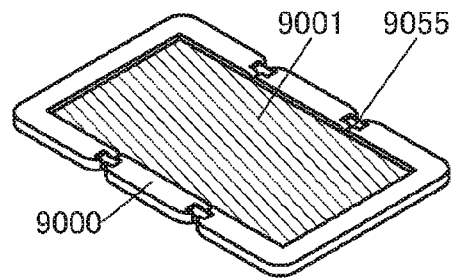


图22E

9201

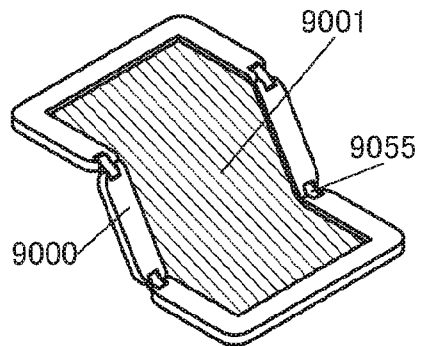


图22F

9201

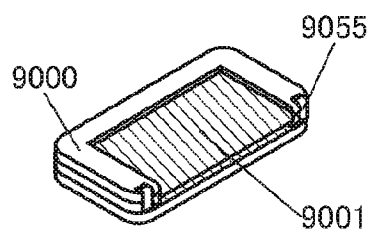


図23A

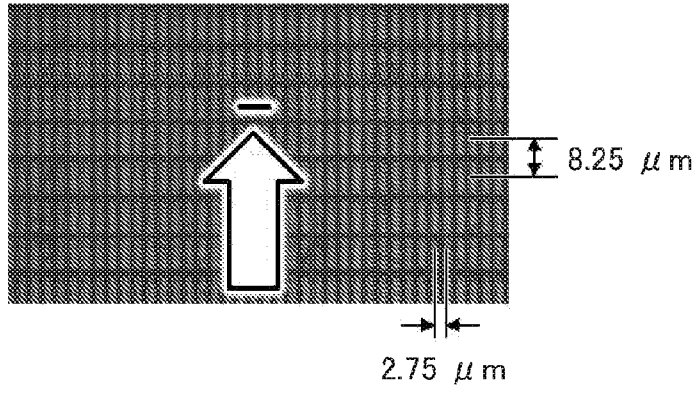
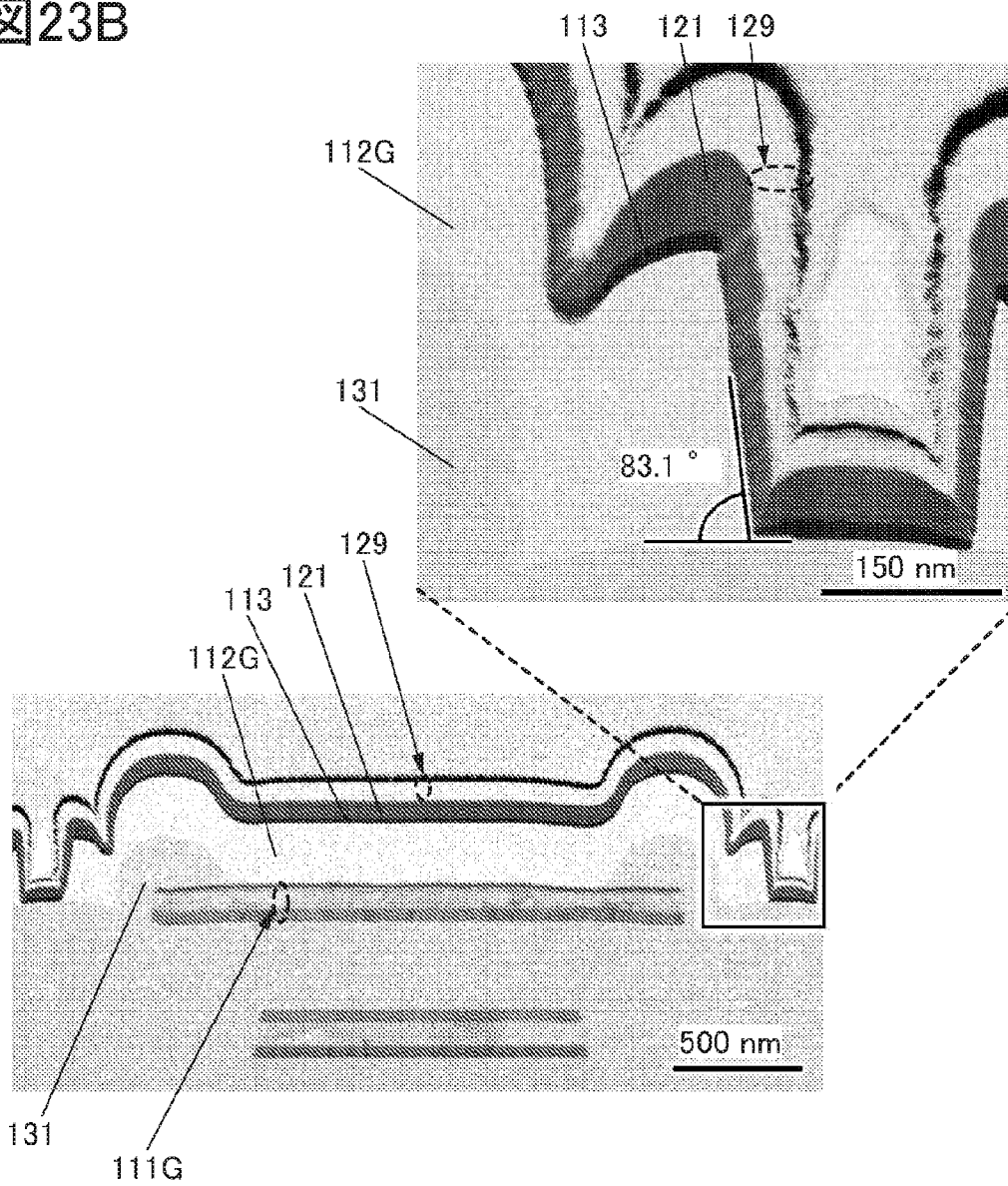
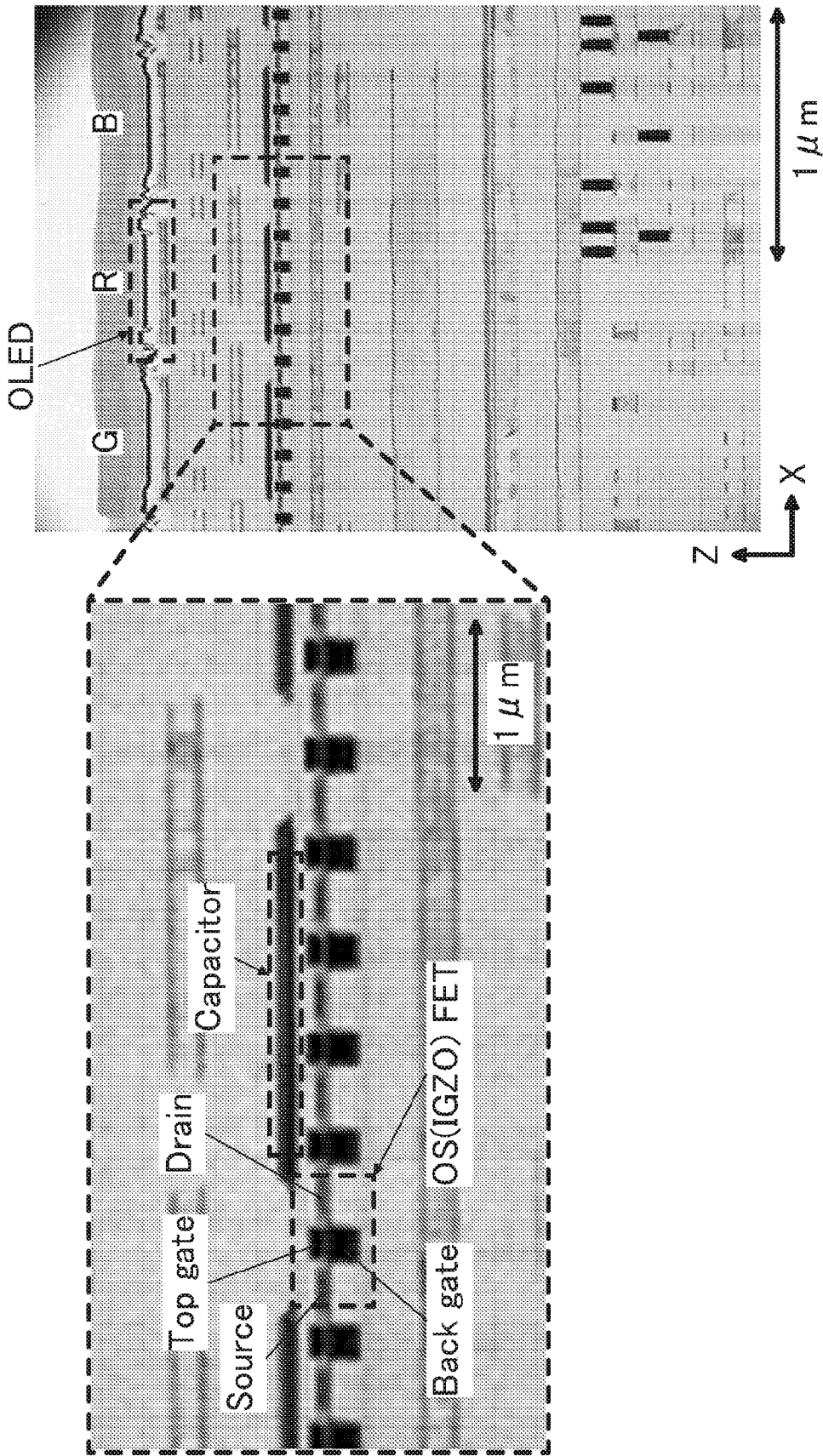


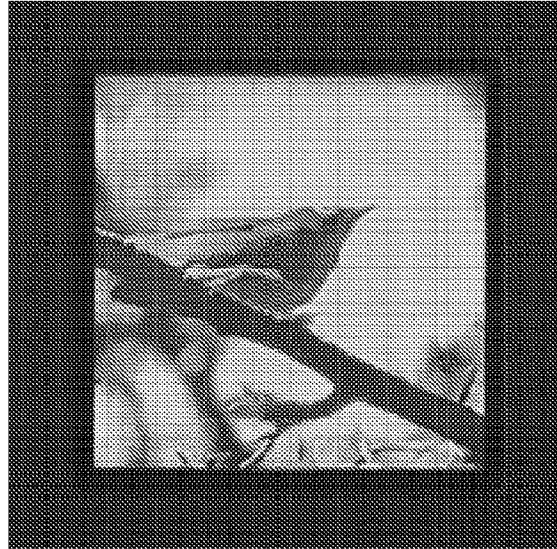
図23B



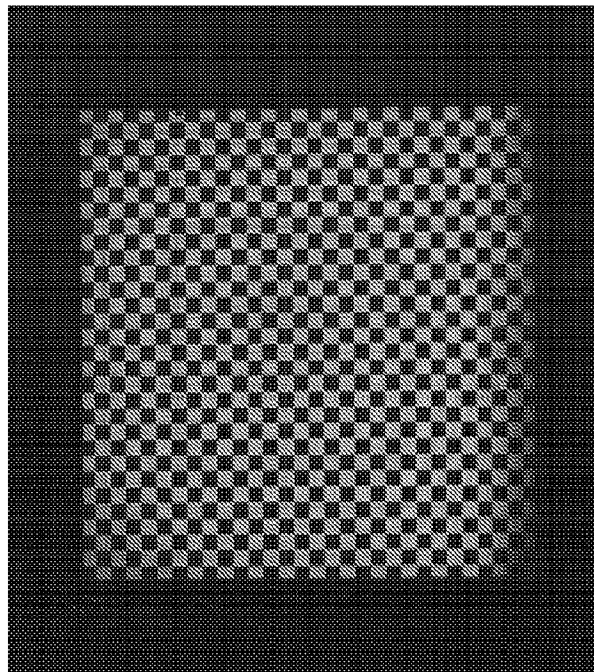
24



☒ 25A



☒ 25B



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/IB2022/050284

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
<i>G09F 9/30</i> (2006.01)i; <i>H01L 27/32</i> (2006.01)i; <i>H05B 33/12</i> (2006.01)i; <i>H01L 51/50</i> (2006.01)i; <i>H05B 33/14</i> (2006.01)i; <i>H05B 33/22</i> (2006.01)i FI: H05B33/22 Z; G09F9/30 365; H05B33/14 A; H01L27/32; H05B33/12 B; H05B33/14 Z; G09F9/30 348A; G09F9/30 339Z		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G09F9/30; H01L27/32; H05B33/12; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/22		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Published examined utility model applications of Japan 1922-1996 Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2022 Registered utility model specifications of Japan 1996-2022 Published registered utility model applications of Japan 1994-2022		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2019/038619 A1 (SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.) 28 February 2019 (2019-02-28) claims, paragraphs [0048]-[0089], fig. 1(D)	1-6
A	US 2021/0005669 A1 (SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.) 07 January 2021 (2021-01-07) entire text, all drawings	1-6
A	KR 10-2009-0021442 A (LG DISPLAY CO., LTD.) 04 March 2009 (2009-03-04) entire text, all drawings	1-6
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 04 April 2022		Date of mailing of the international search report 19 April 2022
Name and mailing address of the ISA/JP Japan Patent Office (ISA/JP) 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915 Japan		Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/IB2022/050284

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
WO	2019/038619	A1	28 February 2019	US 2021/0159461 A1 claims, paragraphs [0065]-[0106], fig. 1D CN 111033602 A KR 10-2020-0046035 A	
US	2021/0005669	A1	07 January 2021	JP 2021-12366 A entire text, all drawings CN 112186111 A KR 10-2021-0004867 A TW 202104541 A	
KR	10-2009-0021442	A	04 March 2009	(Family: none)	

<p>A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））</p> <p>G09F 9/30(2006.01)i; H01L 27/32(2006.01)i; H05B 33/12(2006.01)i; H01L 51/50(2006.01)i; H05B 33/14(2006.01)i; H05B 33/22(2006.01)i FI: H05B33/22 Z; G09F9/30 365; H05B33/14 A; H01L27/32; H05B33/12 B; H05B33/14 Z; G09F9/30 348A; G09F9/30 339Z</p>														
<p>B. 調査を行った分野</p> <p>調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））</p> <p>G09F9/30; H01L27/32; H05B33/12; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/22</p> <p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの</p> <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2022年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2022年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2022年</td> </tr> </table> <p>国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）</p>			日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2022年	日本国実用新案登録公報	1996-2022年	日本国登録実用新案公報	1994-2022年				
日本国実用新案公報	1922-1996年													
日本国公開実用新案公報	1971-2022年													
日本国実用新案登録公報	1996-2022年													
日本国登録実用新案公報	1994-2022年													
<p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求項の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>WO 2019/038619 A1 (株式会社半導体エネルギー研究所) 28.02.2019 (2019-02-28) 請求の範囲, [0048]-[0089], 図1(D)</td> <td>1-6</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>US 2021/0005669 A1 (SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.) 07.01.2021 (2021-01-07) 全文全図</td> <td>1-6</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>KR 10-2009-0021442 A (LG DISPLAY CO., LTD.) 04.03.2009 (2009-03-04) 全文全図</td> <td>1-6</td> </tr> </tbody> </table>			引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	X	WO 2019/038619 A1 (株式会社半導体エネルギー研究所) 28.02.2019 (2019-02-28) 請求の範囲, [0048]-[0089], 図1(D)	1-6	A	US 2021/0005669 A1 (SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.) 07.01.2021 (2021-01-07) 全文全図	1-6	A	KR 10-2009-0021442 A (LG DISPLAY CO., LTD.) 04.03.2009 (2009-03-04) 全文全図	1-6
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号												
X	WO 2019/038619 A1 (株式会社半導体エネルギー研究所) 28.02.2019 (2019-02-28) 請求の範囲, [0048]-[0089], 図1(D)	1-6												
A	US 2021/0005669 A1 (SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.) 07.01.2021 (2021-01-07) 全文全図	1-6												
A	KR 10-2009-0021442 A (LG DISPLAY CO., LTD.) 04.03.2009 (2009-03-04) 全文全図	1-6												
<p><input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input checked="" type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。</p>														
<table border="0"> <tr> <td>* 引用文献のカテゴリー</td> <td>“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの</td> </tr> <tr> <td>“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの</td> <td>“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの</td> </tr> <tr> <td>“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの</td> <td>“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの</td> </tr> <tr> <td>“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）</td> <td>“&” 同一パテントファミリー文献</td> </tr> <tr> <td>“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献</td> <td></td> </tr> <tr> <td>“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献</td> <td></td> </tr> </table>			* 引用文献のカテゴリー	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの	“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの	“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの	“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの	“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	“&” 同一パテントファミリー文献	“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献	
* 引用文献のカテゴリー	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの													
“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの	“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの													
“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの													
“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	“&” 同一パテントファミリー文献													
“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献														
“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献														
<p>国際調査を完了した日</p> <p>04.04.2022</p>	<p>国際調査報告の発送日</p> <p>19.04.2022</p>													
<p>名称及びあて先</p> <p>日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号</p>	<p>権限のある職員（特許庁審査官）</p> <p>岩井 好子 20 4160</p> <p>電話番号 03-3581-1101 内線 3271</p>													

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号
 PCT/IB2022/050284

引用文献			公表日	パテントファミリー文献			公表日
WO	2019/038619	A1	28.02.2019	US	2021/0159461	A1	
					請求の範囲, [0065]-[0106], 図1D		
				CN	111033602	A	
				KR	10-2020-0046035	A	
US	2021/0005669	A1	07.01.2021	JP	2021-12366	A	
					全文全図		
				CN	112186111	A	
				KR	10-2021-0004867	A	
				TW	202104541	A	
KR	10-2009-0021442	A	04.03.2009	(ファミリーなし)			